

上海市通力律师事务所

关于

华虹半导体有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

法律意见书



二〇二六年三月

目 录

一.	本次交易各方的主体资格.....	6
二.	本次交易涉及之方案、相关协议及安排.....	23
三.	本次交易涉及之授权与批准.....	34
四.	本次交易涉及之标的资产.....	39
五.	本次交易涉及的债权债务和员工安置的处理.....	58
六.	本次交易的信息披露.....	59
七.	本次交易的相关实质性条件.....	61
八.	同业竞争与关联交易.....	69
九.	本次交易涉及的证券服务机构及其资格.....	72
十.	关于上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况以及股票买卖自 查情况.....	73
十一.	结论意见.....	76
附件一:	标的公司拥有的主要知识产权.....	77
附件二:	标的公司报告期内关联交易情况.....	281

上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书

致：华虹半导体有限公司

敬启者：

上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》和中国境内有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时有效的法律、法规以及规范性文件等有关规定（以下简称“法律、法规以及规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

（引 言）

根据华虹半导体有限公司（以下简称“华虹半导体”或“上市公司”）的委托，本所指派陈军律师、夏青律师（以下合称“本所律师”）作为华虹半导体本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，就本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据本所律师对我国现行法律、法规以及规范性文件的理解出具法律意见。

本所出具的法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的且与本次交易有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表

意见，也不具备适当资格对其他国家或地区法律管辖范围内的事项发表意见。本所律师并不具备对本法律意见书中所引用的有关会计、审计、资产评估等专业文件之内容进行核查和判断的专业资格，本法律意见书对该等专业文件及其内容的引用并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证；本法律意见书提及其他国家或地区法律意见书、法律审阅报告或其内容，均系指援引、参考该等发行人可依赖的境外法律意见书、法律审阅报告或其内容。

本所已得到本次交易相关各方的确认，其提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符，提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于与出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、前述各方或其他单位出具的证明文件或相关专业报告发表法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供华虹半导体为本次交易之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为华虹半导体申请进行本次交易必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担责任。本所律师同意华虹半导体在本次交易重组报告书及其摘要中自行引用或按监管机构审核要求引用本法律意见书的部分或全部内容，但华虹半导体作上述引用时不得因引用而导致法律上的歧义和曲解。

（正 文）

为本法律意见书表述方便，在本法律意见书中，除非另有说明，以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的涵义：

1. 华虹半导体、上市公司 指华虹半导体有限公司。
2. 华虹 NEC 指上海华虹 NEC 电子有限公司。
3. 华虹集团 指上海华虹（集团）有限公司。
4. 华虹国际 指 Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司），系一家根据开曼群岛法律注册成立且合法存续的公司。
5. 张江集团 指上海张江（集团）有限公司。
6. NEC 指日本电气株式会社。
7. 香港海华 指香港海华有限公司。
8. Newport 指 Newport Fab LLC。
9. 中国日电 指日电（中国）有限公司。
10. 上海贝岭 指上海贝岭股份有限公司。
11. 上海华虹宏力 指上海华虹宏力半导体制造有限公司。
12. 上海集成电路基金 指上海集成电路产业投资基金股份有限公司。
13. 大基金二期 指国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

14. 国投先导基金 指上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）。
15. 资产出售方、交易对方 指华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。
16. 标的公司、华力微 指上海华力微电子有限公司。
17. 标的资产 指资产出售方所持华力微 97.4988%的股权。
18. 华力集 指上海华力集成电路制造有限公司。
19. 本次交易 指华虹半导体向资产出售方发行股份购买华力微 97.4988%股权并募集配套资金暨关联交易。
20. 本次发行股份购买资产 指华虹半导体向资产出售方发行股份购买华力微 97.4988%股权。
21. 本次募集配套资金 指华虹半导体向合计不超过 35 名的特定投资者发行股份募集配套资金的行为。
22. 《购买资产协议》 指华虹半导体与交易对方于 2025 年 8 月 29 日签署之《发行股份及支付现金购买资产协议》。
23. 《购买资产协议之补充协议》 指华虹半导体与交易对方于 2025 年 12 月 31 日签署之《发行股份购买资产协议之补充协议》。
24. 《减值补偿协议》 指华虹半导体与华虹集团于 2025 年 12 月 31 日签署之《减值补偿协议》。

25. 国泰海通 指国泰海通证券股份有限公司。
26. 大华会计师 指大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
27. 东洲评估 指上海东洲资产评估有限公司。
28. 《重组报告书》 指《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
29. 《审计报告》 指大华会计师于 2026 年 3 月 30 日出具的大华审字[2026]0011007164 号《审计报告》。
30. 《资产评估报告》 指东洲评估以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日对华力微股东全部权益进行评估并出具的东洲评报字【2025】第 2446 号《华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
31. 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
32. 中国证监会 指中国证券监督管理委员会。
33. 上交所 指上海证券交易所。
34. 上海市国资委 指上海市国有资产监督管理委员会。
35. 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》。
36. 《重组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》。

37. 《发行办法》 指《上市公司证券发行注册管理办法》。
38. 法律、法规以及规范性文件 指已公开颁布、生效并现行有效的中华人民共和国境内法律、行政法规、行政规章、有权监管机构的有关规定等法律、法规以及规范性文件。为本法律意见书之目的，本法律意见书所述的“法律、法规以及规范性文件”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律、法规以及规范性文件。
39. 香港联交所 指香港联合交易所有限公司。
40. 《公司条例》 指不时修订的中国香港特别行政区《公司条例》。
41. 《香港法律审阅报告》 指上市公司香港法律顾问 Herbert Smith Freehills Kramer 为上市公司本次交易事宜于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 2 月 10 日及 2026 年 3 月 26 日出具的 Hong Kong Legal Review Report。
42. 元 如无特别指明，指人民币元。

一. 本次交易各方的主体资格

(一) 资产购买方华虹半导体

1. 基本情况

经本所律师核查，根据华虹半导体提供的文件资料及《香港法律审阅报告》，华虹半导体系于 2005 年 1 月 21 日依据《公司条例》设立的

公司，于2014年10月15日于香港联交所上市，并于2023年8月7日于上交所科创板上市。

经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》，截至《香港法律审阅报告》出具之日，华虹半导体依据香港法律适当设立且有效存续。

2. 股本沿革

经本所律师核查，根据华虹半导体提供的文件资料，华虹半导体历次主要股本变动情况如下：

(1) 华虹半导体的设立及收购华虹 NEC

经本所律师核查，经国务院于2004年12月批示同意，为华虹NEC重组上市目的，华虹NEC中方股东华虹集团、张江集团、上海贝岭拟将其持有的华虹NEC股权划转到境外，并与华虹NEC外方股东合资设立拟上市公司，自行选择有利时机，到境外发行股票并在香港上市。

2005年1月21日，华虹半导体在中国香港依据《公司条例》注册，设立时公司名称为“华虹半导体有限公司（Hua Hong Semiconductor Limited）”，设立时已发行股份数为1股，每股面值为0.01美元，该等已发行股份由Harefield Limited持有。

2005年3月3日，华虹NEC相关股东、华虹半导体签订股权转让相关协议，约定华虹NEC当时全体注册于境内的股东分别将其持有的华虹NEC股权划转、转让予相关境外主体，并由华虹半导体向前述划转或转让完成后的华虹NEC全体股东发行股份购买其合计持有的华虹NEC100%股权，前述事宜的具体情况如下表所示：

单位：万美元

华虹 NEC 原股东情况			第一步：华虹 NEC 境内股东将股权划转、 转让予境外主体			第二步：华虹半导体发行股份购买华虹 NEC 全部股权		
股东名称	出资额	持股比例 (%)	划入方/受让方	出资额	持股比例 (%)	出售方	出售比例 (%)	对价股份 (股)
华虹集团	50,000	55.92	华虹国际	50,000	55.92	华虹国际 (注 1)	61.42	350,401,100 (注 2)
华虹国际	4,480	5.01	—	—	—			
张江集团 (注 1)	437	0.49	华虹国际 (注 1)	437	0.49			
中国日电	7,000	7.83	NEC	7,000	7.83	NEC	17.36	99,038,800
NEC	8,520	9.53	—	—	—			
上海贝岭	10,030	11.22	香港海华	10,030	11.22	香港海华	11.22	64,010,100
Newport	8,941	10	—	—	—	Newport	10	57,050,000
合计	89,408	100	—	89,408	100	—	100	570,500,000

注 1：经本所律师核查，根据华虹集团、华虹国际与张江集团等于 2005 年 3 月 3 日签订的境外信托契据及华虹集团、华虹国际与张江集团于 2005 年 3 月 3 日签订的股权托管及划转协议，张江集团将华虹 NEC 0.49% 股权（即“华虹 NEC 权益”）委托华虹集团代管并划转至华虹国际，并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持有的华虹 NEC 权益置换为华虹半导体 0.49% 股权（对应华虹半导体 2,795,450 股，即“华虹半导体权益”）；股权置换后，由华虹国际根据协议约定代张江集团持有及管理华虹半导体权益，并代表张江集团行使华虹半导体权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务；张江集团根据协议约定保留华虹半导体权益项下的处分权、收益权等股东权利，并承担相应义务。

注 2：其中华虹国际所持有的华虹半导体 1 股股份系自 Harefield Limited 处以 0.01 美元的价格受让取得。

经本所律师核查，国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月4日出具国资产权[2005]150号《关于对上海华虹NEC电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹NEC中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。

经本所律师核查，中华人民共和国商务部分别于2005年3月31日、2005年4月30日、2005年7月28日核发商合批[2005]178号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司向境外划转股权并在香港设立华虹半导体有限公司的批复》、商资批[2005]720号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]1540号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司转股的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，中华人民共和国国家发展和改革委员会于2005年5月8日核发发改外资[2005]730号《国家发展改革委关于上海华虹NEC电子有限公司中方股东股权全部转移境外并在香港上市项目核准的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，华虹国际、NEC、香港海华及Newport已于2005年6月1日被登记为华虹半导体股东，华虹NEC之股权已于2005年10月9日变更登记至华虹半导体名下。

上述华虹NEC收购完成后，华虹半导体的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100	61.42

		(其中 2,795,450 股系为 张江集团托管)	
2.	NEC	99,038,800	17.36
3.	香港海华	64,010,100	11.22
4.	Newport	57,050,000	10
合计		570,500,000	100

(2) 2014 年 10 月华虹半导体在香港联交所首次公开发行股票并上市

经本所律师核查，华虹半导体股东大会于2014年9月20日作出决议，同意华虹半导体公开发行股票，同时批准董事行使华虹半导体配发、发行及处置股份的一切权力(包括作出要约、订立协议、或授出将会或可能须配发及发行股份的证券的权力)。

经本所律师核查，根据华虹半导体公开披露的相关信息，华虹半导体于2014年10月以11.25港币/股的价格公开发行合计228,696,000股股份；本次发行完成后，华虹半导体已发行股份总数增至1,033,871,656股。2014年10月15日，华虹半导体在香港联交所主板挂牌上市。

(3) 2015 年 9 月第一期股票期权激励计划及授予

经本所律师核查，华虹半导体股东特别大会于2015年9月1日作出决议，同意采纳股票期权计划，并授权董事会自计划批准日7年内任何时间决定授予参与者按行权价认购一定数量华虹半导体股票的权利；该股票期权计划项下拟授出的所有期权及华虹半导体任何其他股票期权计划项下拟授出的任何期权获行使时可予发行的股票总数，合计不得超过当时的已发行股本总数的10%，

且该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过华虹半导体总股本的3%。

经本所律师核查，上海市国资委已于2015年8月14日出具沪国资委分配（2015）278号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划的批复》，原则同意上述期权激励计划。

经本所律师核查，根据华虹半导体股东大会的上述授权，华虹半导体董事会于2015年9月4日作出决议，同意于2015年9月4日向董事及雇员授出股票期权。华虹半导体本次授出30,250,000份期权，前述期权可按行权价6.912港元认购合计最多30,250,000股股票，本次期权分三期归属，并将于2022年9月3日失效。

(4) 2018年11月增资

经本所律师核查，华虹半导体于2018年1月3日与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订《认购协议》，约定国家集成电路产业投资基金股份有限公司（无论是通过其自身或是通过其指定人士）认购华虹半导体242,398,925股股份，认购价为每股12.9002港元；华虹半导体股东特别大会于2018年2月14日作出决议，同意前述股份认购事宜。国家集成电路产业投资基金股份有限公司指定的主体鑫芯（香港）投资有限公司已于2018年11月7日完成前述股份认购。

经本所律师核查，华虹集团于2017年12月15日召开一届五十三次党委会，同意鑫芯（香港）投资有限公司入股华虹半导体；大基金已于2017年12月15日召开第二十次董事会审议通过鑫芯（香港）投资有限公司入股华虹半导体事宜，并就前述事宜于2017年12月

15日出具了《国家集成电路产业投资基金重大项目核准意见表》。本次增资完成后，华虹半导体已发行股份总数增至1,283,750,891股。

(5) 2018年12月第二期股票期权计划第一次授予

经本所律师核查，华虹半导体董事会于2018年12月18日作出决议，同意于2018年12月24日及2019年12月23日向若干雇员和/或董事配发股票期权，但该等期权计划的实施须根据国资监管部门的要求以取得华虹半导体股东大会的批准为前提。华虹半导体于2018年12月24日向华虹半导体若干员工及当时的董事授出34,500,000份期权（该等期权须经华虹半导体股东大会批准后方可生效）。前述期权可按行权价15.056港元认购合计最多34,500,000股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员（连同董事）而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属；前述期权已于2025年12月23日失效。

经本所律师核查，上海市国资委于2019年3月12日出具沪国资委分配（2019）44号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划（二期）的批复》，原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划（二期）方案》，并应按有关规定提交华虹半导体股东大会审议。

经本所律师核查，华虹半导体股东特别大会于2019年3月28日作出决议，同意根据华虹半导体于2015年9月1日采纳的股票期权计划于2018年12月24日授出34,500,000份股票期权，并同意于2019年12月23日或前后进一步授出4,000,000份股票期权。

(6) 2019年3月第二期股票期权计划第二次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及华虹半导体股东大会的授权，华虹半导体董事会于2019年3月28日作出决议，同意于2019年3月29日向唐均君授出500,000份期权，前述期权可按行权价18.40港元认购合计最多500,000股股票；本次期权分四期归属，并将于2026年3月28日失效。

(7) 2019年12月第二期股票期权计划第三次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及华虹半导体股东大会的授权，华虹半导体董事会于2019年11月12日作出决议，同意于2019年12月23日向华虹半导体（无锡）有限公司具有重要技术专长及/或担任核心管理职位的101名员工授予2,482,000份期权。前述期权可按行权价17.952港元认购合计最多2,482,000股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属。前述期权将于2026年12月22日失效。

(8) 2021年11月华虹半导体股票期权计划调整

经本所律师核查，华虹半导体股东特别大会于2021年11月26日作出决议，为使华虹半导体能够更灵活地向其雇员提供激励及奖励，同意将华虹半导体股票期权计划授出限额调整为130,047,036股股票。

(9) 2023年8月华虹半导体在上交所首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2023]1228号《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，华虹半导体向社会公开发行人民币普通股40,775万股，每股发行价格52元。经上交所同意，华虹半导体境内发行股票总数为40,775万股，其中10,397.4252万股于2023年8月7日起在上交所科创板上市交易。

3. 控股股东及实际控制人

经本所律师核查，根据华虹半导体提供的股东名册并经华虹半导体确认，截至2025年12月31日，华虹国际持有华虹半导体347,605,650股境外上市外资股股份，占华虹半导体于2025年12月31日已发行股份总数的20.00%，为华虹半导体的直接控股股东；华虹集团持有华虹国际100%的股权，并直接持有华虹半导体1,198,517股A股股份，为华虹半导体的间接控股股东；截至2025年12月31日，上海市国资委直接持有华虹集团51.74%的股权，系华虹半导体的实际控制人。

基于上述核查，并根据《香港法律审阅报告》，本所律师认为，华虹半导体系依据香港法律适当设立且有效存续的公司，具备参与本次交易的主体资格。

(二) 资产出售方

1. 华虹集团

经本所律师核查，根据华虹集团的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn>)的查询，截至2025年12月31日，华虹集团的基本情况如下：

企业名称	上海华虹（集团）有限公司
统一社会信用代码	91310000132263312B
法定代表人	秦健
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号
注册资本	1,352,148.449311 万元
成立日期	1996 年 4 月 9 日
营业期限	1996 年 4 月 9 日至 2046 年 4 月 8 日
企业类型	有限责任公司
经营范围	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师核查，根据华虹集团提供的章程等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，华虹集团的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1.	上海市国资委	699,642.264137	51.74%
2.	上海国际集团有限公司	206,680.669833	15.29%
3.	上海国盛（集团）有限公司	206,680.669833	15.29%
4.	上海仪电（集团）有限公司	131,556.483529	9.73%
5.	上海临港经济发展（集团）有限公司	107,588.361979	7.96%

合计	1,352,148.449311	100.00% (注)
----	------------------	----------------

注：合计数与各部分数直接相加之和如存在尾数差异，系由四舍五入原因造成，下同。

2. 上海集成电路基金

经本所律师核查，根据上海集成电路基金的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，上海集成电路基金的基本情况如下：

企业名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL3AW02
法定代表人	李鑫
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 A 单元
注册资本	2,480,000 万元
成立日期	2016 年 12 月 7 日
营业期限	2016 年 12 月 7 日至 2029 年 3 月 31 日
企业类型	股份有限公司
经营范围	股权投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师核查，根据上海集成电路基金提供的章程等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，上海集成电路基金的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1.	上海科技创业投资（集团） 有限公司	761,403.34	30.70%
2.	中国人寿资产管理有限公司 （代表“中国人寿-沪发1 号股权投资计划”）	750,526.16	30.26%
3.	国家集成电路产业投资基金 股份有限公司	261,052.69	10.53%
4.	上海浦东新兴产业投资有限 公司	174,035.25	7.02%
5.	上海国际信托有限公司	156,631.54	6.32%
6.	中保投智集芯（嘉兴）股权 投资合伙企业（有限合伙）	131,544.95	5.30%
7.	中保投齐芯（嘉兴）集成电 路产业投资有限责任公司	104,421.15	4.21%
8.	中国中信金融资产管理股份 有限公司	96,876.20	3.91%
9.	上海嘉定创业投资管理有限 公司	43,508.72	1.75%
合计		2,480,000	100.00%

经本所律师核查，上海集成电路基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为SEJ523。上海集成电路基金的基金管理人上海集成电路产业投资基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为P1068675。

3. 大基金二期

经本所律师核查，根据大基金二期的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）的查询，截至2025年12月31日，大基金二期的基本情况如下：

企业名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F
法定代表人	张新
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
注册资本	20,415,000 万元
成立日期	2019年10月22日
营业期限	2019年10月22日至2029年10月21日
企业类型	股份有限公司
经营范围	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经本所律师核查，根据大基金二期提供的章程等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）的查询，

截至 2025 年 12 月 31 日，大基金二期的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1.	中华人民共和国财政部	2,250,000	11.02%
2.	国开金融有限责任公司	2,200,000	10.78%
3.	浙江富浙集成电路产业发展 有限公司	1,500,000	7.35%
4.	武汉光谷金融控股集团有限 公司	1,500,000	7.35%
5.	成都天府国集投资有限公司	1,500,000	7.35%
6.	中国烟草总公司	1,500,000	7.35%
7.	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000	7.35%
8.	重庆战略性新兴产业股权 投资基金合伙企业（有限 合伙）	1,400,000	6.86%
9.	北京亦庄国际投资发展有限 公司	1,000,000	4.90%
10.	中移资本控股有限责任公司	1,000,000	4.90%
11.	北京国谊医院有限公司	1,000,000	4.90%
12.	江苏惠泉集成电路产业投资 有限公司	1,000,000	4.90%
13.	安徽省芯火集成电路产业投 资合伙企业（有限合伙）	750,000	3.67%
14.	安徽皖投安华现代产业投资 合伙企业（有限合伙）	750,000	3.67%
15.	福建省国资集成电路投资有 限公司	300,000	1.47%

16.	深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	300,000	1.47%
17.	广州产业投资基金管理有限公司	300,000	1.47%
18.	黄埔投资控股（广州）有限公司	200,000	0.98%
19.	中国电信集团有限公司	150,000	0.73%
20.	联通资本投资控股有限公司	100,000	0.49%
21.	广西投资引导基金有限责任公司	100,000	0.49%
22.	中电金投控股有限公司	50,000	0.24%
23.	华芯投资管理有限责任公司	15,000	0.07%
24.	福建三安集团有限公司	10,000	0.05%
25.	协鑫资本管理有限公司	10,000	0.05%
26.	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000	0.05%
27.	北京建广资产管理有限公司	10,000	0.05%
28.	上海矽启企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000	0.05%
合计		20,415,000	100.00%

经本所律师核查，大基金二期系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SJU890。大基金二期的基金管理人华芯投资管理有限责任公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1009674。

4. 国投先导基金

经本所律师核查，根据国投先导基金的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>) 的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，国投先导基金的基本情况如下：

企业名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MADTAPYB6E
执行事务合伙人	上海国投先导私募基金管理有限公司
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区中科路 1699 号 28 层 02 单元
认缴出资额	4,500,100 万元
成立日期	2024 年 7 月 22 日
营业期限	2024 年 7 月 22 日至无固定期限
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经本所律师核查，根据国投先导基金提供的合伙协议等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>) 的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，国投先导基金的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
----	-------	-------	---------------	------

1.	上海国投先导私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.0022%
2.	上海国经投资发展有限公司	有限合伙人	2,000,000	44.44%
3.	上海浦东创新发展(集团)有限公司	有限合伙人	1,000,000	22.22%
4.	上海国有资本投资有限公司	有限合伙人	600,000	13.33%
5.	上海汽车工业(集团)有限公司	有限合伙人	250,000	5.56%
6.	上海国际集团有限公司	有限合伙人	250,000	5.56%
7.	上海国盛(集团)有限公司	有限合伙人	200,000	4.44%
8.	海通创新证券投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
9.	国泰君安证裕投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
10.	上海申能诚毅股权投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
11.	上海国际信托有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
合计			4,500,100	100.00%

经本所律师核查，国投先导基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为SAMQ44。

国投先导基金的基金管理人上海国投先导私募基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1074817。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，上述四名资产出售方均有效存续，具备参与本次交易的主体资格。

二. 本次交易涉及之方案、相关协议及安排

(一) 本次交易方案概述

经本所律师核查，根据华虹半导体 2025 年第六次董事会决议、2025 年第九次董事会决议、2026 年第一次临时股东大会决议、2026 年第三次董事会决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《减值补偿协议》及《重组报告书》，本次交易系华虹半导体通过发行股份的方式购买华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金合计持有的华力微 97.4988% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。根据东洲评估出具的《资产评估报告》，标的公司股东全部权益评估价值为 848,000 万元，华虹半导体与交易对方在此基础上协商确定标的资产的交易价格为 826,790.215326 万元。本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。本次交易的具体内容如下：

1. 发行股份购买资产

华虹半导体拟通过发行股份的方式购买华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名交易对方持有的华力微 97.4988% 股权。本次交易拟购买资产华力微 97.4988% 股权的交易价格为

826,790.215326 万元。本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司。

(1) 交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。

(2) 标的资产的交易对价和支付方式

本次交易中，上市公司聘请东洲评估以2025年8月31日为评估基准日对标的资产进行了评估。根据东洲评估出具的《资产评估报告》，华力微全部权益的评估值为848,000万元。基于前述评估值并经交易各方充分协商，标的资产交易对价为826,790.215326万元，各交易对方的交易对价如下表所示：

交易对方	出售华力微股权比例	交易对价（万元）
华虹集团	63.5443%	538,855.119569
上海集成电路基金	15.7215%	133,318.646521
大基金二期	10.2503%	86,922.766501
国投先导基金	7.9827%	67,693.682735
合计	97.4988%	826,790.215326

本次交易的交易对价由上市公司通过发行股份方式进行支付，不足一股的部分由上市公司以现金补足。如经有权国资监管机构备案的评估结果与上述华力微股东全部权益评估结果不一致的，各方将经内部有权机构批准后基于经备案的评估结果重新确定本

次交易的交易对价，并就此另行签署补充协议。

(3) 发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产中所发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），该等股票无面值，上市地点为上海证券交易所。

(4) 发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。

(5) 发行股份的定价方式和价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为华虹半导体审议本次交易的首次董事会决议公告之日。根据《重组办法》相关规定，华虹半导体发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日华虹半导体股票交易均价=决议公告日前若干个交易日华虹半导体股票交易总额/决议公告日前若干个交易日华虹半导体股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次发行股份的发行价格为43.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日华虹半导体股票均价的80%，符合《重组办法》的相关规定。

在定价基准日至发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中

中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

(6) 发行数量

上市公司本次发行股份的数量将根据交易对价和发行价格确定，具体计算方式为：向各发行对象发行股份数量=向各发行对象购买标的资产对应的交易对价/发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。依据该公式计算的发行股份数量精确至股，不足一股的部分由上市公司以现金补足。

根据标的资产的交易总对价及股份对价情况，本次发行股份的数量为190,768,392股，各交易对方在本次交易中分别获得上市公司本次发行股份的数量如下：

交易对方	股份对价（万元）	获得股份的数量（股）
华虹集团	538,855.119569	124,332,053
上海集成电路基金	133,318.646521	30,761,109
大基金二期	86,922.766501	20,056,014
国投先导基金	67,693.682735	15,619,216
合计	826,790.215326	190,768,392

本次发行股份购买资产中的最终股份发行数量应以经上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量也

随之进行调整。

(7) 锁定期安排

交易对方因本次发行股份购买资产取得的华虹半导体股份的锁定期安排分别如下：

- A. 华虹集团本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。本次交易完成后 6 个月内如华虹半导体股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则华虹集团通过本次交易取得的前述华虹半导体股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。
- B. 上海集成电路基金本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如果上海集成电路基金符合《重组办法》第四十七条第三款第（一）项规定，则其本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得进行转让。
- C. 大基金二期、国投先导基金本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让；如其取得前述华虹半导体股份时，对于用于认购华虹半导体股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的华虹半导体股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。

股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份及因华虹半导体送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。

若上述限售期安排与届时有效的法律、法规、部门规章及规范性文件的规定不相符或与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关规定或监管意见相应调整。

(8) 减值补偿安排

根据《资产评估报告》，本次交易标的公司华力微系采用市场法确定最终评估价值，上市公司将与减值补偿主体华虹集团签署《减值补偿协议》，就本次交易涉及的减值测试资产、减值测试期间及补偿方法、减值补偿的执行等事宜进行约定。

(9) 过渡期损益安排

本次交易以市场法作为主要评估方法，未以基于未来收益预期的估值方法作为主要评估方法，本次交易过渡期（自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止）期间，标的资产的盈利、亏损由上市公司享有或承担。

(10) 滚存未分配利润安排

华虹半导体在本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份购买资产完成后华虹半导体的新老股东共同享有。

2. 募集配套资金

本次交易中，华虹半导体拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 755,628.60 万元。

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金中所发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），该等股票无面值，上市地点为上交所。

(2) 发行方式及发行对象

本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行，发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名（含35名）的特定投资者。

最终发行对象将由华虹半导体股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会注册同意文件后，与本次交易的主承销商根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

(3) 发行股份的定价方式和价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日华虹半导体股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及

董事会授权人士根据股东大会的授权与本次交易的主承销商根据竞价结果协商确定。

在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

(4) 发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过755,628.60万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金项下发行股份数量=募集配套资金总额÷发行价格，且不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。按照前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行规模及发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照《发行办法》等的相关规定最终确定。

在本次募集配套资金定价基准日至发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

(5) 股份锁定期

本次募集配套资金的认购方所认购的华虹半导体股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于华虹半导体送股、转增股本等原因增持的华虹半导体股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

(6) 募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于华力微技术升级改造项目、特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用，其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。具体用途如下：

项目名称	拟投入募集资金金额 (万元)	占募集配套 资金比例
华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
合计	755,628.60	100.00%

如果本次募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前，华虹半导体若根据实际情况自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

(7) 滚存未分配利润安排

华虹半导体在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后华虹半导体的新老股东共同享有。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易方案符合法律、法规以及规范性文件的规定，方案内容不存在侵害华虹半导体及其股东合法利益的情形。

（二）本次交易涉及之相关协议

1. 《购买资产协议》及其补充协议

经本所律师核查，华虹半导体与华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方于 2025 年 8 月 29 日签署了附生效条件的《购买资产协议》，对本次发行股份购买资产事项进行了具体约定，主要包括标的资产内容、发行方式及发行股票的种类和面值、发行价格、锁定期、协议生效、资产交割、保证及承诺、违约责任、税费分担、协议的终止及解除、通知、保密、不可抗力、法律适用及争议解决、其它等条款。

经本所律师核查，华虹半导体与华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方于 2025 年 12 月 31 日签署了附生效条件的《购买资产协议之补充协议》，就标的资产的交易对价及对价支付、过渡期损益安排予以约定。

2. 《减值补偿协议》

经本所律师核查，华虹半导体与华虹集团于 2025 年 12 月 31 日签署了附生效条件的《减值补偿协议》，对华虹半导体拟通过发行股份的方

式购买标的资产有关减值测试及减值补偿事项进行了具体约定，主要包括减值测试资产、减值测试期间及补偿方法、减值补偿的执行、法律适用及争议解决、违约责任、协议的生效、变更及终止、其它等条款。

经本所律师对前述协议条款和条件的核查，该等协议不存在违反法律以及行政法规强制性规定的情形，待其各自约定之生效条件获得满足后即成为对协议当事人具有约束力的法律文件。

(三) 本次交易不构成重大资产重组

经本所律师核查，根据本次交易作价情况、《审计报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70013197_B01 号《审计报告》，并依据《重组办法》第十二条的规定，根据华力微 2025 年度经审计的财务数据与华虹半导体 2025 年度经审计的财务数据，标的公司相关财务指标占比计算结果如下：

项目	资产总额与交易金额孰高 (万元)	资产净额与交易金额孰高 (万元)	营业收入 (万元)
标的公司	826,790.22	826,790.22	510,114.63
华虹半导体财务指标	10,012,329.13	4,516,029.04	1,729,145.07
财务指标占比	8.26%	18.31%	29.50%

根据上述测算，标的公司相关财务指标占华虹半导体同期经审计的合并财务报告对应财务指标的比例均未达到 50%以上。据此，本所律师认为，本次交易不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组。

(四) 本次交易不构成重组上市

经本所律师核查，并根据华虹半导体的确认，本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委。据此，本所律师认为，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。

三. 本次交易涉及之授权与批准

(一) 本次交易已取得的批准与授权

1. 华虹半导体为本次交易召开之董事会

经本所律师核查，华虹半导体 2025 年第六次董事会于 2025 年 8 月 29 日作出决议，同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈华虹半导体集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第 11.2 条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议

案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》等与本次交易相关的议案。华虹半导体独立董事已对本次交易相关事宜发表独立意见。

经本所律师核查，华虹半导体 2025 年第九次董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》《关于签署附生效条件的〈减值补偿协议〉的议案》《关于本次交易构成关联（连）交易的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第 11.2 条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何

上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》《关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案》《关于提请股东大会批准特别交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于提请召开股东大会的议案》等与本次交易相关的议案。华虹半导体独立董事已对本次交易相关事宜发表独立意见。

经本所律师核查，华虹半导体 2026 年第三次董事会于 2026 年 3 月 30 日作出决议，同意《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。华虹半导体独立董事已对本次交易相关事宜发表独立意见。

2. 华虹半导体为本次交易召开之股东大会

经本所律师核查，华虹半导体于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》《关于签署附生效条件的〈减值补偿协议〉的议案》《关于本次交易构成关联（连）交易的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第 11.2 条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》《关于提请提请股东大会批准特别交易的议案》《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案》等与本次交易相关的议案。

3. 经本所律师核查，根据交易对方提供的文件资料，本次交易的交易对方已取得其内部有权决策机构现阶段应当履行的关于参与本次交易的批准和授权。
4. 经本所律师核查，上海市国资委已于 2026 年 1 月 12 日出具了《上海市国有资产评估项目备案表》，对本次交易中标的公司华力微的评估值予以备案。
5. 经本所律师核查，上海市国资委已于 2026 年 2 月 7 日出具沪国资委产权[2026]31 号《市国资委关于华虹半导体有限公司资产重组有关事项的批复》，原则同意本次交易方案。
6. 经本所律师核查，并根据《香港法律审阅报告》，本次交易已获得香港证券及期货事务监察委员会就本次交易向华虹集团授出的清洗豁免及就特别交易事宜给予的同意。

（二）本次交易尚须取得的批准与授权

经本所律师核查，并根据《香港法律审阅报告》，截至本法律意见书出具之日，本次交易尚需取得的批准与授权如下：

1. 就本次交易取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册；
2. 相关法律法规所要求的其他必要的批准、核准、备案或许可（如适用）。

(三) 基于上述核查，并根据《香港法律审阅报告》，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除尚须取得的上述批准与授权外，本次交易已依其进行阶段取得了法律、法规以及规范性文件所要求的相关批准及授权。

四. 本次交易涉及之标的资产

经本所律师核查，本次交易的标的资产为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金合计持有的华力微 97.4988% 股权，其具体情况如下：

(一) 华力微的基本情况

经本所律师核查，根据上海市市场监督管理局核发之《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>) 的查询，华力微的基本情况如下：

企业名称	上海华力微电子有限公司
统一社会信用代码	913100005500570876
法定代表人	秦健
住所	中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号
注册资本	203,619.2198 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 1 月 18 日
经营范围	开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师核查，根据华力微提供之公司章程、本所律师于国家企业信用

信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>) 的查询并经华力微确认, 华力微的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	华虹集团	129,388.277164	129,388.277164	63.5443
2.	上海集成电路 基金	32,012.074045	32,012.074045	15.7215
3.	大基金二期	20,871.634314	20,871.634314	10.2503
4.	国投先导基金	16,254.404321	16,254.404321	7.9827
5.	上海华虹宏力	5,092.829962	5,092.829962	2.5012
	合计	203,619.219806	203,619.219806	100.0000

(二) 华力微的设立及股本沿革

1. 2010年1月设立

华力微系由上海联和投资有限公司、华虹集团、华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司共同出资于 2010 年 1 月 18 日设立, 设立时的注册资本为 660,000 万元, 其中, 上海联和投资有限公司出资 450,000 万元, 持有华力微 68.1817% 的股权; 华虹集团出资 70,000 万元, 持有华力微 10.6061% 的股权; 华虹 NEC 出资 70,000 万元, 持有华力微 10.6061% 的股权; 上海宏力半导体制造有限公司出资 70,000 万元, 持有华力微 10.6061% 的股权。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 13 日出具的中瑞岳华沪验字[2010]第 004 号《验资报告》, 截至 2010 年 1 月 13 日, 华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的首期注册资本

200,000 万元。

2010 年 1 月 18 日，华力微取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

华力微设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2.	华虹集团	70,000	0	10.61
3.	华虹 NEC	70,000	0	10.61
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	0	10.61
合计		660,000	200,000	100.00

2. 2010 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 15 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1010 号《验资报告》，截至 2010 年 4 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第二期注册资本 35,000 万元。

2010 年 4 月 29 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2.	华虹集团	70,000	0	10.61
3.	华虹 NEC	70,000	0	10.61
4.	上海宏力半导体 制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		660,000	235,000	100.00

3. 2010年10月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于2010年10月8日出具的沪立信佳诚验字(2010)第1035号《验资报告》，截至2010年9月30日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第三期注册资本100,000万元。

2010年10月13日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000098113的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	450,000	300,000	68.18

2.	华虹集团	70,000	0	10.61
3.	华虹 NEC	70,000	0	10.61
4.	上海宏力半导体 制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		660,000	335,000	100.00

4. 2010年12月第一次增资

2010年11月20日，华力微股东会作出决议，同意华力微注册资本由660,000万元增至790,000万元，新增注册资本130,000万元由上海联和投资有限公司以130,000万元的价格认缴。

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于2010年11月26日出具的沪立信佳诚验字(2010)第1039号《验资报告》，截至2010年11月25日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第四期注册资本58,083万元。

2010年12月1日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000098113的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	580,000	358,083	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86

3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体 制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		790,000	393,083	100.00

5. 2011 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 28 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1011 号《验资报告》，截至 2011 年 4 月 28 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第五期注册资本 127,550 万元。

2011 年 4 月 28 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	580,000	485,633	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体 制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		790,000	520,633	100.00

6. 2011 年 8 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 2 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1020 号《验资报告》，截至 2011 年 8 月 2 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第六期注册资本 71,917 万元。

2011 年 8 月 5 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	580,000	557,550	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体 制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		790,000	592,550	100.00

7. 2011 年 11 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 14 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1030 号《验资报告》，截至 2011 年 11 月 14 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第七期注册资本 22,450 万元。

2011年11月18日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000098113的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体 制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		790,000	615,000	100.00

8. 2012年1月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于2012年1月16日出具的沪立信佳诚验字(2012)第1002号《验资报告》，截至2012年1月16日，华力微已收到华虹集团和华虹 NEC 以货币缴纳的第八期注册资本140,000万元。

2012年1月17日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000098113的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2.	华虹集团	70,000	70,000	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		790,000	755,000	100.00

9. 2014 年 2 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2014 年 2 月 14 日出具的沪立信佳诚验字(2014)第 1001 号《验资报告》，截至 2014 年 2 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第九期注册资本 35,000 万元。

2014 年 2 月 19 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2.	华虹集团	70,000	70,000	8.86

3.	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4.	上海宏力半导体 制造有限公司	70,000	70,000	8.86
合计		790,000	790,000	100.00

10. 2016年4月股东变更

根据华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司于 2012 年 4 月 23 日签订的《上海华虹 NEC 电子有限公司与上海宏力半导体制造有限公司合并协议》，双方以新设合并方式设立公司，名称为“上海华虹宏力半导体制造有限公司”，合并后，华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司解散，其债权、债务全部由上海华虹宏力承继。据此，华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司持有的华力微股权均变更为由合并后的上海华虹宏力持有。

2016 年 4 月 7 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913100005500570876 的《营业执照》。

本次股东变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有 限公司	580,000	580,000	73.42
2.	上海华虹宏力	140,000	140,000	17.72
3.	华虹集团	70,000	70,000	8.86

合计	790,000	790,000	100.00
----	---------	---------	--------

11. 2016年12月第二次增资

2016年11月18日，华力微股东会作出《关于同意上海华力微电子有限公司增资的决议》，同意华力微注册资本由790,000万元增至2,190,000万元，其中上海联和投资有限公司以520,000万元的价格认缴新增注册资本520,000万元，上海集成电路基金以880,000万元的价格认缴新增注册资本880,000万元。

2016年12月14日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913100005500570876的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	上海联和投资有限公司	1,100,000	1,100,000	50.23
2.	上海集成电路基金	880,000	880,000	40.18
3.	上海华虹宏力	140,000	140,000	6.39
4.	华虹集团	70,000	70,000	3.20
合 计		2,190,000	2,190,000	100.00

12. 2019年12月第一次股权转让及第三次增资

2019年12月13日，华力微股东会作出《关于上海华力微电子有限公司

司股权变更和增资的决议》，同意上海联和投资有限公司将其所持有的华力微 50.2283% 股权（对应注册资本 1,100,000 万元）以 1,148,510 万元的价格转让给华虹集团；同意华力微注册资本由 2,190,000 万元增至 2,207,239.727995 万元，新增 17,239.727995 万元注册资本由华虹集团以 18,000 万元的价格进行认缴。

2019 年 12 月 25 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913100005500570876 的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	华虹集团	1,187,239. 727995	1,187,239. 727995	53.79
2.	上海集成电路基金	880,000	880,000	39.87
3.	上海华虹宏力	140,000	140,000	6.34
	合计	2,207,239. 727995	2,207,239. 727995	100.00

13. 2023 年 11 月第四次增资

2023 年 11 月 18 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方为华虹集团及大基金二期。

2023 年 11 月 28 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913100005500570876 的《营业执

照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例 (%)
1.	华虹集团	53.85
2.	上海集成电路基金	30.98
3.	大基金二期	10.24
4.	上海华虹宏力	4.93
	合计	100.00

14. 2025 年 4 月第五次增资

2025 年 3 月 28 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方为华虹集团、国投先导基金及大基金二期。

2025 年 4 月 30 日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913100005500570876 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例 (%)
1.	华虹集团	63.54
2.	上海集成电路基金	15.72
3.	大基金二期	10.25
4.	国投先导基金	7.98
5.	上海华虹宏力	2.50

合计	100.00
----	--------

15. 2025年8月分立

2025年6月26日，华力微股东会作出《关于公司分立的决议》，同意华力微进行分立，分立基准日为2024年11月30日，分立后华力微继续存续，同时将华力微的长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定权利义务依法分出给新设公司；分立后，华力微的注册资本为203,619.219806万元，分立后的各公司股东持股比例与分立前保持一致，分立前的债务由分立后的华力微及新设公司承担连带责任。前述分立决议作出后，华力微于报纸发布了关于华力微分立事宜的公告，并向相关债权人发出了《债权人通知书》。

2025年8月21日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913100005500570876的《营业执照》。

本次分立完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1.	华虹集团	129,388.277164	129,388.277164	63.54
2.	上海集成电路基金	32,012.074045	32,012.074045	15.72
3.	大基金二期	20,871.634314	20,871.634314	10.25
4.	国投先导基金	16,254.404321	16,254.404321	7.98

5.	上海华虹 宏力	5,092.829962	5,092.829962	2.50
	合计	203,619.219806	203,619.219806	100.00

(三) 标的资产权利负担情况

经本所律师核查，根据华力微提供的市场监督管理部门登记档案等文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>) 的查询以及华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方出具的承诺，资产出售方各自持有的华力微的股权不存在纠纷，未设置有质押等担保权利，也未遭受查封、冻结或其他权利限制。

基于上述核查，本所律师认为，华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方各自合法持有华力微的相应股权，标的资产产权清晰，不存在涉及重大纠纷的情况。

(四) 华力微的主要资产

经本所律师核查，并根据华力微的确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微主要资产的具体情况如下：

1. 主要租赁物业

经本所律师核查，并根据华力微的确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微承租的主要经营性租赁物业情况如下：

序号	出租方	租赁地址	租赁面积	租赁期限	用途
1.	上海华虹宏力	上海市浦东新区张江高科技园区13街坊2丘厂房	91,563.11平方米	2010年3月1日至2030年2月28日	厂房
2.			化学品仓库、动力厂房和生产厂房	自验收合格交付之日起20年	
3.			192平方米	2021年6月1日至2026年12月31日	厂房

基于上述核查，本所律师认为，华力微以租赁方式使用上述房屋不违反法律、行政法规的强制性规定。

2. 主要专利

(1) 主要境内已授权专利

经本所律师核查，根据华力微提供的专利证书等文件资料、本所律师于国家知识产权局网站的公开查询并经华力微确认，截至2025年12月31日，华力微拥有的分立后拟保留在其名下的主要境内已授权专利共计1933项，具体情况详见本法律意见书附件一表1。

基于上述核查，本所律师认为，华力微系自行申请取得上述专利

权，华力微已取得的上述专利权不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

(2) 主要境外已授权专利

经本所律师核查，根据华力微提供的专利证书等文件资料、上海浦一知识产权代理有限公司出具的《关于上海华力微电子有限公司境外专利的说明》，截至2025年12月31日，华力微拥有的分立后拟保留在其名下的主要境外已授权专利共计148项，具体情况详见本法律意见书附件一表2。

经本所律师核查，根据上海浦一知识产权代理有限公司出具的《关于上海华力微电子有限公司境外专利的说明》并经华力微确认，华力微依法有效拥有上述专利的权利，并均已按照注册地法律法规的规定依法缴纳了相关费用，该等专利处于合法有效的状态；该等专利权属清晰，不存在争议或纠纷，或潜在争议或纠纷，或抵押、质押等权利瑕疵或限制的情形。

3. 主要集成电路布图设计专有权

经本所律师核查，根据华力微提供的文件资料并经华力微确认，截至2025年12月31日，华力微拥有的主要集成电路布图设计专有权共10项，具体情况详见本法律意见书附件一表3。

基于上述核查，本所律师认为，华力微系自行申请取得上述集成电路布图设计专有权，华力微已取得的上述集成电路布图设计专有权不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

4. 主要 IP 授权

经本所律师核查，根据华力微提供的文件资料并经华力微确认，华力微通过与第三方 IP 供应商的合作，为客户提供不同种类的标准单元库、存储器编译器和其他 IP 类型。截至 2025 年 12 月 31 日，华力微获得的 IP 授权主要类型包括标准单元库、可编程存储类 IP、嵌入式非易失性存储 IP 及模拟、接口 IP 等。

(五) 华力微的业务开展及业务许可

经本所律师核查，华力微的经营范围为“开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。根据华力微的确认，华力微的主营业务为集成电路晶圆代工业务。

经本所律师核查，并根据华力微的确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微拥有的主要资质及许可如下：

1. 华力微已办理进出口货物收发货人备案，所在地海关为浦东海关，海关备案编码为3122211409，备案日期为2010年3月5日。
2. 华力微持有上海市浦东新区生态环境局于2022年12月9日核发的《排污许可证》，证书编号为913100005500570876001V，行业类别为集成电路制造、锅炉，有效期限自2022年12月9日至2027年12月8日。

(六) 华力微的税务情况

1. 税种、税率及税收优惠情况

经本所律师核查，根据大华会计师出具的《审计报告》以及华力微的确认，华力微目前适用的主要税种、税率情况如下：

公司名称	主要税种	税率
华力微	企业所得税	0%（注 1）
	增值税	13、9、6、3、0% （注 2）

注 1：根据国务院颁布的《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）和财政部、税务总局、发展改革委及工业和信息化部颁布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告[2020]45 号）的相关规定，华力微为集成电路线宽小于 65 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业，按照税法相关规定可以自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。截至 2025 年 12 月 31 日止，华力微进入税务获利年度第一年。

注 2：根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。据此，华力微适用上述增值税加计抵减政策。

2. 税务合规情况

经本所律师核查，根据上海市公共信用信息服务中心于 2026 年 3 月 17 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，就华力微，在 2021 年 2 月 25 日（含）至 2026 年 2 月 25 日（含）的查

询时间范围内，在税务领域“未查见信息主体的违法记录信息”。

(七) 华力微的合规经营情况

经本所律师核查，根据上海市公共信用信息服务中心于 2026 年 3 月 17 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，就华力微，在 2021 年 2 月 25 日（含）至 2026 年 2 月 25 日（含）的查询时间范围内，在发展改革、商务、生态环境、安全生产、消防、市场监管、税务、人力资源社会保障、公积金管理等领域“未查见信息主体的违法记录信息”。

(八) 华力微的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

经本所律师核查，根据华力微提供的相关文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn>）、信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）等公开网络信息的查询并经华力微确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微不存在尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。

五. 本次交易涉及的债权债务和员工安置的处理

经本所律师核查，根据本次交易方案，本次交易实施完毕后，华力微涉及之原有债权债务将仍由华力微自行承担，不涉及债权、债务的转让。本次交易实施完毕后，华虹半导体将成为华力微的控股股东，并以其在华力微认缴的出资额为限对华力微承担责任。

经本所律师核查，本次交易实施完毕后，华力微的独立法人主体地位未发生变化，其应继续依法履行其与员工的劳动合同。

六. 本次交易的信息披露

(一) 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华虹半导体就本次交易履行信息披露义务的具体情况如下：

1. 2025年8月18日，华虹半导体发布《华虹半导体有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-019），华虹半导体A股股票自2025年8月18日开市起停牌。
2. 2025年8月25日，华虹半导体发布《华虹半导体有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-020）。
3. 2025年8月29日，华虹半导体2025年第六次董事会作出决议，同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2025年9月1日发布《华虹半导体有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-025），华虹半导体股票自2025年9月1日开市起复牌。
4. 2025年9月30日、2025年10月31日、2025年11月29日、2025年12月29日，华虹半导体分别发布了关于本次交易事项的进展公告。

5. 2025年12月31日，华虹半导体2025年第九次董事会作出决议，同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》等与本次交易相关的议案；2026年1月22日，华虹半导体发出了关于本次交易的股东大会通知。
6. 2026年2月10日，华虹半导体公告了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告。同日，华虹半导体召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
7. 2026年3月30日，华虹半导体2026年第三次董事会作出决议，同意《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

(二) 基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，华虹半导体就本次交易已根据相关法律、法规以及规范性文件的规定，履行了必要的信息披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；华虹半导体尚须根据本次交易进展情况，按照《重组办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关信息披露义务。

七. 本次交易的相关实质性条件

(一) 本次交易符合《重组办法》规定的相关条件

1. 经本所律师核查，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组办法》第十一条第（一）项之规定，具体如下：

- (1) 经本所律师核查，根据华力微提供的相关文件资料及其确认，华力微主要从事集成电路晶圆代工业务。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，华力微所从事的业务不属于限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策。
- (2) 经本所律师核查，本次交易的标的资产为华力微 97.4988%的股权，根据上海市公共信用信息服务中心于 2026 年 3 月 17 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，报告期内华力微不存在因违反环境保护、土地管理相关法律法规而受到行政处罚的情形。
- (3) 经本所律师核查，本次交易中，参与集中的上市公司、标的公司上一年度营业额已达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》所规定的申报经营者集中的营业额标准；但本次交易前华虹集团直接持有标的公司 63.5443%的股权，本次交易后标的公司将成为上市公司的全资子公司，由于华虹集团仍系上市公司的间接控股股东，华虹集团将通过上市公司间接控制标的公司，因此本次交易未导致标的公司最终控制权发生变更。

本所律师已于2025年9月通过经营者集中反垄断业务系统提交《华虹半导体有限公司收购上海华力微电子有限公司97.4988%股权经营者集中申报事宜商谈申请报告》，并提出本次交易是否触发经营者集中审查的商谈问题。上海市市场监督管理局（国家市场监督管理总局授权的华东地区行政监管单位）负责本次交易商谈申请的审查人员已在商谈过程中答复标的公司控制权未发生变更的情形下，无需履行经营者集中申报程序。

(4) 经本所律师核查，上市公司系注册于中国香港特别行政区的红筹企业，交易对方及标的公司均为内资企业；本次交易后，上市公司将直接持有标的公司97.4988%的股权。本次交易涉及外商投资事宜、不涉及对外投资，需就外商投资事宜履行外商投资信息报告程序，上市公司将根据有关规定及本次交易时间进度办理相关手续。

2. 经本所律师核查，截至2025年12月31日，华虹半导体的股份总数为173,761.4193万股。根据本次交易方案之发行股份上限计算（包括发行股份购买资产和募集配套资金），本次交易完成后，社会公众股股东持有的股份不低于华虹半导体股本总额的10%，华虹半导体仍然符合上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 经本所律师核查，本次交易购买的标的资产的最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构确认的评估结果为基础确定；华虹半导体董事会和独立董事均已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估价值的公允性发表肯定性意见；本次交易的交易各方已按照或将按照相关法律、法规以及规范性文件及

内部管理制度的要求履行相应的内部授权与批准程序。本次发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日（即华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议公告日）前 120 个交易日华虹半导体股票交易均价的 80%。据此，本所律师认为，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害华虹半导体和其股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项之规定。

4. 经本所律师核查，根据交易对方和华力微提供的相关文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）等公开网络信息的查询及资产出售方出具的相关承诺，华虹半导体本次交易购买的标的资产权属清晰，交易对方合法拥有标的资产的所有权，标的资产不存在被质押、查封、冻结等限制转让的情形，标的资产的过户和转移不存在法律障碍。

经本所律师核查，根据本次交易方案及相关协议，本次交易不涉及债权、债务的转移或处置，标的公司的债权债务仍将由其享有和承担。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，本次交易符合《重组办法》第十一条第（四）项之规定。

5. 经本所律师核查，根据《重组报告书》以及华虹半导体的确认，本次交易有利于华虹半导体增强持续经营能力，不存在可能导致华虹半导体在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第（五）项之规定。

6. 经本所律师核查，根据《重组报告书》以及华虹半导体提供的相关文件资料及其确认，本次交易前，华虹半导体已经按照有关法律、法规以及规范性文件的规定建立了法人治理结构和独立运营的公司管理体系，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于实际控制人及其关联人。本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司，华虹半导体的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于其实际控制人及其关联人。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第（六）项之规定。
7. 经本所律师核查，华虹半导体已经按照《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。华虹半导体上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，华虹半导体仍将保持其健全有效的法人治理结构。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第（七）项之规定。
8. 经本所律师核查，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70013197_B01 号《审计报告》，华虹半导体不存在最近一年财务会计报告被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的情形。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。
9. 经本所律师核查，根据华虹半导体及其董事、高级管理人员出具的承诺、相关政府主管部门出具的证明以及本所律师于信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn>）等公开网络信息的查询，华虹半导体及

其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及华虹半导体的确认，本次交易有利于提高华虹半导体的资产质量、增强华虹半导体的持续经营能力，不会导致华虹半导体财务状况发生重大不利变化，本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经本所律师核查，根据本次交易的相关协议、资产出售方出具的相关承诺，华虹半导体本次交易购买的标的资产权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者妨碍权属转移的其他情况，标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍；交易对方合法持有标的资产，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；交易对方对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形。据此，本所律师认为，本次交易购买的标的资产权属清晰，如相关法律程序和先决条件得到适当履行，资产出售方持有之华力微股权在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。

据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十四条之规定。

11. 经本所律师核查，根据《重组报告书》以及本次交易方案，本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，

且发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%；本次募集配套资金拟用于华力微技术升级改造项目、华力微特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十五条及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之规定。

12. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议、2025 年第九次董事会会议决议、2026 年第一次临时股东大会决议及 2026 年第三次董事会会议决议，华虹半导体本次发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日（即华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议公告日）前 120 个交易日华虹半导体股票交易均价的 80%。据此，本所律师认为，本次发行股份购买资产的发行价格符合《重组办法》第四十六条之规定。

13. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议、2025 年第九次董事会会议决议、2026 年第一次临时股东大会决议、2026 年第三次董事会会议决议以及交易对方出具的承诺函，交易对方已就在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期作出承诺（交易对方锁定期承诺的具体情况详见本法律意见书第二（一）1（7）项）。据此，本所律师认为，本次交易中有关股份限售安排符合《重组办法》第四十七条、第四十八条第二款之规定。

（二）本次交易符合《发行办法》规定的相关条件

1. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、华虹半导体及其董事、高级

管理人员的出具的相关承诺并经华虹半导体确认，截至本法律意见书出具之日，华虹半导体不存在《发行办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形：

- (1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
 - (2) 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
 - (3) 现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
 - (4) 上市公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
 - (5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
 - (6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
2. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，华虹半导体本次募集配套资金拟用于华力微技术升级改造项目、华力微特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。

据此，本所律师认为，本次募集配套资金的用途符合《发行办法》第十二条之规定。

3. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，最终发行对象将由华虹半导体股东大会授权董事会在取得中国证监会注册同意文件后，与本次交易的主承销商根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。据此，本所律师认为，本次募集配套资金的发行对象符合《发行办法》第五十五条之规定。
4. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日华虹半导体股票交易均价的 80%，最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次交易的主承销商根据竞价结果协商确定。据此，本所律师认为，本次募集配套资金的定价基准日、发行价格符合《发行办法》第五十六条、第五十七条之规定。
5. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、本次交易方案，根据本次发行方案，本次发行的发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。据此，本所律师认为，本次募集配套资金的股份限售安排符合《发行办法》第五十九条之规定。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》和《发行办法》规定的各项实质条件。

八. 同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

1. 经本所律师核查，根据华虹半导体的年度报告等公开披露文件及其确认，华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。本次交易前，华虹半导体间接控股股东华虹集团控制的华力微与上市公司均从事 65/55nm、40nm 晶圆代工业务，双方的同类业务为相同工艺节点下的重合工艺平台的代工业务。上市公司和华力微的工艺技术存在一定的差异，但双方基于各自的工艺技术提供的代工服务不存在实质性差异，双方存在不构成重大不利影响的同业竞争。
2. 经本所律师核查，根据本次交易方案、华虹集团出具的相关承诺及华虹半导体的确认，本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司，华虹集团及其控股子公司（华虹半导体及其控股子公司除外）所从事之业务与华虹半导体及其控股子公司从事之主营业务不存在构成重大不利影响的同业竞争。
3. 关于避免同业竞争的措施

经本所律师核查，为充分保护华虹半导体及投资者的利益，华虹半导体的直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

- (1) 截至承诺函签署之日，其及其控制的除华虹半导体及其控股子公

司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”），与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。

- (2) 本次交易完成后，其及其控制的其他企业与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，其及其控制的其他企业将采取有效措施避免新增与华虹半导体及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动。
- (3) 其如违反上述承诺的，愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给华虹半导体及其控股子公司造成的所有直接和间接损失。
- (4) 上述承诺在其作为华虹半导体控股股东/间接控股股东期间有效。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易不会导致华虹半导体新增构成重大不利影响的同业竞争；同时，华虹国际及华虹集团已就避免与华虹半导体之间的同业竞争出具了有效承诺，有助于保护华虹半导体及其中小股东的利益。

（二）关联交易

1. 本次交易构成关联交易

经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

2. 标的公司报告期内关联交易情况

经本所律师核查，根据大华会计师出具的《审计报告》以及华力微提供的相关文件资料，报告期内，标的公司与其主要关联方之间发生的主要关联交易的具体情况详见本法律意见书附件二。

3. 规范关联交易的措施

经本所律师核查，为减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护华虹半导体及其中小股东的合法权益，华虹半导体的直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺：

- (1) 本次交易完成后，其及其控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其下属公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；
- (2) 其将严格遵守相关法律法规和上市公司章程等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不以任何形式非法占用上市公司的资金、资产，不要求上市公司违规向其提供任何形式担保，不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。
- (3) 其违反上述承诺的，其愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给上市公司及其下属公司造成的所有直接和间接损失。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司，华虹半导体因标的资产注入将新增部分关联交易，该等关联交易是标的公司基于自身业务需求所作出的经营决策，未对其经营独立性产生重大不利影响。此外，华虹半导体的直接及间接控股股东已出具《关于规范关联交易的承诺》，该等承诺不存在违反法律、法规以及规范性文件规定的情形，有利于保障华虹半导体及其中小股东的利益。

九. 本次交易涉及的证券服务机构及其资格

经本所律师核查，本次交易涉及的主要证券服务机构情况如下：

（一）独立财务顾问

经本所律师核查，本次交易的独立财务顾问为国泰海通，国泰海通持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

（二）审计机构

经本所律师核查，本次交易针对标的资产的审计机构为大华会计师，大华会计师持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，并办理了从事证券服务业务会计师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

（三）资产评估机构

经本所律师核查，本次交易针对标的资产的资产评估机构为东洲评估，东洲评估已于上海市财政局办理评估机构备案并公告，并办理了从事证券服务业务资产评估机构备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

(四) 备考审阅机构

经本所律师核查，本次交易的备考审阅机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）持有中华人民共和国财政部核发的《会计师事务所执业证书》，并办理了从事证券服务业务会计师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

(五) 法律顾问

经本所律师核查，本次交易的法律顾问为本所，本所持有上海市司法局核发的《律师事务所执业许可证》，并已完成证券法律业务律师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

基于上述核查，本所律师认为，为本次交易提供服务的证券服务机构均具备为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

十. 关于上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况以及股票买卖自查情况

(一) 内幕信息知情人登记制度的制定情况

经本所律师核查，华虹半导体已制定《内幕信息知情人登记管理制度》等公司制度。

(二) 内幕信息知情人登记制度的执行情况

经本所律师核查，根据华虹半导体董事会出具的相关说明，华虹半导体已按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在本次交易期间，采取了如下保密措施：

1. 华虹半导体在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2. 华虹半导体及华虹半导体相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。
3. 华虹半导体严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送上交所。
4. 华虹半导体多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，华虹半导体严格遵守了保密义务。

5. 华虹半导体与交易对方签署《保密协议》，且华虹半导体与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。华虹半导体与为本次交易聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。
6. 筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成华虹半导体股价异常波动，经华虹半导体向上交所申请，华虹半导体股票自 2025 年 8 月 18 日开市起停牌。

基于上述核查，本所律师认为，华虹半导体在本次交易中按照《内幕信息知情人登记制度》执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三) 相关人员买卖上市公司股票情况

经本所律师核查，根据《重组办法》等法律法规的规定，华虹半导体应对本次交易申请股票停牌前六个月至《重组报告书》披露之前一日止（以下简称“核查期间”），华虹半导体及其董事、高级管理人员，华虹半导体控股股东，交易对方及其主要负责人、有关知情人员，标的公司及其董事、高级管理人员、有关知情人员，相关中介机构及其经办人员、其他有关知情人员，以及前述人员的直系亲属等主体（以下简称“相关人员”）买卖华虹半导体股票的情况进行自查。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及相关人員出具的自查报告、承诺函等文件资料，本所已就内幕信息知情人核查期间买卖上市公司股票的情况出具了《上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》。

十一. 结论意见

综上所述，本所律师认为，华虹半导体有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易各方均具备参与本次交易的主体资格；本次交易方案的内容符合法律、法规以及规范性文件的要求；本次交易符合《重组办法》和《发行办法》规定的各项实质条件；本次交易在取得本法律意见书所述必要的批准、授权后，其实施不存在法律障碍。

本法律意见书正本一式六份。



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "韩炯".

经办律师

陈 军 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈军".

夏 青 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "夏青".

二〇二六年三月三十日

附件一：标的公司拥有的主要知识产权

表 1：标的公司拥有的分立后拟保留在其名下的主要境内已授权专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1.	去除等离子体反应腔体内的刻蚀残留物的方法	发明	ZL202410693041.7	2024-05-30	申请日起二十年	原始取得
2.	基于承载台的套刻精度修正方法	发明	ZL202310580502.5	2023-05-22	申请日起二十年	原始取得
3.	一种接触层 OPC 方法	发明	ZL202310487630.5	2023-04-28	申请日起二十年	原始取得
4.	缺陷源检测方法	发明	ZL202310465632.4	2023-04-26	申请日起二十年	原始取得
5.	CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL202310465646.6	2023-04-26	申请日起二十年	原始取得
6.	透射电子显微镜样品的制备方法	发明	ZL202310341087.8	2023-03-31	申请日起二十年	原始取得
7.	一种晶圆失效原因的诊断方法	发明	ZL202310345544.0	2023-03-31	申请日起二十年	原始取得
8.	一种失效定位方法及电子设备	发明	ZL202310176980.X	2023-02-24	申请日起二十年	原始取得
9.	一种半导体测试结构、失效定位方法及电子设备	发明	ZL202310171806.6	2023-02-24	申请日起二十年	原始取得
10.	版图图形边缘分割方法	发明	ZL202211390612.7	2022-11-08	申请日起二十年	原始取得

11.	OPC 修正方法	发明	ZL202211343909. 8	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
12.	目标版图优化方法	发明	ZL202211343908. 3	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
13.	基于派工规则的自适应铜化学机械抛光设备智能排程控制方法	发明	ZL202211343857. 4	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
14.	静电消除装置及晶圆表面静电的消除方法	发明	ZL202211343831. X	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
15.	调节器件电学参数的方法	发明	ZL202211343837. 7	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
16.	CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL202211192978. 3	2022-09-28	申请日起二十年	原始取得
17.	晶圆缺陷检测方法	发明	ZL202211129030. 3	2022-09-16	申请日起二十年	原始取得
18.	目标基准结构的选择及基于其制备半导体结构的方法	发明	ZL202211128817. 8	2022-09-16	申请日起二十年	原始取得
19.	一种涡轮分子泵用定子防尘组件	发明	ZL202211058220. 0	2022-08-31	申请日起二十年	原始取得
20.	一种 CMP LK 机台清洗端漏液检测装置及检测方法	发明	ZL202211056056. X	2022-08-31	申请日起二十年	原始取得
21.	一种缺陷检测方法	发明	ZL202211053151. 4	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得
22.	一种电容测试结构及测试方法	发明	ZL202211042217. X	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得
23.	产品版图的评估系统及评估方法	发明	ZL202211053139. 3	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得

24.	一种数模混合的高精度建立保持时间测量电路及其实现方法	发明	ZL202210963404. 5	2022-08-11	申请日起二十年	原始取得
25.	一种闪存器件及其制备方法	发明	ZL202210906188. 0	2022-07-29	申请日起二十年	原始取得
26.	像素结构、图像传感器及终端	发明	ZL202210899224. 5	2022-07-28	申请日起二十年	原始取得
27.	高压器件的制造方法	发明	ZL202210761842. 3	2022-06-29	申请日起二十年	原始取得
28.	缺陷监控方法及缺陷监控系统	发明	ZL202210744426. 2	2022-06-27	申请日起二十年	原始取得
29.	样品载体保存装置	发明	ZL202210743865. 1	2022-06-27	申请日起二十年	原始取得
30.	晶圆校准方法	发明	ZL202210629214. X	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
31.	WAT 测试装置的检测方法及系统	发明	ZL202210602433. 9	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
32.	SONOS 存储器的光刻返工方法	发明	ZL202210614756. X	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
33.	缺陷样品的制备方法及互连结构缺陷的失效分析方法	发明	ZL202210438345. X	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
34.	版图的局部图形密度分析方法	发明	ZL202210420874. 7	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
35.	图像传感器的制作方法	发明	ZL202210419104. 0	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
36.	半导体结构及其制造方法	发明	ZL202210418472. 3	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
37.	半导体制程量测数据的预测方法	发明	ZL202210419129. 0	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得

38.	一种用于带走工艺腔室内残污的工艺方法	发明	ZL202210420937.9	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
39.	取卡装置	发明	ZL202210287643.3	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
40.	冲洗装置及半导体制造设备	发明	ZL202210304776.7	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
41.	抽气阀门、抽气阀门开闭方法及负压腔体组件	发明	ZL202210289042.6	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
42.	图像传感器的制造方法	发明	ZL202210287629.3	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
43.	一种双端口 SRAM 控制电路及其控制方法	发明	ZL202210190775.4	2022-02-28	申请日起二十年	原始取得
44.	一种晶圆生产线智能获取派工 WPH 的控制系统和方法	发明	ZL202210108131.6	2022-01-28	申请日起二十年	原始取得
45.	一种 PVD 机台	发明	ZL202210102716.7	2022-01-27	申请日起二十年	原始取得
46.	缺陷自分类方法及系统	发明	ZL202111681769.0	2021-12-30	申请日起二十年	原始取得
47.	监测晶圆杂质的方法	发明	ZL202111656770.8	2021-12-30	申请日起二十年	原始取得
48.	MOS 晶体管	发明	ZL202111626376.X	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
49.	一种 NOR 闪存的制备方法	发明	ZL202111681229.2	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得

50.	基于 Q-time 容时区间站点断线的智能调控方法及系统	发明	ZL202111626368. 5	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
51.	一种干泵尾管和离子注入机	发明	ZL202111626346. 9	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
52.	一种增强特殊分布缺陷检测的方法	发明	ZL202111433602. 2	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
53.	一种集成电路版图可制造性的分析方法	发明	ZL202111437319. 7	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
54.	SRAM 及其版图设计方法	发明	ZL202111437296. X	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
55.	一种晶圆缺陷扫描方法及系统	发明	ZL202111448042. 8	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
56.	一种检查光刻工艺微小失焦的方法	发明	ZL202111437342. 6	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
57.	承载台边缘位置平坦度的监控方法	发明	ZL202111437339. 4	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
58.	一种阈值电压的测量方法及其系统	发明	ZL202111436114. 7	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
59.	一种深度加速集成电路版图光刻工艺热点检查的方法	发明	ZL202111436108. 1	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得

60.	一种全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL202111436051.5	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
61.	一种横向扩散金属氧化物半导体的子电路模型构建方法	发明	ZL202111433629.1	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
62.	一种高压器件的栅氧层及其制造方法	发明	ZL202111276185.5	2021-10-29	申请日起二十年	原始取得
63.	图像传感器的制造方法	发明	ZL202111276184.0	2021-10-29	申请日起二十年	原始取得
64.	浅沟槽隔离及通孔刻蚀工艺刻蚀窗口的方法	发明	ZL202111266553.8	2021-10-28	申请日起二十年	原始取得
65.	基于整数规划的产品生产计划的制定方法	发明	ZL202111153447.9	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
66.	PMOS管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111151124.6	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
67.	NMOS管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111153440.7	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
68.	PMOS管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111151126.5	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
69.	机台联动性的监控方法及监控系统	发明	ZL202111006801.5	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得
70.	一种半导体反应设备及其位置校准方法	发明	ZL202111005062.8	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得

71.	FINFET 多输入标准单元版图结构及半导体器件	发明	ZL202111005046.9	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得
72.	缺陷忽视区域的自计算方法及装置	发明	ZL202110865251.6	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
73.	一种垂直栅半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865250.1	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
74.	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865223.4	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
75.	显影方法及显影装置	发明	ZL202110865198.X	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
76.	OPC 热点的修补方法	发明	ZL202110865191.8	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
77.	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865147.7	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
78.	测试结构及测试方法	发明	ZL202110748238.2	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
79.	自动物料传输系统及自动化物料传输方法	发明	ZL202110748236.3	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
80.	浅沟槽隔离能力测试结构及其测试方法	发明	ZL202110728159.5	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
81.	通孔层的 OPC 热点的修补方法	发明	ZL202110728158.0	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得

82.	计算机存储介质、禁跑货物预警系统和方法	发明	ZL202110728140.0	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
83.	MOSFET 本征电压的模拟计算方法	发明	ZL202110728116.7	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
84.	图像传感器及其制造方法	发明	ZL202110607036.6	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
85.	TEM 样品的制备方法	发明	ZL202110593171.X	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
86.	与非型闪存器件的接触孔制造方法	发明	ZL202110593161.6	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
87.	半导体器件	发明	ZL202110593143.8	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
88.	在制品数量的预测方法及预测系统	发明	ZL202110591292.0	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
89.	掩模板及监控遮光板位置的方法	发明	ZL202110591286.5	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
90.	闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110591283.1	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
91.	一种 SONOS 器件的制作方法	发明	ZL202110469842.1	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
92.	测试结构及测试方法	发明	ZL202110469820.5	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
93.	晶圆背面清洁装置、浸没式光刻机及晶圆背面清洁方法	发明	ZL202110469812.0	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
94.	电阻失配模型及提取方法	发明	ZL202110354884.0	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得

95.	版图结构及芯片的测试方法	发明	ZL202110354882.1	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
96.	一种图像传感器的制作方法	发明	ZL202110343076.4	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
97.	监控特殊形貌颗粒缺陷的方法	发明	ZL202110343035.5	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
98.	MOS 器件闪烁噪声模型及提取方法	发明	ZL202110343014.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
99.	光掩模结构和光刻设备	发明	ZL202110342840.6	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
100.	三维结构的天线效应的判断方法	发明	ZL202110342820.9	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
101.	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110342807.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
102.	化学机械研磨工艺模型的预测方法	发明	ZL202110340990.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
103.	晶边缺陷自动对焦系统及方法和计算机存储介质	发明	ZL202110340985.2	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
104.	半导体生产制造中 lot 实时追踪及分析方法及系统	发明	ZL202110278683.7	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
105.	针对 SRAM 图形 OPC 一致性检测的方法	发明	ZL202110278678.6	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得

106.	带失效分析标尺的电迁移测试结构	发明	ZL202110278611. 2	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
107.	一种固定宽度的单位方块电阻建模方法	发明	ZL202110274611. 5	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
108.	一种晶圆切割方法	发明	ZL202110274604. 5	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
109.	一种查询中断晶圆批次 LOT 的方法及系统	发明	ZL202110274242. X	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
110.	一种栅约束 NPN 三极管型 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL202110209885. 6	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
111.	或非型闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110209863. X	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
112.	NOR FLASH 的形成方法	发明	ZL202110209862. 5	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
113.	一种缺陷检测方法	发明	ZL202110209860. 6	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
114.	NOR FLASH 的形成方法	发明	ZL202110209856. X	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
115.	一种栅约束 NPN 三极管型 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL202110209122. 1	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
116.	一种闪存存储器字线驱动电路	发明	ZL202110209114. 7	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得

117.	一种具有数据保持功能的低功耗静态随机存取存储器电路	发明	ZL202110209113. 2	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
118.	或非型闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110209103. 9	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
119.	基于神经网络的存储器地址的测试方法及测试装置	发明	ZL202110167504. 2	2021-02-07	申请日起二十年	原始取得
120.	芯片的图形密度的分析方法、装置及电子设备	发明	ZL202110119198. 5	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
121.	一种光阻供应系统	发明	ZL202110117648. 7	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
122.	一种基于 WCF 的分布式报表系统	发明	ZL202110117638. 3	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
123.	一种异常检测方法及其装置	发明	ZL202110105541. 0	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
124.	半导体结构分析方法	发明	ZL202110105536. X	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
125.	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL202110103680. X	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
126.	推挽结构输出电路	发明	ZL202011563490. 8	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
127.	用于 SAR-ADC 中差分输出共模电压可控的 DAC 电路及其控制方法	发明	ZL202011563240. 4	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
128.	一种版图 DRC 违例的对比和定位方法	发明	ZL202011563235. 3	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得

129.	efuse 单元结构、efuse 单元的双列结构及 efuse 单元结构的应用电路	发明	ZL202011562191.2	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
130.	涂胶显影设备的稳压装置以及涂胶显影设备	发明	ZL202011486095.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
131.	掩模版及其制备方法、光刻机	发明	ZL202011486091.6	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
132.	炉管工艺的派工优化方法	发明	ZL202011486070.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
133.	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011486015.5	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
134.	分裂栅闪存单元	发明	ZL202011483368.X	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
135.	光罩位置匹配装置及其匹配方法、光刻机	发明	ZL202011483312.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
136.	晶圆缺陷扫描系统及扫描方法和计算机存储介质	发明	ZL202011483296.9	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
137.	图像传感器的制备方法	发明	ZL202011483214.0	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
138.	一种浅沟槽隔离的制备方法	发明	ZL202011377953.1	2020-11-30	申请日起二十年	原始取得
139.	一种具有线性对数输出的 CIS 传感器	发明	ZL202011363476.3	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得

140.	半导体芯片缺陷定位方法和定位模块	发明	ZL202011362183.3	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得
141.	用于表征 PN 结耗尽区特征的 WAT 测试结构和方法	发明	ZL202011355641.0	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得
142.	阻变存储器及其制造方法	发明	ZL202011353688.3	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
143.	CMOS 图像传感器的像素结构及像素结构的形成方法	发明	ZL202011353401.7	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
144.	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011353399.3	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
145.	SPICE 寿命模型的建模方法、调参方法及建模系统	发明	ZL202011347826.7	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
146.	DFM 综合评分方法	发明	ZL202011347795.5	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
147.	存储器阈值电压均匀性的电性测试方法	发明	ZL202011347770.5	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
148.	SPICE 模型仿真系统及仿真方法	发明	ZL202011265291.9	2020-11-13	申请日起二十年	原始取得
149.	一种通过 STI 刻蚀工艺改善 HDP 填充缺陷的方法	发明	ZL202011252721.3	2020-11-11	申请日起二十年	原始取得

150.	光刻工艺热点的光学邻近修正的方法	发明	ZL202011199811.0	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
151.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL202011196327.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
152.	测试结构、测试结构版图及其形成方法和测试方法	发明	ZL202011192438.6	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
153.	VT-BS 模型的先进工艺控制方法、系统及半导体设备	发明	ZL202011191797.X	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
154.	栅极氧化层的形成方法	发明	ZL202011191792.7	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
155.	改善顶层金属互联层表面缺陷的工艺方法	发明	ZL202011191791.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
156.	半导体结构的刻蚀方法	发明	ZL202011187636.3	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
157.	光学邻近修正方法	发明	ZL202011187204.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
158.	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011187190.4	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
159.	一种用于检测曝光机台透镜眩光程度的光掩膜版及方法	发明	ZL202011125663.8	2020-10-20	申请日起二十年	原始取得
160.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202011095029.4	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得

161.	基于自对准双重图形的产品良率 在线评估系统及评估方法	发明	ZL202011094785. 5	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得
162.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202011094759. 2	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得
163.	监测光刻机漏光情况的方法	发明	ZL202011026687. 8	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
164.	一种栅约束硅控整流器及其实现 方法	发明	ZL202011026662. 8	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
165.	像素图形的预处理方法	发明	ZL202011026644. X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
166.	晶圆缺陷的监控方法	发明	ZL202011026627. 6	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
167.	提高版图边缘格点的预测准确率 的方法	发明	ZL202011024116. 0	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
168.	一种栅约束硅控整流器及其实现 方法	发明	ZL202011024063. 2	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
169.	一种栅约束硅控整流器及其实现 方法	发明	ZL202011024051. X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
170.	CMOS 图像传感器的制作方法	发明	ZL202011024012. X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
171.	晶圆缺陷的验证方法	发明	ZL202011024000. 7	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得

172.	改善栅极刻蚀形貌稳定性的方法和刻蚀设备	发明	ZL202011023983. 2	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
173.	双重图形氧化硅芯轴制备方法	发明	ZL202010894940. 5	2020-08-31	申请日起二十年	原始取得
174.	接触孔光刻工艺热点的光学邻近修正方法	发明	ZL202010891829. 0	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
175.	快速热退火设备	发明	ZL202010884966. 1	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
176.	提升静电吸盘使用寿命的方法	发明	ZL202010884946. 4	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
177.	一种高精度温度模型校准方法及系统	发明	ZL202010884907. 4	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
178.	增强二维图形 OPC 模型精度的方法	发明	ZL202010884893. 6	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
179.	半导体结构的制备方法	发明	ZL202010884286. X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
180.	改善通孔刻蚀残留的方法	发明	ZL202010884276. 6	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
181.	退火设备的温度监控方法	发明	ZL202010884274. 7	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
182.	金属层光刻工艺热点的修复方法	发明	ZL202010884271. 3	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
183.	一种高利用率的电阻并联结构	发明	ZL202010884261. X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得

184.	判断研磨头的胶膜是否扭曲的方法	发明	ZL202010884254. X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
185.	闪存存储器及其制造方法	发明	ZL202010884241. 2	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
186.	优化冗余图形的方法	发明	ZL202010884240. 8	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
187.	MOSFET 阈值电压的 SPICE 子电路模型建模方法	发明	ZL202010884236. 1	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
188.	非挥发性存储器的读参考电流自动调节电路	发明	ZL202010831332. X	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
189.	CMOS 图像传感器转移管垂直栅极深度检测方法	发明	ZL202010831333. 4	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
190.	全局快门 CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL202010832325. 1	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
191.	刻蚀工艺的切换方法	发明	ZL202010840249. 9	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
192.	掩膜版及其制备方法	发明	ZL202010833559. 8	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
193.	提高金属层和通孔层之间的覆盖率的 OPC 处理方法	发明	ZL202010833535. 2	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
194.	版图的特征图形的识别方法	发明	ZL202010832188. 1	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得

195.	深沟槽隔离结构的制备方法及其半 导体结构	发明	ZL202010832187. 7	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
196.	绿色版图的认证方法及预警点的 风险性的判断方法	发明	ZL202010832185. 8	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
197.	光刻标记、对准标记及对准方法	发明	ZL202010832174. X	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
198.	图像传感器金属栅格版图的生成 方法及金属栅格光罩图形	发明	ZL202010832168. 4	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
199.	提高 OPC 修正效率的方法	发明	ZL202010832140. 0	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
200.	栅氧化层测试结构及其制造方 法、栅氧化层测试基板	发明	ZL202010811326. 8	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
201.	一种集成电路数字后端设计的方 法和系统	发明	ZL202010803517. X	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
202.	只读存储器阵列结构、电子设 备、扩展方法及编码方法	发明	ZL202010802417. 5	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
203.	版图图形密度的分析方法	发明	ZL202010802392. 9	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
204.	判断扫描电子显微镜机台是否倾 斜的方法	发明	ZL202010802383. X	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得

205.	一种优化光学邻近效应修正中曝光辅助图形的方法	发明	ZL202010802375. 5	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
206.	电可编程熔丝系统及其编程方法、读取方法	发明	ZL202010762700. X	2020-07-31	申请日起二十年	原始取得
207.	可编程电路及其编程方法、读取方法	发明	ZL202010760424. 3	2020-07-31	申请日起二十年	原始取得
208.	一种深沟槽隔离栅格结构的制造方法	发明	ZL202010745346. X	2020-07-29	申请日起二十年	原始取得
209.	晶片传送装置及 PVD 机台	发明	ZL202010717946. 5	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
210.	温度控制电路、装置、芯片封装测试系统	发明	ZL202010717932. 3	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
211.	半导体结构的形成方法	发明	ZL202010717830. 1	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
212.	一种压控振荡器结构及锁相环	发明	ZL202010717303. 0	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
213.	一种 SONOS 存储器及其制造方法	发明	ZL202010698851. 3	2020-07-20	申请日起二十年	原始取得
214.	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL202010695542. 0	2020-07-16	申请日起二十年	原始取得
215.	提升高压集成电路防负电流闩锁能力的保护环及实现方法	发明	ZL202010694335. 3	2020-07-17	申请日起二十年	原始取得

216.	提升高压集成电路防负电流闭锁能力的保护环及实现方法	发明	ZL202010693328.1	2020-07-17	申请日起二十年	原始取得
217.	电迁移测试结构	发明	ZL202010611427.0	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
218.	MOSFET 器件的全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL202010611393.5	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
219.	电迁移测试结构	发明	ZL202010611392.0	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
220.	MPW 多产品联测的数据处理方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010609717.1	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
221.	版图分析管控标准的计算方法及版图分析的管控方法	发明	ZL202010609716.7	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
222.	转移管的垂直栅及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL202010609712.9	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
223.	晶圆缺陷检测方法及系统	发明	ZL202010577852.2	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
224.	下字线驱动读辅助电路和版图设计	发明	ZL202010577071.3	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
225.	晶背缺陷图检索及预警方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010577051.6	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得

226.	OPC 修正通孔的选择方法	发明	ZL202010576117. X	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
227.	时钟信号调节电路和方法以及模拟电路	发明	ZL202010576116. 5	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
228.	失效数据修复电路和方法、非挥发性存储器、可读存储介质	发明	ZL202010576095. 7	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
229.	一种网格图形统一尺寸的方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010576089. 1	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
230.	版图图形精准匹配的检查方法	发明	ZL202010576088. 7	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
231.	金属线版图设计规则检查方法	发明	ZL202010576086. 8	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
232.	冗余图形的检测方法	发明	ZL202010479608. 2	2020-05-29	申请日起二十年	原始取得
233.	源极跟随管及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL202010478077. 5	2020-05-29	申请日起二十年	原始取得
234.	晶圆缺陷监控系统及其监控方法	发明	ZL202010414919. 0	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
235.	一种通用的芯片测试系统、测试方法及存储介质	发明	ZL202010414915. 2	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
236.	RRAM 阻变结构的形成方法	发明	ZL202010413713. 6	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
237.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202010350856. 7	2020-04-28	申请日起二十年	原始取得

238.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202010350852.9	2020-04-28	申请日起二十年	原始取得
239.	NMOS 器件的制备方法	发明	ZL202010345511.2	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
240.	NMOS 晶体管器件速度的补偿方法	发明	ZL202010344615.1	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
241.	金属线自对准二次成型工艺方法	发明	ZL202010344600.5	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
242.	SONOS 存储器及其制作方法	发明	ZL202010231443.7	2020-03-27	申请日起二十年	原始取得
243.	一种双向硅控整流器及其制备方法	发明	ZL202010231324.1	2020-03-27	申请日起二十年	原始取得
244.	一种堆叠电容、闪存器件及其制造方法	发明	ZL202010224926.4	2020-03-26	申请日起二十年	原始取得
245.	晶圆边缘缺陷检测系统及方法	发明	ZL202010183596.9	2020-03-16	申请日起二十年	原始取得
246.	一种设置研磨时间上限和研磨时间下限的方法及装置	发明	ZL202010183587.X	2020-03-16	申请日起二十年	原始取得
247.	一次性可编程器件的制造方法及一次性可编程器件	发明	ZL202010164411.X	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
248.	一种检测晶圆缺陷的方法及装置	发明	ZL202010159765.5	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
249.	存储器的形成方法	发明	ZL202010159638.5	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
250.	SONOS 器件的制作方法	发明	ZL202010159625.8	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得

251.	半导体的形成方法	发明	ZL202010159624. 3	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
252.	改善光刻机对准的方法	发明	ZL202010159622. 4	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
253.	过曝图形漏报错的检查方法、计算机设备及存储介质	发明	ZL202010104683. 0	2020-02-20	申请日起二十年	原始取得
254.	一种单元标记及其设计方法	发明	ZL202010104156. X	2020-02-20	申请日起二十年	原始取得
255.	一种 efuse 熔丝的版图结构	发明	ZL202010063863. 9	2020-01-20	申请日起二十年	原始取得
256.	一种并行冗余修正电路	发明	ZL202010053416. 5	2020-01-17	申请日起二十年	原始取得
257.	检测闪存位线之间漏电结构的制造方法及漏电检测方法	发明	ZL201911360934. 5	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
258.	缺陷监控方法	发明	ZL201911360930. 7	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
259.	减小关键尺寸漂移的方法	发明	ZL201911360926. 0	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
260.	写入辅助电路、存储器及写入操作方法	发明	ZL201911359172. 7	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
261.	冗余结构及其形成方法	发明	ZL201911334713. 0	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
262.	浮栅型闪存的制作方法	发明	ZL201911334533. 2	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
263.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201911334529. 6	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
264.	对准方法及校准方法	发明	ZL201911334523. 9	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得

265.	光罩组件以及光刻方法	发明	ZL201911334500.8	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
266.	标准单元库的测试方法	发明	ZL201911334496.5	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
267.	用于形成空气间隔的存储器制造方法	发明	ZL201911291112.6	2019-12-16	申请日起二十年	原始取得
268.	闪存的制造方法及闪存	发明	ZL201911261707.7	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
269.	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL201911261700.5	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
270.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201911260210.3	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
271.	阻变存储器及其制造方法	发明	ZL201911255220.8	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
272.	测试方法	发明	ZL201911255219.5	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
273.	半导体结构、晶体管、可变电容及元器件	发明	ZL201911252048.0	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
274.	芯轴图形的形成方法	发明	ZL201911204018.2	2019-11-29	申请日起二十年	原始取得
275.	闪存器件的形成方法	发明	ZL201911204016.3	2019-11-29	申请日起二十年	原始取得
276.	跳线装置	发明	ZL201911194919.8	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
277.	版图优化方法	发明	ZL201911193288.8	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
278.	检测晶片上下层叠对的方法和 设备	发明	ZL201911186817.1	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得

279.	改善铝焊盘结晶缺陷的方法	发明	ZL201911186786. X	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
280.	硅控整流器及其制造方法	发明	ZL201911186720. 0	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
281.	硅控整流器及其制造方法	发明	ZL201911186693. 7	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
282.	进样密封装置、气相色谱-质谱联用仪及色谱柱更换方法	发明	ZL201911185508. 2	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
283.	测试结构、失效分析定位方法及失效分析方法	发明	ZL201911183955. 4	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
284.	改善 2D-NAND 侧墙倾斜的方法	发明	ZL201911183942. 7	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
285.	电平转换电路	发明	ZL201911173830. 3	2019-11-26	申请日起二十年	原始取得
286.	占空比 50%的连续整数分频器及包括其的锁相环电路	发明	ZL201911162944. 8	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
287.	掩模版和标准片及对准图形误差补偿方法	发明	ZL201911162936. 3	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
288.	金属硬质掩模一体化刻蚀方法及其控制系统	发明	ZL201911162919. X	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
289.	光刻层掩模版的制备方法、离子注入方法	发明	ZL201911147979. 4	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得

290.	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201911137379. X	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
291.	MOS 器件的制造方法	发明	ZL201911136246. 0	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
292.	去胶设备、顶针监控方法和去胶工艺	发明	ZL201911136237. 1	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
293.	一种缺陷观测机台及其的图像分析补偿方法	发明	ZL201911133518. 1	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
294.	TechLEF 文件验证方法及其验证系统	发明	ZL201911133493. 5	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
295.	存储器读取速度调节电路	发明	ZL201911133050. 6	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
296.	n 倍驱动两输入与非门标准单元及其版图	发明	ZL201911133036. 6	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
297.	一种垂直栅 CMOS 图像传感器及制造方法	发明	ZL201911133006. 5	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
298.	一种改善小像素 CMOS 图像传感器性能的结构和工艺方法	发明	ZL201911132999. 4	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
299.	字线制作方法	发明	ZL201911095517. 2	2019-11-11	申请日起二十年	原始取得

300.	产品关键层的平均相似度计算方法及产品良率预测方法	发明	ZL201911090135.0	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
301.	确定合适的 OPC 修正程序的方法及装置、掩膜版及优化方法	发明	ZL201911089066.1	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
302.	晶背扫描仪、晶背扫描方法和晶圆扫描方法	发明	ZL201911089034.1	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
303.	浅沟槽隔离结构及其形成方法、半导体器件的制作方法	发明	ZL201911046453.7	2019-10-30	申请日起二十年	原始取得
304.	水循环装置及水循环系统	发明	ZL201911025742.9	2019-10-25	申请日起二十年	原始取得
305.	刻蚀方法以及半导体器件的制造方法	发明	ZL201911024501.2	2019-10-25	申请日起二十年	原始取得
306.	一种内嵌硅控整流器的 PMOS 器件及其实现方法	发明	ZL201910969259.X	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
307.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201910969256.6	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
308.	基于 FDSOI 结构的电平转换单元电路及版图设计方法	发明	ZL201910969246.2	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得

309.	一种提取用于透射电子显微镜的待测样品的方法	发明	ZL201910968721.4	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
310.	RRAM 阻变结构下电极的工艺方法	发明	ZL201910914898.6	2019-09-26	申请日起二十年	原始取得
311.	原子层沉积法形成氮化物膜的方法	发明	ZL201910912457.2	2019-09-25	申请日起二十年	原始取得
312.	版图图形密度的分析方法	发明	ZL201910906283.9	2019-09-24	申请日起二十年	原始取得
313.	Flash 器件耐久性能测试方法	发明	ZL201910898039.2	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
314.	改善刻蚀腔体缺陷的方法	发明	ZL201910897996.3	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
315.	一种评估 CIS 产品不同机台白色像素差异的方法	发明	ZL201910897871.0	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
316.	电迁移可靠性测试结构及电迁移可靠性测试方法	发明	ZL201910897833.5	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
317.	一种应用于锁相环的基于频率比较的锁定指示电路及方法	发明	ZL201910891665.9	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
318.	聚合物的去除方法	发明	ZL201910891638.1	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
319.	光源优化方法、光源优化装置、光刻系统及光刻方法	发明	ZL201910891431.4	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得

320.	浸没式光刻工艺中晶圆表面残水缺陷的改善方法	发明	ZL201910891416. X	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
321.	浅沟道隔离结构中的孔洞缺陷的检测方法	发明	ZL201910849214. 9	2019-09-09	申请日起二十年	原始取得
322.	套刻精度修正方法	发明	ZL201910818292. 2	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
323.	金属互连线填充方法	发明	ZL201910818279. 7	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
324.	CMOS 传感器及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL201910816560. 7	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
325.	改善栅极氧化层的方法及半导体器件的制造方法	发明	ZL201910816556. 0	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
326.	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809929. 1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
327.	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809608. 1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
328.	缺陷扫描机台间高匹配度扫描程式的快速建立方法	发明	ZL201910809109. 2	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
329.	版图修正方法	发明	ZL201910809085. 0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得

330.	一种化学机械研磨机台缺陷检测方法	发明	ZL201910809015.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
331.	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809013.6	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
332.	阻变存储器的制备方法	发明	ZL201910808942.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
333.	一种新型栅控 P-i-N 二极管 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910808934.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
334.	金属填充缺陷的检测结构及其方法	发明	ZL201910808932.1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
335.	栅约束硅控整流器 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201910808916.2	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
336.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910808827.8	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
337.	一种内嵌硅控整流器的 PMOS 器件及其实现方法	发明	ZL201910808797.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
338.	标准晶片及其制造方法	发明	ZL201910808692.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
339.	振荡器	发明	ZL201910777059.4	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得
340.	晶圆表面电荷消除装置及方法	发明	ZL201910777052.2	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得

341.	一种建立晶圆背面图形数据库的方法	发明	ZL201910777051. 8	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得
342.	一种栅控 P-i-N 二极管及其制造方法	发明	ZL201910763000. X	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
343.	一种截取锥清洗装置及使用方法	发明	ZL201910762887. 0	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
344.	一种晶圆表面超小尺寸缺陷检测方法	发明	ZL201910762878. 1	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
345.	一种晶圆缺陷标记装置及晶圆缺陷标记方法	发明	ZL201910698776. 8	2019-07-31	申请日起二十年	原始取得
346.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910698753. 7	2019-07-31	申请日起二十年	原始取得
347.	套准标记及其形成方法	发明	ZL201910678518. 3	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
348.	OPC 修正程序的 MRC 取值方法	发明	ZL201910678510. 7	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
349.	电迁移测试结构及方法	发明	ZL201910677450. 7	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
350.	一种具备修正功能的 antifuse 电路	发明	ZL201910670124. 3	2019-07-24	申请日起二十年	原始取得
351.	闪存的分裂栅极的制造方法	发明	ZL201910659098. 4	2019-07-22	申请日起二十年	原始取得

352.	触点单元结构及其构成的矩阵探针卡	发明	ZL201910643613. X	2019-07-17	申请日起二十年	原始取得
353.	离线量产产品工艺参数调整方法及其调整系统	发明	ZL201910571300. 8	2019-06-28	申请日起二十年	原始取得
354.	闪存的制造方法、闪存储器及光罩掩膜版	发明	ZL201910541255. 1	2019-06-21	申请日起二十年	原始取得
355.	色谱柱辅助安装工具及色谱柱安装方法	发明	ZL201910538137. 5	2019-06-20	申请日起二十年	原始取得
356.	芯片拼接方法	发明	ZL201910529990. 0	2019-06-19	申请日起二十年	原始取得
357.	锁存器	发明	ZL201910476094. 2	2019-06-03	申请日起二十年	原始取得
358.	半导体器件隔离侧墙厚度计算方法及其计算系统	发明	ZL201910476089. 1	2019-06-03	申请日起二十年	原始取得
359.	CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL201910452540. 6	2019-05-28	申请日起二十年	原始取得
360.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910450593. 4	2019-05-28	申请日起二十年	原始取得
361.	MOS_D 晶体管及其构成的 ESD 保护电路	发明	ZL201910432616. 9	2019-05-23	申请日起二十年	原始取得

362.	一种缺陷检测系统、检测方法 及电子束扫描机台	发明	ZL201910386157.5	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
363.	OPC 修正方法及 OPC 修正系统	发明	ZL201910385297.0	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
364.	全局快门 CMOS 图像传感器	发明	ZL201910382534.8	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
365.	基于 FinFET 结构的高速标准单 元库版图设计方法	发明	ZL201910382478.8	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
366.	一种分离栅闪存单元的半导体结 构及其制造方法	发明	ZL201910362571.2	2019-04-30	申请日起二十年	原始取得
367.	CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL201910358958.0	2019-04-29	申请日起二十年	原始取得
368.	一种自对准双层图形的形成方法	发明	ZL201910313973.3	2019-04-18	申请日起二十年	原始取得
369.	一种半导体结构及其制造方法	发明	ZL201910265516.1	2019-04-03	申请日起二十年	原始取得
370.	一种防止 ONO 刻蚀造成衬底损伤 的方法	发明	ZL201910244692.7	2019-03-28	申请日起二十年	原始取得
371.	一种辅助对准方法及系统	发明	ZL201910234065.5	2019-03-26	申请日起二十年	原始取得
372.	一种用于改善硅片翘曲度并提高 套刻精度的方法	发明	ZL201910177307.1	2019-03-08	申请日起二十年	原始取得
373.	一种侧墙结构的形成方法	发明	ZL201910173445.2	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得

374.	一种晶圆清洗干燥装置、方法及 化学机械研磨机台	发明	ZL201910173003.8	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
375.	掩膜版、闪存器件及其制造方法	发明	ZL201910172994.8	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
376.	闪存器件及其制造方法	发明	ZL201910172992.9	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
377.	一种形成随机存储器层的方法	发明	ZL201910157174.1	2019-03-01	申请日起二十年	原始取得
378.	一种探针卡的针尖的智能检测及 处理方法	发明	ZL201910157146.X	2019-03-01	申请日起二十年	原始取得
379.	一种分析半导体晶圆的方法 及装置	发明	ZL201811636763.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
380.	NOR FLASH 器件结构及其制造 方法	发明	ZL201811632627.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
381.	晶圆的晶边缺陷的监控方法	发明	ZL201811632588.7	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
382.	STI 的填充方法	发明	ZL201811632345.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
383.	SOI 二极管	发明	ZL201811632266.2	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
384.	晶圆制造中在线产品批次跑货状 态的分析预测方法	发明	ZL201811630469.8	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得

385.	拼接产品的测试光罩及其组合方法	发明	ZL201811630468. 3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
386.	分栅闪存的制造方法	发明	ZL201811630467. 9	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
387.	NOR 闪存及其制造方法	发明	ZL201811630391. X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
388.	分栅闪存的测试结构及其制造方法	发明	ZL201811630384. X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
389.	缺陷监控分析系统及方法	发明	ZL201811630264. X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
390.	台阶状 ONO 薄膜的刻蚀方法	发明	ZL201811607216. 9	2018-12-27	申请日起二十年	原始取得
391.	电子束扫描机台电子束孔径动态调整结构及测试方法	发明	ZL201811607200. 8	2018-12-27	申请日起二十年	原始取得
392.	一种自动扫描缺陷的方法	发明	ZL201811595214. 2	2018-12-25	申请日起二十年	原始取得
393.	晶圆刻蚀系统及晶圆刻蚀方法	发明	ZL201811580776. X	2018-12-24	申请日起二十年	原始取得
394.	一种提高混合刻蚀工艺稳定性的方法	发明	ZL201811557616. 3	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得
395.	一种提高刻蚀腔电流稳定性的方法	发明	ZL201811557608. 9	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得
396.	分离栅 flash 器件的工艺方法	发明	ZL201811553752. 5	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得

397.	去除侧壁 ONO 结构中阻挡氧化层残留的工艺方法	发明	ZL201811516115.0	2018-12-12	申请日起二十年	原始取得
398.	晶体管电性测试结构及测试方法	发明	ZL201811477002.4	2018-12-05	申请日起二十年	原始取得
399.	一种处理半导体晶圆的方法	发明	ZL201811471840.0	2018-12-04	申请日起二十年	原始取得
400.	一种晶圆转速监控装置及监控方法	发明	ZL201811467391.2	2018-12-03	申请日起二十年	原始取得
401.	气体注入装置及高温炉管	发明	ZL201811460120.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
402.	源漏极离子注入方法及注入系统	发明	ZL201811460106.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
403.	一种改善衬底缺陷处的图形刻蚀的方法	发明	ZL201811458598.3	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
404.	SRAM 测试结构	发明	ZL201811458597.9	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
405.	半导体器件的缺陷检测结构、装置及其检测方法	发明	ZL201811458596.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
406.	半导体结构的制备方法	发明	ZL201811458583.7	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
407.	一种双大马士革结构的形成方法	发明	ZL201811458561.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
408.	一种 MOS 晶体管栅极小信号电容测试方法及系统	发明	ZL201811458548.5	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得

409.	电阻模型的建立方法	发明	ZL201811458546.6	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
410.	酸槽式湿法刻蚀工艺	发明	ZL201811458540.9	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
411.	一种自对准双层图形的形成方法	发明	ZL201811458523.5	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
412.	一种 LOD 应力效应 SPICE 建模的方法	发明	ZL201811458514.6	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
413.	改善自对准像素单元满阱容量的 CMOS 图像传感器	发明	ZL201811458508.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
414.	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201811458489.1	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
415.	一种 MRC 冲突协同优化算法	发明	ZL201811458473.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
416.	一种晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201811458460.3	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
417.	一种 SONOS 存储结构及其制造方法	发明	ZL201811444528.2	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
418.	一种刻蚀方法及半导体器件	发明	ZL201811432033.8	2018-11-28	申请日起二十年	原始取得
419.	一种验证设计规则检查脚本的方法	发明	ZL201811408981.8	2018-11-23	申请日起二十年	原始取得
420.	Interconnect 电容值 SPICE 建模方法	发明	ZL201811396797.6	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得

421.	半导体产品良率上限分析方法	发明	ZL201811396608.5	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
422.	SONOS 器件的制造方法	发明	ZL201811396604.7	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
423.	栅极结构的制造方法	发明	ZL201811396595.1	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
424.	一种晶粒缺陷监控方法	发明	ZL201811369312.4	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
425.	一种检测机台的派工方法	发明	ZL201811368312.2	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
426.	一种离子注入的方法及设备	发明	ZL201811344422.5	2018-11-13	申请日起二十年	原始取得
427.	一种缺陷抽检方法	发明	ZL201811340879.9	2018-11-12	申请日起二十年	原始取得
428.	一种通过光阻膜厚监控涂胶显影机台涂胶槽水平程度的方法	发明	ZL201811302702.X	2018-11-02	申请日起二十年	原始取得
429.	一种优化通孔层连接性能的光学邻近修正方法	发明	ZL201811289318.0	2018-10-31	申请日起二十年	原始取得
430.	闪存的制造方法	发明	ZL201811281931.8	2018-10-31	申请日起二十年	原始取得
431.	一种优化势垒区像素离子注入改善串扰的方法	发明	ZL201811246105.X	2018-10-24	申请日起二十年	原始取得
432.	改善分栅结构闪存多步多晶硅刻蚀损伤的工艺集成方法	发明	ZL201811217631.3	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得

433.	一种改善 SONOS 存储器之多晶硅薄膜沉积特性的方法	发明	ZL201811217621. X	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
434.	闪存器件的制造方法	发明	ZL201811216570. 9	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
435.	一种膜质监控方法及装置	发明	ZL201811216561. X	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
436.	一种光学临近修正前的预处理方法	发明	ZL201811204210. 7	2018-10-16	申请日起二十年	原始取得
437.	一种阈值可调式高压金属氧化物半导体器件及其制备方法	发明	ZL201811198257. 7	2018-10-15	申请日起二十年	原始取得
438.	一种样品去层次方法	发明	ZL201811198243. 5	2018-10-15	申请日起二十年	原始取得
439.	一种图形密度的分析方法	发明	ZL201811154697. 2	2018-09-30	申请日起二十年	原始取得
440.	闪存结构及其控制方法	发明	ZL201811134024. 0	2018-09-27	申请日起二十年	原始取得
441.	闪存结构及对应的编程、擦除和读取方法	发明	ZL201811132953. 8	2018-09-27	申请日起二十年	原始取得
442.	一种涂布机构以及在硅片上涂布 HMDS 的方法	发明	ZL201811064491. 0	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得
443.	应用于高压电路防静电保护的无回滞效应硅控整流器	发明	ZL201811064488. 9	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得

444.	缺陷过滤系统及过滤方法和计算机存储介质	发明	ZL201811063793.6	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得
445.	一种刻蚀副产物智能自清洁方法	发明	ZL201811026563.2	2018-09-04	申请日起二十年	原始取得
446.	一种形成金属扩散阻挡层的方法	发明	ZL201811015325.1	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
447.	晶圆缺陷检测系统及检测方法和计算机存储介质	发明	ZL201811014892.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
448.	一种锁存电路	发明	ZL201811014888.9	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
449.	故障设备识别系统及识别方法和计算机存储介质	发明	ZL201811014880.2	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
450.	一种冗余图形添加方法	发明	ZL201811014864.3	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
451.	一种像素结构及其制造方法	发明	ZL201811013688.1	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
452.	晶圆清洗装置	发明	ZL201811013483.3	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
453.	一种多晶层光刻工艺热点查找方法	发明	ZL201811012246.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
454.	一种校正及监测铜电镀中洗边位置的方法	发明	ZL201811012214.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
455.	一种一体化刻蚀方法	发明	ZL201811011770.0	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得

456.	一种掩模版的制备方法	发明	ZL201811011755.6	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
457.	控片及其制造方法和化学机械研磨缺陷的监测方法	发明	ZL201811011719.X	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
458.	一种 CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL201811011675.0	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
459.	一种形成具有高深宽比图形的结构的方法	发明	ZL201810941652.3	2018-08-17	申请日起二十年	原始取得
460.	改善高深宽比图形不一致和提高光刻胶形貌陡度的方法	发明	ZL201810927353.4	2018-08-15	申请日起二十年	原始取得
461.	去除光刻胶层的方法	发明	ZL201810898935.4	2018-08-08	申请日起二十年	原始取得
462.	改善闪存单元擦除相关失效的工艺集成方法	发明	ZL201810840312.1	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
463.	改善 N 型 SONOS 器件阈值电压均一性的方法	发明	ZL201810840290.9	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
464.	基于 BSIM4 模型的 MOS 器件子电路温度模型及建模方法	发明	ZL201810840264.6	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
465.	滤除图形匹配度误报错的方法	发明	ZL201810840252.3	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得

466.	一种 MOSFET 栅氧化层电容校准结构	发明	ZL201810800725.7	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
467.	一种改善双重图形刻蚀芯模顶端圆角的工艺方法	发明	ZL201810800712.X	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
468.	一种浅沟槽隔离结构的形成方法及浅沟槽隔离结构	发明	ZL201810800695.X	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
469.	一种光刻工艺热点的检查方法	发明	ZL201810800585.3	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
470.	一种应用于干法去胶工艺的匹配验证方法	发明	ZL201810800573.0	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
471.	一种晶圆制程工艺参数的反馈方法	发明	ZL201810759253.5	2018-07-11	申请日起二十年	原始取得
472.	一种半导体器件及其制造方法	发明	ZL201810714188.4	2018-06-29	申请日起二十年	原始取得
473.	一种工艺控制方法	发明	ZL201810706079.8	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
474.	检测晶圆工作台平坦度的方法	发明	ZL201810672956.4	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
475.	快速热退火工艺能力的监控方法	发明	ZL201810672950.7	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
476.	化学机械研磨设备工艺能力的监控方法	发明	ZL201810672949.4	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得

477.	一种分裂栅结构下的浮栅隔离刻蚀工艺	发明	ZL201810632298.6	2018-06-19	申请日起二十年	原始取得
478.	一种分裂栅结构下的侧墙栅极隔离刻蚀膜层工艺	发明	ZL201810632297.1	2018-06-19	申请日起二十年	原始取得
479.	一种双大马士革结构的制作方法	发明	ZL201810604625.7	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
480.	一种等离子体刻蚀的方法	发明	ZL201810604623.8	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
481.	栅极区域的 OPC 验证方法	发明	ZL201810604622.3	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
482.	一种存储单元模型的阈值电压调节方法和系统	发明	ZL201810604592.6	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
483.	一种改善等离子体刻蚀工艺中首片效应的方法	发明	ZL201810604582.2	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
484.	探针卡	发明	ZL201810604560.6	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
485.	一种 SONOS 存储器及其制造方法	发明	ZL201810604556.X	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
486.	一种划片区内的监控图形的排布方法	发明	ZL201810565129.5	2018-06-04	申请日起二十年	原始取得
487.	金属离子监控方法	发明	ZL201810504049.9	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得

488.	一种应用于 SRAM 的可调节 WLUD 读写辅助电路	发明	ZL201810504047. X	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得
489.	一种化学气相淀积机台及处理机台报警的方法	发明	ZL201810503740. 5	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得
490.	一种闪存单元结构的制备方法	发明	ZL201810428572. 8	2018-05-07	申请日起二十年	原始取得
491.	E-FUSE 存储阵列、E-FUSE 以及 E-FUSE 操作方法	发明	ZL201810388020. 9	2018-04-26	申请日起二十年	原始取得
492.	一种静电吸附盘的温度监控方法	发明	ZL201810387262. 6	2018-04-26	申请日起二十年	原始取得
493.	一种检测站的来料负荷控制方法	发明	ZL201810362521. X	2018-04-20	申请日起二十年	原始取得
494.	一种调试关键尺寸均匀性的方法	发明	ZL201810360659. 6	2018-04-20	申请日起二十年	原始取得
495.	一种晶圆的测试方法	发明	ZL201810355979. 2	2018-04-19	申请日起二十年	原始取得
496.	一种铜金属互连电迁移测试结构及其测试方法	发明	ZL201810316625. 7	2018-04-10	申请日起二十年	原始取得
497.	一种芯片测试装置、测试方法及测试板	发明	ZL201810298527. 5	2018-04-03	申请日起二十年	原始取得
498.	无回滞效应栅接地 NMOS 静电防护半导体器件及其实现方法	发明	ZL201810277913. 6	2018-03-30	申请日起二十年	原始取得

499.	一种改进型的多样品并行去封装方法	发明	ZL201810252902. 2	2018-03-26	申请日起二十年	原始取得
500.	获取晶圆晶背刮伤来源的方法	发明	ZL201810157691. 4	2018-02-24	申请日起二十年	原始取得
501.	芯片的测试方法	发明	ZL201810157468. X	2018-02-24	申请日起二十年	原始取得
502.	一种检测晶圆上介质层孔道连通性的方法	发明	ZL201810153103. X	2018-02-11	申请日起二十年	原始取得
503.	射频晶体管射频参数模型建立方法	发明	ZL201810114825. 4	2018-02-06	申请日起二十年	原始取得
504.	一种独立控温的用于可靠性测试的测试结构及其测试方法	发明	ZL201810096981. 2	2018-01-31	申请日起二十年	原始取得
505.	闪存的制造方法	发明	ZL201810084833. 9	2018-01-29	申请日起二十年	原始取得
506.	一种光刻胶回刻蚀工艺中改善晶圆表面颗粒缺陷的方法	发明	ZL201810069436. 4	2018-01-24	申请日起二十年	原始取得
507.	闪存	发明	ZL201810063032. 4	2018-01-23	申请日起二十年	原始取得
508.	闪存及其制造方法	发明	ZL201810063024. X	2018-01-23	申请日起二十年	原始取得
509.	光刻胶去除方法	发明	ZL201810058404. 4	2018-01-22	申请日起二十年	原始取得
510.	闪存阵列的制作方法	发明	ZL201711466172. 8	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得

511.	一种电迁移加速测试方法	发明	ZL2017111465933.8	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
512.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL2017111464516.1	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
513.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL2017111464508.7	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
514.	一种闪烁噪声统计模型的建模方法及其提取方法	发明	ZL2017111464504.9	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
515.	OPC 建模中次分辨率辅助图形确定的方法	发明	ZL2017111464502.X	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
516.	适用于离子注入工艺套刻精度的评估方法	发明	ZL2017111461652.5	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
517.	一种带 SONOS 结构的晶体管及其制造方法	发明	ZL2017111430506.6	2017-12-26	申请日起二十年	原始取得
518.	改善 HTO 厚度稳定性的方法	发明	ZL2017111419332.3	2017-12-25	申请日起二十年	原始取得
519.	一种对插塞缺陷进行检测的方法	发明	ZL2017111394241.9	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
520.	一种版图重复单元匹配性检查方法及系统	发明	ZL2017111394189.7	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得

521.	一种压控振荡器电路	发明	ZL201711394141. 6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
522.	一种高可靠性读出电路	发明	ZL201711394120. 4	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
523.	去除斜边凸起的方法	发明	ZL201711394075. 2	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
524.	一种降低连接孔层程式运行时间的 OPC 修正方法	发明	ZL201711394054. 0	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
525.	一种 SPICE 集中模型的建模方法及系统	发明	ZL201711393123. 6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
526.	一种电子束扫描程式参数自调整方法	发明	ZL201711393038. X	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
527.	晶圆侧边去光阻方法	发明	ZL201711392379. 5	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
528.	一种 MOSFET 器件之全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL201711392362. X	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
529.	一种电感版图之辅助层及器件参数抽取的方法	发明	ZL201711392318. 9	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
530.	适用于随机存储器自动测试的高速电路结构及其测试方法	发明	ZL201711392308. 5	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
531.	SONOS 存储器的 ONO 刻蚀方法	发明	ZL201711392296. 6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得

532.	一种改善长寿命钽靶材后期使用的腔体套件结构	发明	ZL201711392270.1	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
533.	具有侧墙型选择栅的非易失存储器及其制造方法	发明	ZL201711389221.2	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
534.	一种检测多晶硅是否出现短路的检测方法	发明	ZL201711387149.X	2017-12-20	申请日起二十年	原始取得
535.	一种通过增加热处理过程改善 CIS 白色像素点的方法	发明	ZL201711387099.5	2017-12-20	申请日起二十年	原始取得
536.	一种带沟槽结构的双极型晶体管及其制作方法	发明	ZL201711374117.6	2017-12-19	申请日起二十年	原始取得
537.	提高通孔层 OPC 精度的方法	发明	ZL201711345445.3	2017-12-15	申请日起二十年	原始取得
538.	预调金属导线尺寸的方法	发明	ZL201711312299.4	2017-12-11	申请日起二十年	原始取得
539.	优化不同透光率下浅槽隔离刻蚀形貌的方法	发明	ZL201711281769.5	2017-12-07	申请日起二十年	原始取得
540.	改善金属层腐蚀缺陷方法	发明	ZL201711279353.X	2017-12-06	申请日起二十年	原始取得
541.	监控 3D 栅极氧化层工艺的方法及结构	发明	ZL201711244384.1	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得

542.	金属互连结构及其制作方法	发明	ZL201711243083.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
543.	避免控制栅形成中刻蚀返工导致无定型碳膜剥落的方法	发明	ZL201711242834.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
544.	浅沟槽隔离的制造方法	发明	ZL201711241074.4	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
545.	一种亮场缺陷检测设备自动优化光强条件的方法及系统	发明	ZL201711240724.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
546.	一种金属连线恒温电迁移测试结构	发明	ZL201711240650.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
547.	一种存储单元及其存储阵列结构、操作方法	发明	ZL201711240646.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
548.	刻蚀腔体部件的检测方法	发明	ZL201711239742.X	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
549.	提高注入机生产效率的方法	发明	ZL201711237469.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
550.	改善闪存中高压器件栅极氧化层可靠性的工艺集成方法	发明	ZL201711237456.X	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
551.	小样品的去层方法	发明	ZL201711234859.9	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
552.	一种金属层光阻顶部缺失工艺热点的版图处理方法	发明	ZL201711227505.1	2017-11-29	申请日起二十年	原始取得

553.	根据电路设计图形设置扫描阈值的方法	发明	ZL201711220974.0	2017-11-29	申请日起二十年	原始取得
554.	一种自动监控产品跑货状况的方法	发明	ZL201711219188.9	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
555.	一种基于光学临近效应修正减少栅极波动的方法	发明	ZL201711219183.6	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
556.	一种形成不同深度接触孔的刻蚀方法	发明	ZL201711219182.1	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
557.	单端转差分电路及其构成的缓冲器电路和采样保持电路	发明	ZL201711201528.5	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得
558.	一种一键式激活数据收集项目的方法	发明	ZL201711192842.1	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
559.	一种改善锗硅源漏极形貌的制备方法	发明	ZL201711191234.9	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
560.	一种化学机械研磨垫磨损的检测装置及工作方法	发明	ZL201711189823.3	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得

561.	一种改善层间介质研磨工艺厚度稳定性的方法	发明	ZL201711189813. X	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
562.	一种模拟内部版图图形的边缘冗余图形生成方法	发明	ZL201711183763. 4	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
563.	半导体器件的 SAB 工艺方法	发明	ZL201711178355. X	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
564.	提高离子注入区的深宽比的制造方法	发明	ZL201711178339. 0	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
565.	槽式湿法清洗机台	发明	ZL201711178278. 8	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
566.	去除光刻胶显影后残留缺陷的方法	发明	ZL201711178203. X	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
567.	一种监测离子注入设备性能的方法	发明	ZL201711177123. 2	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
568.	一种晶圆的重测方法	发明	ZL201711177120. 9	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
569.	一种用于尺寸缩减 NORFlash 单元工艺集成方法	发明	ZL201711176780. 5	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
570.	一种高可靠性三态输出电路	发明	ZL201711176777. 3	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得

571.	一种改善一体化刻蚀聚集残留缺陷的方法	发明	ZL201711172098.9	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
572.	SONOS 器件的形成方法	发明	ZL201711168493.X	2017-11-21	申请日起二十年	原始取得
573.	一种精确控制浅沟槽隔离的整体形貌和性能的方法	发明	ZL201711167683.X	2017-11-21	申请日起二十年	原始取得
574.	一种嵌入式闪存工艺集成方法	发明	ZL201711160947.9	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
575.	一种具备故障诊断的系统级芯片生产方法	发明	ZL201711160758.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
576.	一种建立全局调节模型进行优化快速热退火的方法	发明	ZL201711160733.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
577.	一种改善 HCD 氮化硅沉积工艺过程缺陷状况的装置	发明	ZL201711160388.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
578.	一种对芯片表面进行分区域对比扫描的检测方法及设备	发明	ZL201711160370.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
579.	一种基于缺陷贡献度的缺陷检测机台自动派工系统和方法	发明	ZL201711159860.X	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得

580.	一种接触孔底部钨栓缺陷的检测结构及检测方法	发明	ZL201711140573.4	2017-11-16	申请日起二十年	原始取得
581.	闪存的工艺集成结构和方法	发明	ZL201711138163.6	2017-11-16	申请日起二十年	原始取得
582.	一种检测接触孔底部钨栓缺失缺陷的方法	发明	ZL201711132944.4	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
583.	一种消除湿法刻蚀金属硅化物阻挡层底切缺陷的工艺方法	发明	ZL201711131180.7	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
584.	PVD 设备的工艺腔的工艺调节结构和方法	发明	ZL201711127897.4	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
585.	一种改善的套刻精度量测方法	发明	ZL201711125009.5	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
586.	一种存储器件中形成控制栅的工艺流程方法	发明	ZL201711123938.2	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
587.	有源区顶部圆滑度的模拟检测方法	发明	ZL201711121971.1	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
588.	镍金属硅化物的 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201711121958.6	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
589.	闪存单元结构及其制造方法	发明	ZL201711121845.6	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得

590.	刻蚀腔体的聚合物清洁方法	发明	ZL201711121422.4	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
591.	基于规则的 OPC 方法	发明	ZL201711112632.7	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
592.	一种改善光刻填充材料平坦度的方法	发明	ZL201711106966.3	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
593.	接触孔的金属连接结构及其制造方法	发明	ZL201711102829.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
594.	光刻套刻精度量测准确性的评估方法	发明	ZL201711102811.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
595.	用于化学机械研磨工艺模型建模的测试图形	发明	ZL201711102787.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
596.	一种边缘保护圈结构、反应室和化学气相沉积设备	发明	ZL201711100107.3	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
597.	一种提高离子注入层抗前层反射的 OPC 修正方法	发明	ZL201711100020.6	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
598.	一种分布式存储区块访问电路	发明	ZL201711100003.2	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
599.	一种改善闪存单元的工艺集成方法	发明	ZL201711099991.3	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得

600.	一种带误码消除功能的锁定指示器电路	发明	ZL201711099120.1	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
601.	一种提高监控图形监控精度的方法	发明	ZL201711099108.0	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
602.	一种省去 CLDD 光罩的 NorFlash 器件集成工艺方法	发明	ZL201711098208.1	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
603.	OPC 修正方法	发明	ZL201711097082.6	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
604.	刻蚀工艺方法	发明	ZL201711097030.9	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
605.	一种高效的缺陷抽检方法及系统	发明	ZL201711092655.6	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
606.	一种制备西格玛凹槽的方法	发明	ZL201711092654.1	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
607.	一种根据射频时数改善一体化刻蚀工艺面内均匀性的方法	发明	ZL201711091683.6	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
608.	一种检测静电吸盘表面颗粒污染物的方法	发明	ZL201711091677.0	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
609.	一种检测及校正晶圆与腔体载物台偏移的装置及方法	发明	ZL201711073025.4	2017-11-03	申请日起二十年	原始取得
610.	一种闪存晶圆的制作方法	发明	ZL201711057785.6	2017-10-23	申请日起二十年	原始取得

611.	一种减小 WPE 效应的标准单元库版图设计方法	发明	ZL201711050885.6	2017-10-31	申请日起二十年	原始取得
612.	一种完善光刻模型数据对测试图形覆盖范围的方法	发明	ZL201710987039.0	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
613.	浅沟槽隔离结构的形成方法	发明	ZL201710987035.2	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
614.	重复性缺陷的筛选方法	发明	ZL201710987031.4	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
615.	一种高性能输出驱动电路	发明	ZL201710986287.3	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
616.	一种自适应闪存写入操作控制方法及电路	发明	ZL201710986267.6	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
617.	一种多晶硅层桥接断路的解决方法	发明	ZL201710985194.9	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
618.	一种套刻精度点检方法	发明	ZL201710985188.3	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
619.	一种光刻辅助图形的设计方法	发明	ZL201710928912.9	2017-10-09	申请日起二十年	原始取得
620.	一种校正全局金属层工艺热点的方法	发明	ZL201710924604.9	2017-09-30	申请日起二十年	原始取得
621.	一种分裂栅的栅极形成方法	发明	ZL201710884971.0	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得

622.	源/漏的形成方法以及半导体器件的形成方法	发明	ZL201710882857.4	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得
623.	一种锗硅源漏极及其制备方法	发明	ZL201710882787.2	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得
624.	一种光罩的校正方法	发明	ZL201710861813.3	2017-09-21	申请日起二十年	原始取得
625.	一种温度的测量方法及电迁移的测试方法	发明	ZL201710822916.9	2017-09-13	申请日起二十年	原始取得
626.	一种MIP平板电容结构及其形成方法	发明	ZL201710801609.2	2017-09-07	申请日起二十年	原始取得
627.	一种针对产品量测区域缺陷监控的方法	发明	ZL201710797272.2	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
628.	一种线宽量测和问题评估的方法	发明	ZL201710797215.4	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
629.	一种离子注入机钨金属污染的监控方法	发明	ZL201710796722.6	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
630.	一种套刻误差量测和问题评估的方法	发明	ZL201710796702.9	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
631.	基于计算机辅助设计的晶圆激光标识工艺实现方法及系统	发明	ZL201710758627.7	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得

632.	适用于 TDDb 的原位侦测热点方法	发明	ZL201710757942.8	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得
633.	光刻工艺热点的整合方法	发明	ZL201710757929.2	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得
634.	一种晶圆检测方法	发明	ZL201710750267.6	2017-08-28	申请日起二十年	原始取得
635.	一种新型硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710731685.0	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
636.	一种新型硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710731223.9	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
637.	一种改善浮栅极并联电容稳定性的方法	发明	ZL201710730505.7	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
638.	一种多晶硅上接触孔粘结层异常缺陷检测方法	发明	ZL201710730497.6	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
639.	一种改善 CMOS 图像传感器刻蚀腔体金属污染的方法	发明	ZL201710702567.7	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得
640.	一种通孔的形成方法	发明	ZL201710702565.8	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得
641.	一种掩模板微尘影响评估方法和系统	发明	ZL201710701067.1	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得

642.	一种光学临近修正工艺的预处理方法	发明	ZL201710670732.5	2017-08-08	申请日起二十年	原始取得
643.	一种确定离子注入机注入角度偏差的方法	发明	ZL201710642794.5	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
644.	一种降低存储器擦写功耗的电荷泵电路	发明	ZL201710642793.0	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
645.	一种双时域动态变频测试方法	发明	ZL201710641641.9	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
646.	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710640089.1	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
647.	一种图形转角的 OPC 修正方法	发明	ZL201710636987.X	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
648.	一种浅离子注入层的 OPC 修正方法	发明	ZL201710636973.8	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
649.	一种自适应定义缺陷扫描方程式扫描区域的方法	发明	ZL201710613874.8	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得
650.	电阻模型及其修正方法	发明	ZL201710612356.4	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得
651.	一种用于闪存电路中的变容二极管结构及其制造方法	发明	ZL201710609969.2	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得

652.	一种基于改进的带隙基准结构的 上电复位电路	发明	ZL201710567419.9	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
653.	刻蚀管控系统及其管控方法和刻 蚀机台	发明	ZL201710567416.5	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
654.	一种用于聚焦离子束机台提取样 品的方法	发明	ZL201710567411.2	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
655.	一种熔断器及其制造方法	发明	ZL201710561178.7	2017-07-11	申请日起二十年	原始取得
656.	图像传感器的制备方法	发明	ZL201710494748.5	2017-06-26	申请日起二十年	原始取得
657.	一种高能离子注入工艺中形成高 深宽比隔离的方法	发明	ZL201710471715.9	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
658.	一种模拟离子注入光阻穿透深度 的模型及其建模方法	发明	ZL201710471713.X	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
659.	静电释放装置及制造方法、聚焦 离子束设备及使用方法	发明	ZL201710470999.X	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
660.	提高套刻精度的方法	发明	ZL201710458343.6	2017-06-16	申请日起二十年	原始取得
661.	一种检测晶圆表面氮化硅残留的 方法	发明	ZL201710429161.6	2017-06-08	申请日起二十年	原始取得

662.	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710420095. 6	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
663.	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710420086. 7	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
664.	一种电平转换与非电路	发明	ZL201710419522. 9	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
665.	一种减小 STI-CMP 过程中碟型凹陷的方法	发明	ZL201710401452. 4	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
666.	晶圆退火的热量补偿方法	发明	ZL201710401289. 1	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
667.	半导体芯片老化测试装置及方法	发明	ZL201710400323. 3	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
668.	一种晶圆颗粒检测系统及方法	发明	ZL201710399666. 2	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
669.	一种驱动力可配置的电荷泵电路	发明	ZL201710370115. 3	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
670.	一种光刻胶供应装置	发明	ZL201710370114. 9	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
671.	一种在氧化硅湿法刻蚀中降低硅损伤的方法	发明	ZL201710370095. X	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
672.	一种器件建模中最优器件的自动选择方法及系统	发明	ZL201710368792. 1	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得

673.	一种通孔中光刻胶蚀刻蚀量的自动调节方法	发明	ZL201710368784. 7	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
674.	晶圆缺陷的检测方法	发明	ZL201710353548. 8	2017-05-18	申请日起二十年	原始取得
675.	一种金属互连结构的制备方法	发明	ZL201710329424. 6	2017-05-11	申请日起二十年	原始取得
676.	光学邻近校正前的图形预处理方法	发明	ZL201710318782. 7	2017-05-08	申请日起二十年	原始取得
677.	计算版图中线宽固定节距不同的线条的分布的方法	发明	ZL201710318781. 2	2017-05-08	申请日起二十年	原始取得
678.	一种采用电流编程的电子可编程熔丝电路结构	发明	ZL201710312461. 6	2017-05-05	申请日起二十年	原始取得
679.	一种通过预补值来快速建立光刻工艺条件的方法	发明	ZL201710276130. 1	2017-04-25	申请日起二十年	原始取得
680.	一种电荷捕获型非易失存储器及其制作方法	发明	ZL201710272690. X	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得
681.	一种降低闪存源端导通电阻的方法	发明	ZL201710272670. 2	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得

682.	一种结合耐高压晶体管的电荷捕获型非易失存储器制作方法	发明	ZL201710272223.7	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得
683.	一种层间电容的控制方法及控制系统	发明	ZL201710229267.1	2017-04-10	申请日起二十年	原始取得
684.	一种嵌入式存储器自适应工作参数调整方法	发明	ZL201710228681.0	2017-04-10	申请日起二十年	原始取得
685.	图形光罩连接孔缺陷检查测试结构及方法	发明	ZL201710225567.2	2017-04-07	申请日起二十年	原始取得
686.	接触孔制作工艺缺陷的检查方法	发明	ZL201710225130.9	2017-04-07	申请日起二十年	原始取得
687.	实现更小线宽的光刻工艺	发明	ZL201710190157.9	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
688.	一种大尺寸拼接产品曝光方法	发明	ZL201710190123.X	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
689.	一种钳位电压电路	发明	ZL201710189260.1	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
690.	减缓晶圆边缘散焦的光刻方法	发明	ZL201710188876.7	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
691.	套刻精度补正的优化方法及系统	发明	ZL201710187899.6	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
692.	一种 EFUSE 烧写方法及烧写电路	发明	ZL201710187627.6	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
693.	一种浪涌电流控制模块及其方法	发明	ZL201710187522.0	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得

694.	版图重复单元光学邻近效应修正一致性检查方法	发明	ZL201710170707.0	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
695.	补偿由光刻镜头散射光导致曝光误差的方法	发明	ZL201710170252.2	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
696.	一种上电复位电路	发明	ZL201710169793.3	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
697.	一种监控 Ge 离子注入质量的方法	发明	ZL201710146467.0	2017-03-13	申请日起二十年	原始取得
698.	一种时钟分布网络结构及其生成方法	发明	ZL201710146090.9	2017-03-13	申请日起二十年	原始取得
699.	一种提高芯片同测数的方法	发明	ZL201710141184.7	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
700.	一种增强型 CMOS 施密特电路	发明	ZL201710141051.X	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
701.	一种光罩颗粒尺寸的评估方法	发明	ZL201710140908.6	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
702.	一种提高 SONOS 器件读取电流的方法	发明	ZL201710140796.4	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
703.	一种刻蚀方法	发明	ZL201710033545.6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
704.	图形光罩接触孔缺陷检测方法	发明	ZL201611089543.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
705.	测试结构及测试方法	发明	ZL201611087779.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得

706.	一种基于频率比较的锁定指示器	发明	ZL201611086921. X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
707.	一种基于前层图形判别的离子注入层边界的光学临近修正方法	发明	ZL201611085965. 0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
708.	WAT 机台报警引起的 lot 异常处理优化方法及系统	发明	ZL201611085624. 3	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
709.	一种半导体晶圆的测试结构	发明	ZL201611077582. 9	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
710.	一种降低热载流子劣化的电平转换电路	发明	ZL201611077581. 4	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
711.	一种改善高深宽比光刻胶形貌的结构和方法	发明	ZL201611077084. 4	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
712.	防止研磨头与研磨垫修整器相撞的装置、方法及研磨设备	发明	ZL201611076614. 3	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
713.	一种监控 CIS 像素单元相关电容的电路及方法	发明	ZL201611076611. X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
714.	一种用于优化晶圆边缘缺陷的晶圆传送方法	发明	ZL201611076590. 1	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
715.	一种电源箝位 ESD 保护电路结构	发明	ZL201611076587. X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得

716.	一种优化低功耗产品漏电流的方法	发明	ZL201611076529.7	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
717.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201611075479.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
718.	一种考虑版图环境的电阻模型提取方法及系统	发明	ZL201611061474.2	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
719.	一种应用于 PLL 的高性能 VCO 电路	发明	ZL201611061473.8	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
720.	一种电阻闪烁噪声模型的建立方法及系统	发明	ZL201611061346.8	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
721.	一种炉管尾气处理管道	发明	ZL201611059866.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
722.	一种通用版图临近效应表征模型及其提取方法	发明	ZL201611053506.4	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
723.	一种电阻子电路噪声模型结构及其建模方法	发明	ZL201611048937.1	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
724.	一种增强 OPC 处理精度的方法	发明	ZL201611047406.0	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
725.	一种用于产生二维 OPC 测试图形的方法	发明	ZL201611042085.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得

726.	一种自校准可扩展性 SRAM 延时测试电路	发明	ZL201611041043. X	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
727.	改善有源区点状腐蚀缺陷的方法	发明	ZL201611040507. 5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
728.	芯片内部动作时间的检测系统及方法	发明	ZL201611040490. 3	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
729.	一种基于理想电阻的可熔断电阻验证系统及方法	发明	ZL201611037379. 9	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
730.	一种 WAT 阈值电压测试方法及系统	发明	ZL201611031129. 4	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
731.	一种改善非对称性静电吸盘刻蚀腔体边缘缺陷的方法	发明	ZL201611028534. 0	2016-11-18	申请日起二十年	原始取得
732.	一种多步骤干法刻蚀机台颗粒监测的方法	发明	ZL201611027701. X	2016-11-01	申请日起二十年	原始取得
733.	一种 NISSIN 离子注入机台的自动化程式正确性管理方法及装置	发明	ZL201611018094. 0	2016-11-18	申请日起二十年	原始取得
734.	PMOS 器件及其集成工艺方法	发明	ZL201611017984. X	2016-11-17	申请日起二十年	原始取得
735.	电迁移测试结构	发明	ZL201611010913. 7	2016-11-17	申请日起二十年	原始取得

736.	一种动态调整安全研磨时间限的方法	发明	ZL201610993680.0	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
737.	一种上电复位电路	发明	ZL201610986873.3	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
738.	一种可探知晶圆滑动的机械臂装置	发明	ZL201610986671.9	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
739.	提高前照式 CMOS 图像传感器红光量子效率的方法及结构	发明	ZL201610985910.9	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
740.	一种集成 5 伏器件和 SONOS 存储器的制造方法	发明	ZL201610985902.4	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
741.	一种晶圆化学机械抛光保持环的清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610985516.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
742.	一种集成离子刻蚀划片槽和密封环的制造方法	发明	ZL201610985505.7	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
743.	用于钨沉积前的接触孔表面的处理方法	发明	ZL201610985481.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
744.	半导体器件及其制备方法	发明	ZL201610984921.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得

745.	消除前金属层内部缺陷导致的短路漏电的方法	发明	ZL201610984912.6	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
746.	一种炉管的氮气冷却系统及晶圆和晶舟的冷却方法	发明	ZL201610983199.3	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
747.	一种延长刻蚀腔体开腔保养时间间隔的保养方法	发明	ZL201610983032.7	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
748.	一种快速收集阈值电压分布的方法	发明	ZL201610971021.7	2016-11-01	申请日起二十年	原始取得
749.	一种化学机械研磨机台研磨压力补偿方法	发明	ZL201610957345.5	2016-10-27	申请日起二十年	原始取得
750.	恒温电迁移测试中的电流加速因子评估方法	发明	ZL201610950150.8	2016-10-26	申请日起二十年	原始取得
751.	用于封装级可靠性测试的静电防护电路和测试安装方法	发明	ZL201610949909.0	2016-10-26	申请日起二十年	原始取得
752.	一种基于 systemverilog 的 AHB 核随机验证方法	发明	ZL201610936104.2	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得

753.	药液槽承载晶圆的底座及提高槽式湿法刻蚀均匀性的方法	发明	ZL201610926005.6	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
754.	一种嵌入式闪存及其电流比较读出电路	发明	ZL201610925994.7	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
755.	一种晶圆边缘清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610925966.5	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
756.	一种优化晶圆环状缺陷的方法	发明	ZL201610924726.3	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
757.	自校准式恒温电迁移测试中的金属活化能评估方法	发明	ZL201610924546.5	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
758.	一种减少曝光焦距误差的方法	发明	ZL201610924503.7	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
759.	一种 CIS 器件及优化后段光通道工艺来降低 CIS 暗电流的方法	发明	ZL201610924437.3	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
760.	抗电磁干扰的晶振谐振回路电路	发明	ZL201610924231.0	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
761.	一种用于无电容型 LDO 的补偿电路	发明	ZL201610901016.9	2016-10-17	申请日起二十年	原始取得
762.	一种改善应力记忆工艺效果的方法	发明	ZL201610885707.4	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得

763.	一种连接孔图形光罩缺点的检测方法	发明	ZL201610884418. 2	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
764.	一种降低背照式 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201610884399. 3	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
765.	一种剥离嵌入式闪存的逻辑及 SRAM 区中浮栅结构的方法	发明	ZL201610884377. 7	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
766.	一种金属线层小尺寸冗余图形的添加和处理方法	发明	ZL201610884323. 0	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
767.	一种双向 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201610875594. X	2016-09-30	申请日起二十年	原始取得
768.	一种用于缺陷检测机台的实时侦测光阻损伤的方法	发明	ZL201610857461. X	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
769.	一种用作 ESD 保护的 GGNMOS 器件及其制作方法	发明	ZL201610854759. 5	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
770.	一种栅氧层的制备方法	发明	ZL201610854700. 6	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
771.	一种上电复位电路	发明	ZL201610852610. 3	2016-09-26	申请日起二十年	原始取得
772.	一种 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201610850755. X	2016-09-26	申请日起二十年	原始取得

773.	降低化学机械抛光工艺热点检测漏报率的方法	发明	ZL201610828347.4	2016-09-18	申请日起二十年	原始取得
774.	一种突破外观缺陷机台检测极限的方法	发明	ZL201610795422.1	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
775.	适用于各类周期性测试算法的存储器内建自测试电路	发明	ZL201610795123.8	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
776.	一种测试有源区顶部圆滑度的方法	发明	ZL201610790820.4	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
777.	一种形成 MIS 结构的方法	发明	ZL201610790816.8	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
778.	降低离子注入层光刻胶剥离风险的方法	发明	ZL201610790803.0	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
779.	一种优化 CMOS 图像传感器晶圆边缘缺陷的方法	发明	ZL201610790785.6	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
780.	提高良率提升缺陷监测效率的方法	发明	ZL201610790782.2	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
781.	电化学镀铜洗边装置以及电化学镀铜洗边方法	发明	ZL201610790760.6	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得

782.	保形沉积的薄膜厚度预测模型建立及应用方法	发明	ZL201610777684. 5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
783.	刻蚀设备以及用于去除晶背边缘薄膜的晶背边缘刻蚀方法	发明	ZL201610776793. 5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
784.	一种监控侧墙刻蚀后残留的方法	发明	ZL201610770418. X	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
785.	一种炉管的进气装置	发明	ZL201610770371. 7	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
786.	一种降低变容器最小电容的方法	发明	ZL201610766363. 5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
787.	可制造性检测分析方法	发明	ZL201610766345. 7	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
788.	一种检测浅沟槽隔离区空洞缺陷的方法	发明	ZL201610704834. X	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
789.	一种锗硅 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610704833. 5	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
790.	一种非易失存储器结构及其制作方法	发明	ZL201610704806. 8	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
791.	改善有源区边界处的栅极拐角的方法	发明	ZL201610704771. 8	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
792.	一种嵌入式闪存的电荷泵控制电路结构	发明	ZL201610704743. 6	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得

793.	一种在接触孔中制备薄膜的方法	发明	ZL201610704710.1	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
794.	一种晶圆研磨头清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610703066.6	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
795.	一种适用于低电容密度电容测试结构的版图布局方法	发明	ZL201610703053.9	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
796.	一种可调控栅增加 ILD 填充窗口的工艺方法	发明	ZL201610703052.4	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
797.	防止重掺杂的硅衬底边缘的离子析出的方法	发明	ZL201610703032.7	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
798.	一种避免电子束扫描过程中产生电弧放电的缺陷检测方法	发明	ZL201610703019.1	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
799.	半浮栅晶体管工艺方法	发明	ZL201610696009.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
800.	改善 OPC 版图处理不一致的方法	发明	ZL201610695909.2	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
801.	透射电子显微镜样品结染色的方法	发明	ZL201610694441.5	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
802.	针对多晶硅氧化物栅极缺失的电子束扫描检测方法	发明	ZL201610694386.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得

803.	多产品共晶圆流片中的几何信息提取方法	发明	ZL201610694146. X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
804.	降低金属硬质掩模大马士革一体化刻蚀缺陷生长的方法	发明	ZL201610694050. 3	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
805.	制备透射电子显微镜样品的的方法	发明	ZL201610692334. 9	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
806.	透射电子显微镜样品结染色的方法	发明	ZL201610692332. X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
807.	自加热电迁移测试结构以及晶圆级自加热电迁移测试方法	发明	ZL201610608746. X	2016-07-29	申请日起二十年	原始取得
808.	离子注入设备及监控方法	发明	ZL201610608697. X	2016-07-29	申请日起二十年	原始取得
809.	一种化学机械研磨模拟方法	发明	ZL201610606958. 4	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
810.	一种单位格点几何信息提取方法	发明	ZL201610606945. 7	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
811.	一种基于图形密度的工艺模型建模与修正方法	发明	ZL201610606942. 3	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
812.	SEN 离子注入机台的自动化程式正确性管理方法及装置	发明	ZL201610585587. 6	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
813.	用于执行版图 OPC 处理的方法	发明	ZL201610585550. 3	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得

814.	具有双外延层结构的 CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL201610585056. 7	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
815.	一种用于共源架构嵌入式闪存的字线驱动电路及其方法	发明	ZL201610584970. X	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
816.	一种改善圆晶片内膜厚均匀性的方法	发明	ZL201610584924. X	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
817.	改善闪存阵列区垫氧层刻蚀过程中硅衬底完整性的方法	发明	ZL201610510527. 8	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
818.	一种降低 ESD 风险的版图处理方法	发明	ZL201610510504. 7	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
819.	一种离子注入工艺的精确控制方法	发明	ZL201610498922. 9	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
820.	一种快速降低热板温度的方法	发明	ZL201610498921. 4	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
821.	一种量测工序的智能抽样方法及系统	发明	ZL201610498899. 3	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
822.	调节衬底表面反射率的结构及方法、光刻方法	发明	ZL201610498878. 1	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得

823.	一种离子注入层图形线宽尺寸的形成方法	发明	ZL201610498312.9	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
824.	一种优化 OPC 验证的方法	发明	ZL201610421103.4	2016-06-14	申请日起二十年	原始取得
825.	一种电化学镀铜洗边宽度的自动调节装置和自动调节方法	发明	ZL201610415928.5	2016-06-14	申请日起二十年	原始取得
826.	用于 CMP 设备上的研磨垫安装夹具装置及使用方法	发明	ZL201610370175.0	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
827.	一种光刻机的晶圆承载吸附压力优化方法	发明	ZL201610370135.6	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
828.	一种曝光条件检测方法及系统	发明	ZL201610370132.2	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
829.	一种自对准 STI 的制备方法	发明	ZL201610367958.3	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
830.	一种铜研磨方法及系统	发明	ZL201610367935.2	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
831.	一种提高 OPC 修正精度的方法	发明	ZL201610367932.9	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
832.	改善闪存浅槽嵌壁工艺缺陷的双光刻处理方法	发明	ZL201610357144.1	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
833.	防止有形貌晶圆表面刻蚀损伤的光刻刻蚀方法	发明	ZL201610357141.8	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得

834.	一种暗场缺陷检测设备自对准工艺窗口的校正方法	发明	ZL201610357127.8	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
835.	局部曝光异常缺陷自动检测方法	发明	ZL201610356816.7	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
836.	一种亮场扫描设备自动定义扫描区域的检测方法	发明	ZL201610355214.X	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
837.	一种优化 CMOS 图像传感器晶圆边缘缺陷的方法	发明	ZL201610355204.6	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
838.	一种金属层膜厚堆叠模型校准的方法及系统	发明	ZL201610355194.6	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
839.	一种离子注入机的智能工艺互锁控制方法及系统	发明	ZL201610355192.7	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
840.	一种靶材边缘之铝熔射层的检测方法	发明	ZL201610353584.X	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
841.	函括格点边缘区域图形数据的版图特征参数提取方法	发明	ZL201610327932.6	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
842.	超浅结退火方法	发明	ZL201610327931.1	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
843.	一种平面 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610327914.8	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得

844.	化学机械研磨工艺模型校准验证 流程中薄膜厚度引入方法	发明	ZL201610327878. 5	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
845.	实现多晶硅栅极平坦化的方法	发明	ZL201610327876. 6	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
846.	版图设计中的权重线宽的提 取方法	发明	ZL201610326227. 4	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
847.	基于掩模板规则限制优化光学临 近修正结果的方法	发明	ZL201610326182. 0	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
848.	一种减少光刻胶中毒的方法	发明	ZL201610323439. 7	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
849.	用于预防半导体芯片版图的天线 效应的方法	发明	ZL201610320945. 0	2016-05-13	申请日起二十年	原始取得
850.	一种离子注入层阴影效应分析结 构的形成方法	发明	ZL201610319144. 2	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
851.	一种 3D 集成电路结构及其制造 方法	发明	ZL201610319141. 9	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
852.	一种加速 WAT 测试的系统和方法	发明	ZL201610280121. 5	2016-04-29	申请日起二十年	原始取得
853.	离子注入层版图的光学修正方法	发明	ZL201610280103. 7	2016-04-29	申请日起二十年	原始取得

854.	一种使电荷泵输出电压具有多种温度系数的电路	发明	ZL201610250583. 2	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
855.	一种基于 MEEF 的 OPC 验证方法	发明	ZL201610250573. 9	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
856.	一种用于小电容失配检测及绝对值测量的电路及方法	发明	ZL201610250571. X	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
857.	阻挡介质层的刻蚀方法	发明	ZL201610250432. 7	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
858.	MOS 管阈值电压分布的测量系统及测量方法	发明	ZL201610219022. 6	2016-04-11	申请日起二十年	原始取得
859.	一种通过改变 SAB 膜质降低 CIS 器件噪声的方法	发明	ZL201610218970. 8	2016-04-11	申请日起二十年	原始取得
860.	离子注入设备的冷却单元	发明	ZL201610212943. X	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
861.	梯度压力模式改善膜厚均一性的方法	发明	ZL201610212828. 2	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
862.	测试金属线的电迁移结构	发明	ZL201610212826. 3	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
863.	一种平衡存储单元区填充与逻辑区栅氧完整性的工艺方法	发明	ZL201610212604. 1	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得

864.	利用曝光辅助图形来减少基底反射影响的方法	发明	ZL201610212558. 5	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
865.	一种确定 OPC 模型焦平面的方法	发明	ZL201610212556. 6	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
866.	一种改善晶圆翘曲度的方法	发明	ZL201610186873. 5	2016-03-29	申请日起二十年	原始取得
867.	一种改善炉管晶舟支撑脚颗粒状况的装置及方法	发明	ZL201610185803. 8	2016-03-29	申请日起二十年	原始取得
868.	控制多晶硅栅极关键尺寸均匀性的方法	发明	ZL201610173911. 3	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
869.	高电流注入机台监控方法	发明	ZL201610173716. 0	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
870.	炉管、晶片冷却方法以及自动晶舟清洁方法	发明	ZL201610173685. 9	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
871.	自动晶圆校准方法	发明	ZL201610173682. 5	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
872.	一种消除闪光退火机台首十枚效应的方法	发明	ZL201610173408. 8	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
873.	阻挡 CMOS 图像传感器 HDP 浅沟槽填充过程中金属污染的方法	发明	ZL201610173365. 3	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得

874.	针对版图设计数据改版的光刻工艺的友善性检查方法	发明	ZL201610173339.0	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
875.	一种 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610164426.X	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
876.	一种 MOSFET BSIM4 子电路器件模型及其建模方法	发明	ZL201610163792.3	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
877.	一种改善深亚微米级闪存器件耦合率的沟槽氧化物的刻蚀方法	发明	ZL201610163759.0	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
878.	一种校正电子显微镜电子束与晶圆位置偏差的方法	发明	ZL201610114691.7	2016-03-01	申请日起二十年	原始取得
879.	一种解决 HDP PSG 制程厚度均匀性持续跳高的方法	发明	ZL201610109837.9	2016-02-29	申请日起二十年	原始取得
880.	降低 CMOS 图像传感器的无金属硅化物区域接触电阻的方法	发明	ZL201610107865.7	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
881.	一种兼容不同规格之探针的探针卡	发明	ZL201610107841.1	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
882.	改善静电吸附盘树脂保护环损伤的结构及方法	发明	ZL201610107752.7	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得

883.	改善闪存产品多晶硅表面缺陷检测灵敏度的方法及结构	发明	ZL201610107730.0	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
884.	双结构接触孔同步刻蚀工艺	发明	ZL201610107729.8	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
885.	一种提升经时击穿测试有效性的方法	发明	ZL201610107358.3	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
886.	栅氧化层厚度实时监控方法	发明	ZL201610088975.3	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
887.	一种用于槽型湿法设备的干燥装置及干燥方法	发明	ZL201610088128.7	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
888.	一种验证快闪存储器隧穿氧化层可靠性的方法	发明	ZL201610088127.2	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
889.	消除比较器延迟的振荡电路	发明	ZL201510724253.8	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
890.	一种 CMOS 图像传感器的结构及其制备方法	发明	ZL201510719251.X	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
891.	一种 H3PO4 槽小换酸的控制方法	发明	ZL201510719240.1	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
892.	一种检测光刻机焦距偏移量的方法	发明	ZL201510719205.X	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
893.	一种排除电性噪声干扰的方法	发明	ZL201510716961.7	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得

894.	一种改善低介电质膜厚稳定性的方法	发明	ZL201510716951.3	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
895.	一种改善低介电质薄膜厚度稳定性的方法	发明	ZL201510716938.8	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
896.	形成源漏区外延锗硅均匀轮廓的方法	发明	ZL201510716917.6	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
897.	一种降低颗粒产生的方法	发明	ZL201510716894.9	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
898.	一种针对多晶硅层光刻版图的工艺热点检查方法	发明	ZL201510715852.3	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
899.	一种降低接触式图像传感器工作区金属污染的方法	发明	ZL201510708400.2	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
900.	一种降低接触式图像传感器工作区金属污染的方法	发明	ZL201510708385.1	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
901.	一种MOS可变电容的仿真模型建立方法和仿真方法	发明	ZL201510707912.7	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
902.	嵌入式外延锗硅层的盖帽层的制备方法	发明	ZL201510707870.7	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得

903.	嵌入式外延锗硅层的盖帽层的制 作方法	发明	ZL201510707673. 5	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
904.	研磨液供给及研磨垫整理装置、 研磨机台	发明	ZL201510707376. 0	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
905.	一种研磨垫及其更换方法	发明	ZL201510703868. 2	2015-10-26	申请日起二十年	原始取得
906.	一种保持研磨机台研磨率平衡的 方法	发明	ZL201510703181. 9	2015-10-26	申请日起二十年	原始取得
907.	用于化学机械研磨机台的固定环	发明	ZL201510683995. 0	2015-10-20	申请日起二十年	原始取得
908.	一种 TEM 芯片样品的标记方法	发明	ZL201510680560. 0	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
909.	一种 CIS 器件的制造方法	发明	ZL201510680467. X	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
910.	MIM 电容器的测试结构和测试 方法	发明	ZL201510680458. 0	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
911.	抑制浅沟槽隔离结构深度负载效 应的方法	发明	ZL201510663204. 8	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
912.	一种侦测锗硅残留的方法	发明	ZL201510663115. 3	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
913.	无深度负载效应的浅沟槽隔离结 构的制备方法	发明	ZL201510663074. 8	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得

914.	一种 SRAM 单元建模方法	发明	ZL201510663043. 2	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
915.	一种晶圆验收测试机台加压校准方法	发明	ZL201510662809. 5	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
916.	一种半导体器件电性测试方法	发明	ZL201510662806. 1	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
917.	对准精度测量的图形结构	发明	ZL201510662782. X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
918.	一种利用信息码识别的探针卡及方法	发明	ZL201510662503. X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
919.	一种避免浅沟槽隔离结构出现深度负载效应的方法	发明	ZL201510662464. 3	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
920.	一种 AL 刻蚀机台热量再利用的装置及方法	发明	ZL201510662415. X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
921.	离子注入阻挡层的制作方法	发明	ZL201510662096. 2	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
922.	一种存储器测试装置及一种存储器芯片测试方法	发明	ZL201510655029. 8	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
923.	一种消除比较器延迟和失配的振荡电路	发明	ZL201510626725. 6	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得
924.	一种光刻套准补正的方法	发明	ZL201510626687. 4	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得

925.	一种金属沟槽刻蚀方法	发明	ZL201510626669.6	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得
926.	一种偏置电压显性相关的失配模型及其提取方法	发明	ZL201510624152.3	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
927.	U形栅极的形成方法	发明	ZL201510624106.3	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
928.	一种通用失配模型及其提取方法	发明	ZL201510623395.5	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
929.	一种降低 CMOS 图像传感器白像素的集成工艺	发明	ZL201510621256.9	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
930.	通过多晶硅吸杂降低 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201510621245.0	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
931.	通过 C 离子注入降低 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201510621209.4	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
932.	通过 F 离子注入降低 CMOS 图像传感器暗电流的方法	发明	ZL201510621207.5	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
933.	一种改善晶圆形变的曝光载片台	发明	ZL201510608938.6	2015-09-22	申请日起二十年	原始取得
934.	一种漏电流的测试版图、检测结构及其检测方法	发明	ZL201510592962.5	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得

935.	一种改善晶圆边缘产品良率的方法	发明	ZL201510591788. 2	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
936.	一种栅极阵列图形的双重曝光制备方法	发明	ZL201510591374. X	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
937.	一种光学邻近效应修正离焦模型的校准方法	发明	ZL201510591365. 0	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
938.	一种制作 Sigma 型锗硅沟槽的方法	发明	ZL201510591355. 7	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
939.	一种提高器件性能均一性的方法	发明	ZL201510591338. 3	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
940.	一种扫描程式运用阈值修正进行晶圆检测的方法	发明	ZL201510591333. 0	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
941.	一种防止 TEM 芯片样品破裂的方法	发明	ZL201510578320. X	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得
942.	用于 CMOS 器件离子注入光学修正的测试结构及方法	发明	ZL201510578319. 7	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得
943.	解决高能量下连续片晶圆孤立线宽下降的方法	发明	ZL201510578270. 5	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得

944.	一种 SONOS 器件中 ONO 结构的制 造方法	发明	ZL201510547787. 8	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
945.	一种晶圆边缘产品良率的改 善方法	发明	ZL201510547779. 3	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
946.	常压炉管生长的薄膜厚度的控制 方法	发明	ZL201510546241. 0	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
947.	高深宽比结构的光刻胶填充方法	发明	ZL201510546180. 8	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
948.	一种制备 TEM 芯片样品的方法	发明	ZL201510532705. 2	2015-08-26	申请日起二十年	原始取得
949.	电迁移测试结构及测试方法	发明	ZL201510532704. 8	2015-08-26	申请日起二十年	原始取得
950.	用于减少高浓度外延工艺中的位 错缺陷的方法和系统	发明	ZL201510524163. 4	2015-08-24	申请日起二十年	原始取得
951.	一种互连寄生电阻电容校准结构	发明	ZL201510514462. X	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
952.	CMOS 器件工艺中锗硅外延层的制 备方法	发明	ZL201510514447. 5	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
953.	一种集成电路分析中透射电镜平 面样品的制备方法	发明	ZL201510514446. 0	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得

954.	一种双位 SONOS 存储器及其编译、擦除和读取方法	发明	ZL201510514435. 2	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
955.	一种 N 沟道非易失性闪存器件及其编译、擦除和读取方法	发明	ZL201510514392. 8	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
956.	一种栅氧化层缺陷的分析方法	发明	ZL201510514373. 5	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
957.	一种防止 I/O 电路不确定态的上电检测电路	发明	ZL201510514279. X	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
958.	预估 MEEF 较大图形的方法及系统	发明	ZL201510497384. 7	2015-08-13	申请日起二十年	原始取得
959.	多管路液体气化反应成膜设备气流控制方法	发明	ZL201510494546. 1	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
960.	一种 Σ 型结构的半浮栅器件的制造方法	发明	ZL201510494525. X	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
961.	光刻生产控制方法	发明	ZL201510493961. 5	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
962.	一种 TEM 样品制备方法	发明	ZL201510493945. 6	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
963.	一种引线键合去除的方法	发明	ZL201510493865. 0	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得

964.	金属硬掩模一体化刻蚀中桥接位置的检测方法	发明	ZL201510489081.0	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
965.	弯折探针及其治具	发明	ZL201510489059.6	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
966.	栅极硬掩模层的去除方法	发明	ZL201510489041.6	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
967.	一种避免光刻机镜头过热的方法	发明	ZL201510489028.0	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
968.	抑制反短沟道效应的方法及 NMOS 器件制备方法	发明	ZL201510488879.3	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
969.	一种基于多曝光程序的多硅片循环运动方法	发明	ZL201510488878.9	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
970.	一种平面 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201510487953.X	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
971.	超薄栅氧的制备方法	发明	ZL201510487665.4	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
972.	一种引入套刻误差的光刻工艺规则检查方法	发明	ZL201510460417.0	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
973.	一种自动放行 WAT PM 探针卡的系统及方法	发明	ZL201510460280.9	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
974.	一种双浅沟槽隔离形成方法	发明	ZL201510460278.1	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
975.	一种栅介质层的制备方法	发明	ZL201510460277.7	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得

976.	一种晶圆支撑件的清洗装置及清洗方法	发明	ZL201510460195. 2	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
977.	一种重复单元结构 TEM 样品的定位方法	发明	ZL201510460194. 8	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
978.	一种在线测试半导体器件衬底	发明	ZL201510459334. X	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
979.	一种避免在形成金属硅化物工艺中接触孔尺寸偏移的方法	发明	ZL201510459314. 2	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
980.	一种集成电路芯片反向工程的定位方法	发明	ZL201510459284. 5	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
981.	栅极区域的光学临近修正验证方法	发明	ZL201510456589. 0	2015-07-29	申请日起二十年	原始取得
982.	离子注入层光刻胶膜厚的优化方法	发明	ZL201510456455. 9	2015-07-29	申请日起二十年	原始取得
983.	针对特定重复图形的光学临近效应修正方法	发明	ZL201510435966. 2	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
984.	一种同时形成一维和二维光刻胶图形的方法	发明	ZL201510435960. 5	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得

985.	通过优化电荷释放步骤工艺条件改善球状缺陷的方法	发明	ZL201510435956.9	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
986.	一种测试 SRAM 共享接触孔与多晶硅接触电阻的结构	发明	ZL201510435944.6	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
987.	一种晶圆反应腔室及晶圆反应腔室之晶圆保护方法	发明	ZL201510435942.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
988.	一种测试 SRAM 共享接触孔与有源区接触电阻的结构	发明	ZL201510435916.4	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
989.	金属电迁移测试结构以及金属电迁移测试方法	发明	ZL201510435910.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
990.	进出气装置、具有进出气装置之热处理机台及进出气方法	发明	ZL201510435906.0	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
991.	形成不同深度沟槽的集成电路制造方法	发明	ZL201510435897.5	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
992.	晶圆测试管理系统及方法	发明	ZL201510435476.2	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
993.	一种同时形成一维和二维光刻胶图形的方法	发明	ZL201510435445.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得

994.	一种 SPC 策略自动更新方法及 SPC 自动策略系统	发明	ZL201510435372. 1	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
995.	一种半导体工艺生产线的派工方法及系统	发明	ZL201510435344. X	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
996.	掩模板表面微尘去除装置及除尘方法	发明	ZL201510435342. 0	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
997.	一种节省光罩的 CMOS 阱形成方法	发明	ZL201510430138. X	2015-07-21	申请日起二十年	原始取得
998.	一种双位无结闪存存储器及其编程、擦除和读取方法	发明	ZL201510422547. 5	2015-07-17	申请日起二十年	原始取得
999.	金属氧化物金属电容器制作方法	发明	ZL201510375658. 5	2015-06-30	申请日起二十年	原始取得
1000.	针对晶圆晶边的化学气相沉积工艺腔及化学气相沉积方法	发明	ZL201510375630. 1	2015-06-30	申请日起二十年	原始取得
1001.	刻蚀映射关系模型和控制浅槽隔离刻蚀关键尺寸的方法	发明	ZL201510369469. 7	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1002.	侧墙的形成方法	发明	ZL201510369468. 2	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得

1003.	改善磷硅玻璃中磷分布均匀性的方法	发明	ZL201510369420.1	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1004.	双层套刻精度控制层次管理的方法、校准标记及测量系统	发明	ZL201510369337.4	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1005.	一种镍硅化物的形成方法	发明	ZL201510369145.3	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1006.	一种探针卡	发明	ZL201510367325.8	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1007.	一种掩膜板及孤立孔寻址图形在测量中的应用方法	发明	ZL201510367319.2	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1008.	一种制作镍硅化物的方法	发明	ZL201510367130.3	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1009.	一种镍硅化物的优化方法	发明	ZL201510367108.9	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1010.	一种镍硅化物的制作方法	发明	ZL201510367094.0	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1011.	一种跨导恒定的差分对输入电路	发明	ZL201510309771.3	2015-06-08	申请日起二十年	原始取得
1012.	一种控制静电吸盘吸力的方法	发明	ZL201510277990.8	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1013.	一种基于动态电压衬度分析的样品制备方法	发明	ZL201510277921.7	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1014.	一种用于器件建模的标准单元选择方法	发明	ZL201510277904.3	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得

1015.	一种金属硬质掩模一体化刻蚀通孔过刻蚀量的检测方法	发明	ZL201510277903.9	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1016.	一种降低图像传感器暗电流的方法	发明	ZL201510277901.X	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1017.	一种晶圆曝光顺序的优化方法	发明	ZL201510277863.8	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1018.	探针针痕位置的检测系统及方法	发明	ZL201510277862.3	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1019.	一种混合晶向无结 CMOS 结构	发明	ZL201510276547.9	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1020.	光刻抗反射层的离线监控方法	发明	ZL201510272206.4	2015-05-25	申请日起二十年	原始取得
1021.	通过工艺集成优化减小半导体器件性能调试难度的方法	发明	ZL201510249105.5	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
1022.	一种改善不同晶片之间有源区关键尺寸差异的方法	发明	ZL201510249102.1	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
1023.	一种提高芯片去层次时均匀度的方法	发明	ZL201510248913.X	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
1024.	减少聚合物产生的光刻化学品喷涂系统及控制方法	发明	ZL201510225370.X	2015-05-04	申请日起二十年	原始取得
1025.	一种离子注入机的剂量匹配方法	发明	ZL201510216741.8	2015-04-30	申请日起二十年	原始取得

1026.	一种刻蚀反应腔体的清洁方法	发明	ZL201510213483.8	2015-04-29	申请日起二十年	原始取得
1027.	一种嵌入式锗硅结构的制作方法	发明	ZL201510213373.1	2015-04-29	申请日起二十年	原始取得
1028.	一种监控光刻机台稳定性的方法及系统	发明	ZL201510199044.6	2015-04-23	申请日起二十年	原始取得
1029.	一种透射电镜样品的制备方法及定位方法	发明	ZL201510199043.1	2015-04-23	申请日起二十年	原始取得
1030.	一种铜互连的制备方法	发明	ZL201510198901.0	2015-04-22	申请日起二十年	原始取得
1031.	一种 SONOS 双栅闪存器件及其编译方法	发明	ZL201510198895.9	2015-04-22	申请日起二十年	原始取得
1032.	用于使用保形填充层改善器件表面均匀性的方法和系统	发明	ZL201510189718.4	2015-04-20	申请日起二十年	原始取得
1033.	等离子体刻蚀装置及提高硅钴镍刻蚀效率的方法	发明	ZL201510174002.7	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1034.	一种 Flash 产品的 ONO 薄膜缺陷的失效分析方法	发明	ZL201510174001.2	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1035.	降低多孔 low-k 材料的 k 值的互连工艺	发明	ZL201510173995.6	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得

1036.	钴阻挡层的形成方法和金属互连工艺	发明	ZL201510173198.8	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1037.	光刻对准标记结构及其制造方法	发明	ZL201510149621.0	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1038.	一种气体喷嘴	发明	ZL201510149062.3	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1039.	一种掩膜版装载盒	发明	ZL201510149035.6	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1040.	改善 ArF 光阻在硅片表面上的黏附性的方法	发明	ZL201510149034.1	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1041.	晶片刻蚀腔室的清洗方法	发明	ZL201510145288.6	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1042.	集成目标图形优化与光学邻近修正的方法	发明	ZL201510144598.6	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1043.	接触孔的形成方法	发明	ZL201510144276.1	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1044.	一种解决光罩图形单元 ESD 现象的处理方法	发明	ZL201510144260.0	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1045.	检测刻蚀负载效应的方法	发明	ZL201510144256.4	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1046.	一种基于模型的离子析出缺陷改善方法	发明	ZL201510144225.9	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1047.	一种晶圆边缘缺陷的检测方法	发明	ZL201510144223.X	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得

1048.	根据集成电路制程能力指数自动调整抽检频率的量测方法	发明	ZL201510144222.5	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1049.	一种 TEM 样品制备方法	发明	ZL201510144200.9	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1050.	一种提高二维图形解析度的工艺方法	发明	ZL201510144159.5	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1051.	栅氧层缺陷检测方法及其器件漏电检测方法	发明	ZL201510144158.0	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1052.	一种通过显微镜法实现纳米级套刻精度的方法	发明	ZL201510133717.8	2015-03-25	申请日起二十年	原始取得
1053.	一种浮栅闪存器件及其编译方法	发明	ZL201510128242.3	2015-03-23	申请日起二十年	原始取得
1054.	晶圆可接受性测试机台内部环境的监测方法和监测装置	发明	ZL201510128230.0	2015-03-23	申请日起二十年	原始取得
1055.	一种监控电子显微镜真空腔体洁净度的方法	发明	ZL201510126619.1	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1056.	一种检测接触孔过度刻蚀的方法	发明	ZL201510126618.7	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1057.	相邻两个同电位通孔的光学临近修正方法	发明	ZL201510126616.8	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得

1058.	一种侦测图形底部光刻胶残留的缺陷检测方法	发明	ZL201510126604.5	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1059.	具有用于嵌入锗材料的成形腔的半导体器件及其双沟槽制造工艺	发明	ZL201510079521.5	2015-02-13	申请日起二十年	原始取得
1060.	具有用于嵌入锗材料的成形腔的半导体器件及其制造工艺	发明	ZL201510079513.0	2015-02-13	申请日起二十年	原始取得
1061.	嵌入式 SiGe 外延测试块的设计	发明	ZL201510050661.X	2015-01-30	申请日起二十年	原始取得
1062.	用于改善 SiGe 厚度的均匀性的方法和系统	发明	ZL201510035496.0	2015-01-23	申请日起二十年	原始取得
1063.	一种 UV 处理机台工艺性能的日常检查方法	发明	ZL201410714988.8	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1064.	一种接触孔刻蚀装置及刻蚀方法	发明	ZL201410714909.3	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1065.	ONO 介质层的制备方法	发明	ZL201410714893.6	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1066.	消除多晶硅刻蚀工艺中多晶硅残余的方法	发明	ZL201410714842.3	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1067.	一种光刻工艺热点的自动修复方法	发明	ZL201410714799.0	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得

1068.	一种改善金属硅化物的方法	发明	ZL201410714798.6	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1069.	一种测定薄膜研磨速率的方法	发明	ZL201410710267.X	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1070.	一种改善金属硅化物的方法	发明	ZL201410710161.X	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1071.	一种离子注入机的预处理方法	发明	ZL201410710134.2	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1072.	嵌入式碳化硅的制备方法	发明	ZL201410697561.1	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1073.	改善 SiGe CMOS 工艺中 PMOS 器件的电学性能的方法	发明	ZL201410697473.1	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1074.	一种采用存储器监测器件制程余量的方法	发明	ZL201410697305.2	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1075.	嵌入式锗硅器件的制作方法	发明	ZL201410693124.2	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1076.	一种 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201410692996.7	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1077.	DC-DC 转换电路	发明	ZL201410692975.5	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1078.	NMOS 器件的硅衬底表面的处理方法及 NMOS 器件的制作方法	发明	ZL201410664725.0	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得
1079.	改善浅沟槽隔离边缘 SiC 应力性能的方法	发明	ZL201410664592.7	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得
1080.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201410664315.6	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得

1081.	晶圆净化装置、刻蚀机台及大马士革刻蚀方法	发明	ZL201410654598. 6	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1082.	一种闪存器件及其编程方法	发明	ZL201410654597. 1	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1083.	一种 SONOS 闪存器件的编译方法	发明	ZL201410654584. 4	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1084.	一种浮栅闪存器件及其编程方法	发明	ZL201410654582. 5	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1085.	一种 SONOS 闪存器件及其编译方法	发明	ZL201410654511. 5	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1086.	一种降低源极和漏极电阻的方法	发明	ZL201410654365. 6	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1087.	降低源极和漏极电阻的结构和方法	发明	ZL201410654361. 8	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1088.	一种静电吸盘性能的监测方法	发明	ZL201410652825. 1	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1089.	一种接触孔关键尺寸的控制方法	发明	ZL201410652823. 2	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1090.	根据特殊电路结构脱落缺陷确定可疑工艺步骤的方法	发明	ZL201410629236. 1	2014-11-10	申请日起二十年	原始取得
1091.	后段铜互连工艺中降低通孔间介质材料的 K 值的方法	发明	ZL201410625362. X	2014-11-07	申请日起二十年	原始取得

1092.	改善浅沟槽隔离边缘 SiC 应力性能的方法	发明	ZL201410619982. 2	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1093.	SiGe 源漏 MOS 器件制造方法	发明	ZL201410619373. 7	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1094.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201410618097. 2	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1095.	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	发明	ZL201410597402. 4	2014-10-29	申请日起二十年	原始取得
1096.	背面探测式光子辐射显微镜装置及测试方法	发明	ZL201410597388. 8	2014-10-29	申请日起二十年	原始取得
1097.	一种调节高压器件电性的多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201410522341. 5	2014-09-30	申请日起二十年	原始取得
1098.	改善 HCD 氮化硅沉积工艺的应力缺陷的方法	发明	ZL201410520740. 8	2014-09-30	申请日起二十年	原始取得
1099.	浅沟槽隔离的制造方法	发明	ZL201410491604. 0	2014-09-24	申请日起二十年	原始取得
1100.	一种探针卡清针装置	发明	ZL201410491591. 7	2014-09-24	申请日起二十年	原始取得
1101.	铜互连的扩散阻挡层、半导体器件及其制造方法	发明	ZL201410487739. X	2014-09-23	申请日起二十年	原始取得
1102.	一种用于制备等离子氮化栅极介质层的方法	发明	ZL201410443794. 9	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得

1103.	高深宽比沟槽刻蚀残留缺陷的检测方法	发明	ZL201410443792. X	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1104.	改善亮场机台缺陷扫描精度的方法	发明	ZL201410443791. 5	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1105.	消息中间件的监控系统	发明	ZL201410443404. 8	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1106.	一种接触孔可靠性测试装置	发明	ZL201410443389. 7	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1107.	一种对图形结构刻蚀能力的检测方法	发明	ZL201410441474. X	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1108.	一种用于缺陷分类的光学检测方法	发明	ZL201410441473. 5	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1109.	一种检测离子阱注入形貌对器件性能影响的方法	发明	ZL201410441471. 6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1110.	一种清洗设备颗粒监控的方法	发明	ZL201410441448. 7	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1111.	预防机台偏移对产品造成机械刮伤的方法	发明	ZL201410441418. 6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1112.	一种提高外延机台产能的装置与方法	发明	ZL201410440501. 1	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得

1113.	一种刻蚀装置与方法	发明	ZL201410440490. 7	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1114.	改善晶圆边缘缺陷的装置	发明	ZL201410440477. 1	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1115.	样品座	发明	ZL201410440457. 4	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1116.	一种检测图形尺寸对离子阱形貌影响的方法	发明	ZL201410440456. X	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1117.	一种检测扫描机台的性能方法	发明	ZL201410440447. 0	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1118.	一种光罩图形缺陷检测系统及方法	发明	ZL201410440440. 9	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1119.	减少修正迭代次数的 OPC 方法	发明	ZL201410428712. 3	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1120.	n 沟道 SONOS 器件及其编译方法	发明	ZL201410428695. 3	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1121.	一种双接触孔刻蚀停止层的制作方法	发明	ZL201410428687. 9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1122.	用于镍硅合金化工艺的阻挡层的制备方法	发明	ZL201410428597. X	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1123.	改善激光退火热分布的方法	发明	ZL201410428585. 7	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1124.	一种光罩自动派工控制方法及控制系统	发明	ZL201410428244. X	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得

1125.	n 沟道非易失性存储元件及其编译方法	发明	ZL201410427477. 8	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1126.	SONOS 闪存器件及其编译方法	发明	ZL201410427471. 0	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1127.	闪存器件的编程方法	发明	ZL201410427436. 9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1128.	一种提高钴阻挡层沉积选择比的方法	发明	ZL201410427394. 9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1129.	电子束缺陷扫描装置及方法	发明	ZL201410414994. 1	2014-08-21	申请日起二十年	原始取得
1130.	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201410414597. 4	2014-08-21	申请日起二十年	原始取得
1131.	梯度式干法去胶方法	发明	ZL201410412283. 0	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1132.	静态存储器的检测设备及检测方法	发明	ZL201410411989. 5	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1133.	一种修复超低介质常数薄膜侧壁损伤的方法	发明	ZL201410411975. 3	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1134.	一种减少超低介质常数薄膜侧壁损伤的方法	发明	ZL201410411972. X	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1135.	一种防止化学机械研磨时微观刮伤的研磨方法	发明	ZL201410411838. X	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得

1136.	形成浅沟槽隔离结构的方法	发明	ZL201410410384. 4	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1137.	末端射程损伤的检测以及修复方法	发明	ZL201410403765. X	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1138.	图形预处理方法以及测量图形密度的方法	发明	ZL201410403759. 4	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1139.	改善 PMOS 器件性能的离子注入方法	发明	ZL201410403757. 5	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1140.	用于多孔低介电常数材料的光固化工艺方法	发明	ZL201410403729. 3	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1141.	改善多孔低介电常数材料垂直均匀性的方法	发明	ZL201410403327. 3	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1142.	半导体制造过程的监控方法及半导体生产方法	发明	ZL201410390822. 5	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1143.	根据图形特征对自动聚焦光强进行补偿的缺陷检测方法	发明	ZL201410390806. 6	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1144.	湿法清洗工艺设备颗粒监控方法	发明	ZL201410390799. X	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得

1145.	一种提高同测数的新型测试开发方法	发明	ZL201410390798.5	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1146.	通过刻蚀不足缺陷检测多晶硅与连接孔对准度的方法	发明	ZL201410390797.0	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1147.	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	发明	ZL201410390784.3	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1148.	通过栅氧的双氧化提高栅氧均匀性的方法	发明	ZL201410390774.X	2014-09-18	申请日起二十年	原始取得
1149.	一种产品通孔刻蚀缺陷的检测方法	发明	ZL201410377465.9	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1150.	半导体器件缺陷的光学检测方法	发明	ZL201410377459.3	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1151.	晶圆缺陷监控方法	发明	ZL201410377374.5	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1152.	静态存储器的在线失效分析及在线电子束检测设备	发明	ZL201410377359.0	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1153.	量测群组设备及量测方法	发明	ZL201410377345.9	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1154.	一种对缺陷进行选择检测的方法	发明	ZL201410377341.0	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得

1155.	一种具有凸面栅极结构的 B4-Flash	发明	ZL201410375182.0	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1156.	一种有效验证探针卡异常的方法	发明	ZL201410374767.0	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1157.	气体过滤方法	发明	ZL201410374698.3	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1158.	一种具有凸面栅极结构的 B4-Flash	发明	ZL201410374646.6	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1159.	一种无结晶体管	发明	ZL201410374634.3	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1160.	用于制作嵌入式锗硅的方法	发明	ZL201410374256.9	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1161.	曝光辅助图形的优化方法	发明	ZL201410371051.5	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1162.	一种透射电镜样品的制备方法	发明	ZL201410370914.7	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1163.	测试结构及其测试方法	发明	ZL201410369986.X	2014-07-30	申请日起二十年	原始取得
1164.	浅沟槽隔离的工艺方法	发明	ZL201410359893.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1165.	CMOS 中 P 型源漏离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357338.2	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1166.	P 型轻掺杂离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357335.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得

1167.	N 型轻掺杂离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357285. 4	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1168.	利用同型结监控 N 型源漏离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357283. 5	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1169.	恒温测试系统及温度监测方法	发明	ZL201410357245. X	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1170.	一种通孔刻蚀不足的检测方法	发明	ZL201410357244. 5	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1171.	利用同型结监控 N 型轻掺杂离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357242. 6	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1172.	一种改善通孔刻蚀后晶圆表面微环境的方法	发明	ZL201410357201. 7	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1173.	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201410357183. 2	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1174.	CMOS 中 N 型源漏注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357182. 8	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1175.	利用同型结监控 P 型轻掺杂离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357174. 3	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1176.	负偏压温度不稳定性评估方法	发明	ZL201410357130. 0	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1177.	一种通孔刻蚀不足的检测方法	发明	ZL201410357129. 8	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得

1178.	形成浅沟槽隔离结构的方法	发明	ZL201410357127.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1179.	一种消除连接孔刻蚀副产物凝结缺陷的晶圆净化设备	发明	ZL201410357115.6	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1180.	炉管清洗工艺	发明	ZL201410356934.9	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1181.	监控图形晶片栅极氧化层表面的方法	发明	ZL201410356924.5	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1182.	监控图形晶片栅极氧化层表面的方法	发明	ZL201410356373.2	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1183.	减少自对准硅化镍尖峰缺陷和管道缺陷的方法	发明	ZL201410331759.8	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1184.	半导体制造的多平行动态流程控制方法	发明	ZL201410331742.2	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1185.	晶圆边缘非晶碳薄膜清除装置及方法	发明	ZL201410331729.7	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1186.	测试结构的断路定位方法	发明	ZL201410331726.3	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1187.	OPC 修正方法	发明	ZL201410331704.7	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得

1188.	消除晶圆曝光失焦缺陷的吸盘及方法	发明	ZL201410321501. X	2014-07-08	申请日起二十年	原始取得
1189.	半导体工艺方法以及半导体结构	发明	ZL201410315127. 2	2014-07-03	申请日起二十年	原始取得
1190.	并行测试系统及其测试方法	发明	ZL201410307559. 9	2014-06-30	申请日起二十年	原始取得
1191.	干氧扩散过程中氧在硅基片中扩散系数的确定方法	发明	ZL201410306975. 7	2014-06-30	申请日起二十年	原始取得
1192.	一种解决 TEOS 机台保养后颗粒跳高的方法	发明	ZL201410286826. 9	2014-06-24	申请日起二十年	原始取得
1193.	浸没式光刻工艺方法	发明	ZL201410276008. 0	2014-06-19	申请日起二十年	原始取得
1194.	掩膜板图形的形成方法和光刻及刻蚀方法	发明	ZL201410275987. 8	2014-06-19	申请日起二十年	原始取得
1195.	电击穿测试结构	发明	ZL201410274268. 4	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1196.	半导体器件的制备方法	发明	ZL201410273962. 4	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1197.	半导体生产约束管控方法	发明	ZL201410273947. X	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1198.	SONOS B4-flash 存储器	发明	ZL201410273620. 2	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1199.	一种提高图形搜索准确率的方法	发明	ZL201410273618. 5	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1200.	一种晶圆横向水平对准的方法	发明	ZL201410273408. 6	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得

1201.	一种晶圆边缘找平的方法	发明	ZL201410273168. X	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1202.	光刻机对准性能的检测方法	发明	ZL201410261079. 3	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1203.	一种在线确定光刻工艺窗口的方法	发明	ZL201410261076. X	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1204.	铝刻蚀工艺用聚焦环、铝刻蚀工艺	发明	ZL201410260820. 4	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1205.	晶圆曝光布局的优化方法	发明	ZL201410260817. 2	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1206.	一种用于光刻胶厚度摆动曲线测试的硅片及制作方法	发明	ZL201410260816. 8	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1207.	离子注入层图形线宽尺寸的优化方法	发明	ZL201410260767. 8	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1208.	机台之机械手臂偏移的检测装置及其检测方法	发明	ZL201410258529. 3	2014-06-11	申请日起二十年	原始取得
1209.	小尺寸样品层次去除方法	发明	ZL201410254088. X	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1210.	一种低功耗高稳定性的复位电路	发明	ZL201410254082. 2	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1211.	一种采用双侧墙工艺形成超低尺寸图形的方法	发明	ZL201410253948. 8	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得

1212.	SRAM 版图的生成方法	发明	ZL201410253555.7	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1213.	利用氮注入改善锗硅选择性外延的侧墙淀积问题的方法	发明	ZL201410253551.9	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1214.	PMOS 器件漏电测量方法	发明	ZL201410253237.0	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1215.	一种采用双侧墙工艺形成超低尺寸图形的方法	发明	ZL201410253213.5	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1216.	通孔链结构的失效分析方法	发明	ZL201410253207.X	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1217.	半导体芯片失效分析的方法	发明	ZL201410253203.1	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1218.	一种化学机械研磨后的清洗装置	发明	ZL201410228259.1	2014-05-27	申请日起二十年	原始取得
1219.	铜互连大马士革工艺方法	发明	ZL201410217938.9	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1220.	金属互连结构及其制造方法	发明	ZL201410217927.0	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1221.	一次性可编程器件的制造方法	发明	ZL201410217798.5	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1222.	侧墙结构、侧墙结构的制备方法、CMOS 器件	发明	ZL201410217721.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1223.	辅助图形的设计方法、测试版图的制作方法、光刻方法	发明	ZL201410217697.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得

1224.	一种优化离子注入区域形貌的方法	发明	ZL201410217696. 3	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1225.	锁存比较器	发明	ZL201410217637. 6	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1226.	一种内介电层的制备方法	发明	ZL201410217636. 1	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1227.	一种监控电子显微镜化学油污污染的方法	发明	ZL201410216685. 3	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1228.	应用晶边扫描预防线状分布缺陷发生的方法	发明	ZL201410216683. 4	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1229.	一种消除晶边颗粒残留的铝刻蚀前置工艺方法	发明	ZL201410215840. X	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1230.	离子注入设备及离子注入方法	发明	ZL201410215837. 8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1231.	一种改善晶圆尖峰退火均一性的校准方法	发明	ZL201410215824. 0	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1232.	单电容振荡器	发明	ZL201410215811. 3	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1233.	高粘度光刻胶的涂布方法、光刻方法	发明	ZL201410215788. 8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得

1234.	一种探针卡探针的颗粒物清洁控制方法	发明	ZL201410215781.6	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1235.	金属互连线拼接版图结构	发明	ZL201410193170.6	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1236.	一种低介电常数薄膜的成膜方法	发明	ZL201410193144.3	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1237.	一种形成低介电常数薄膜及其缓冲层的成膜方法	发明	ZL201410193143.9	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1238.	氧化硅薄膜制备方法	发明	ZL201410192908.7	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1239.	硅通孔绝缘层制备方法	发明	ZL201410192894.9	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1240.	金属硬掩膜结构、制造方法及铜互连结构制造方法	发明	ZL201410192846.X	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1241.	一种用于硅通孔形貌修正的SiCoNi蚀刻方法	发明	ZL201410192806.5	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1242.	测试结构及其版图生成方法	发明	ZL201410182131.6	2014-04-30	申请日起二十年	原始取得
1243.	一种传输晶体管结构	发明	ZL201410174842.9	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1244.	一种浅沟槽氧化物空洞和浮栅极多晶硅凹点的消除方法	发明	ZL201410174759.1	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1245.	一种有源区制备方法	发明	ZL201410174736.0	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得

1246.	一种用于光阻喷嘴的清洗槽体结构及其应用	发明	ZL201410174612. 2	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1247.	一种栅极侧墙减薄工艺	发明	ZL201410174441. 3	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1248.	一个光罩内的单元芯片存在不同图像条件的缺陷扫描方法	发明	ZL201410173942. X	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1249.	晶圆回收方法	发明	ZL201410164593. 5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1250.	一种半导体炉管的晶舟	发明	ZL201410164143. 6	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1251.	一种缺陷检测和观察设备的位置同步方法	发明	ZL201410164124. 3	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1252.	用于预防封装时测试结构短路的保护环和封装测试方法	发明	ZL201410164122. 4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1253.	一种新的芯片测试结构	发明	ZL201410164090. 8	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1254.	一种消除有源区损伤的多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201410164086. 1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1255.	一种离子注入倾角的日常监控方法	发明	ZL201410164080. 4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

1256.	一种采用温度模型进行曲线拟合的方法	发明	ZL201410164079. 1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1257.	一种快速退火装置的监控方法	发明	ZL201410164077. 2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1258.	一种闪存的存储单元栅极制备方法	发明	ZL201410164074. 9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1259.	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201410164057. 5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1260.	一种套刻精度测量的图像结构及其套刻精度测量方法	发明	ZL201410164035. 9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1261.	一种管理设备状态转换关系的方法	发明	ZL201410163886. 1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1262.	一种提高光刻工艺窗口的版图处理方法	发明	ZL201410163857. 5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1263.	一种研磨盘装置	发明	ZL201410163591. 4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1264.	一种集成电路缺陷的分析方法	发明	ZL201410163560. 9	2014-07-28	申请日起二十年	原始取得
1265.	降低多晶硅栅极与活化区镍硅化物厚度比的方法	发明	ZL201410163504. 5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1266.	晶圆测试结果图标记修改方法	发明	ZL201410163495. X	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

1267.	电流检测电路及包括该电流检测电路的电流环控制电路	发明	ZL201410163453.6	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1268.	一种降低在线 WAT 测试对铜互连可靠性影响的方法	发明	ZL201410163450.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1269.	链式通孔结构样品处理方法及失效测试方法	发明	ZL201410163436.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1270.	降低多晶硅栅极与活化区镍硅化物厚度比的方法	发明	ZL201410162899.7	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1271.	改善器件负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201410162847.X	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1272.	用于监控炉管无氧氛围的监控片、制造方法及其监控方法	发明	ZL201410162818.3	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1273.	降低手机时间管理模块漏电的工艺改进方法	发明	ZL201410162700.0	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1274.	一种多晶硅上小尺寸图形结构的制备方法	发明	ZL201410161318.8	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1275.	一种激光脉冲退火方法	发明	ZL201410161316.9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

1276.	一种底部无负载的自对准双层图形的制作方法	发明	ZL201410161257. 5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1277.	一种监控离子注入机稳定性和均匀性的方法	发明	ZL201410161246. 7	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1278.	围栅型纳米线晶体管	发明	ZL201410145600. 7	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1279.	离子注入浓度的校准方法	发明	ZL201410141310. 5	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1280.	延长超低介电常数材料的工艺等待时间的方法	发明	ZL201410138998. 1	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1281.	一种改进接触孔线宽均一性的刻蚀方法	发明	ZL201410138996. 2	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1282.	闪存存储器	发明	ZL201410138977. X	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1283.	浸润式光刻机浸润部件的自动清洗装置和清洗方法	发明	ZL201410127033. 2	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1284.	等离子体刻蚀装置的腔体清洗方法	发明	ZL201410127005. 0	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1285.	离线机台利用率计算系统及计算方法	发明	ZL201410126994. 1	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得

1286.	透射电镜样品的制备方法	发明	ZL201410126975.9	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1287.	PMOS 制造工艺中减少 e-SiGe 晶格缺陷的方法	发明	ZL201410125554.4	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1288.	用于清洗半导体晶圆的清洗槽	发明	ZL201410125553.X	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1289.	一种添加冗余图形的方法	发明	ZL201410125546.X	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1290.	原子力显微镜探针装置	发明	ZL201410118223.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1291.	晶圆良率监测方法	发明	ZL201410118221.9	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1292.	原子力显微镜探针装置	发明	ZL201410118215.3	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1293.	一种半导体制造试验工艺流程的建立方法	发明	ZL201410118200.7	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1294.	一种多晶硅层器件辅助图形的绘制方法	发明	ZL201410118199.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1295.	一种双栅氧的制备方法	发明	ZL201410118197.9	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1296.	一种智能探针卡针压控制系统及控制方法	发明	ZL201410118188.X	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1297.	多晶硅残留监测结构	发明	ZL201410117788.4	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1298.	PMOS 器件的制造方法	发明	ZL201410117766.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得

1299.	一种与激光退火工艺问题相关的排除硅片质量因素的方法	发明	ZL201410117759.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1300.	一种多通道管控工艺流程的设计方法	发明	ZL201410117735.2	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1301.	一种智能化选择性目标尺寸调整方法	发明	ZL201410111322.3	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1302.	用于 NDC 薄膜的离线监控方法	发明	ZL201410111309.8	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1303.	一种 NAND 闪存器件及其制造方法	发明	ZL201410111308.3	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1304.	探针卡识别芯片安装方法	发明	ZL201410111293.0	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1305.	晶圆后段电容电性测试结构	发明	ZL201410111285.6	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1306.	层间介质层性能的测试结构和测试方法	发明	ZL201410110743.4	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1307.	双层栅介质层结构及其制备方法	发明	ZL201410110065.1	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1308.	对准图形及晶圆	发明	ZL201410110062.8	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1309.	P 型沟道闪存器件及其制造方法	发明	ZL201410110060.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1310.	用于 WAT 测试的半导体结构	发明	ZL201410110056.2	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得

1311.	监测方法	发明	ZL201410109846.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1312.	离子注入层的光学临近效应修正方法	发明	ZL201410109835.0	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1313.	监测氧化硅沉积工艺中硅损耗的方法	发明	ZL201410109834.6	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1314.	减少互补式金氧半导体影像传感器白像素的方法	发明	ZL201410109814.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1315.	一种优化浅槽隔离刻蚀线宽的方法	发明	ZL201410106820.9	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1316.	一种浅沟槽填充方法	发明	ZL201410106819.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1317.	一种监测低温离子注入的方法	发明	ZL201410106663.1	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1318.	一种防止研磨垫刮伤晶圆的系统	发明	ZL201410106660.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1319.	读取非易失性存储器电流的方法及获取电流分布状态的方法	发明	ZL201410106658.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1320.	一种针对光刻版图接触孔热点的检查方法	发明	ZL201410106641.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得

1321.	一种验证缺陷检测程序灵敏度的方法	发明	ZL201410106633.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1322.	一种稳定 MIM 电容光刻线宽的方法	发明	ZL201410106627.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1323.	一种提高栅氧化层质量的方法	发明	ZL201410106618.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1324.	一种提高 B4-Flash 器件耐久性的方法	发明	ZL201410106616.7	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1325.	一种用于氮掺杂碳化硅薄膜的离线监控方法	发明	ZL201410106607.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1326.	采用电容衬度测试结构检测多晶硅底部桥连缺陷的方法	发明	ZL201410106602.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1327.	一种测试样品的制备方法	发明	ZL201410106589.3	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1328.	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201410106568.1	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1329.	一种用于锁相环电路的锁定检测电路	发明	ZL201410106552.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1330.	对没有重复分界的存储区域进行扫描的方法	发明	ZL201410106540.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得

1331.	一种降低镍管道缺陷的方法	发明	ZL201410106537.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1332.	控制栅极刻蚀方法	发明	ZL201410106533.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1333.	一种降低源漏外延生长缺陷的方法	发明	ZL201410106521.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1334.	一种金属电迁移结构	发明	ZL201410106505.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1335.	一种减少 OPC 修正后验证误报错的方法	发明	ZL201410106502.2	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1336.	探针卡	发明	ZL201410106479.7	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1337.	一种优化等离子体均匀性的压力控制阀门及方法	发明	ZL201410106477.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1338.	离子注入段问题机台的判定方法	发明	ZL201410060668.5	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1339.	芯片分区采集最佳光线偏振信号的缺陷程式建立方法	发明	ZL201410060660.9	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1340.	一种晶圆可接受测试方法	发明	ZL201410060659.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1341.	具有毛刺抑制能力的电流舵型数模转换电路	发明	ZL201410060641.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1342.	用于湿法刻蚀工艺的酸槽	发明	ZL201410060590.7	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得

1343.	采用电容测试结构检测多晶硅栅极刻蚀缺陷的方法	发明	ZL201410060338. 6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1344.	一种检测多晶硅残留的测试结构	发明	ZL201410060317. 4	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1345.	一种 WAT 测试的备份结构及备份方法	发明	ZL201410060309. X	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1346.	采用小窗口图形测试结构检测多晶硅底部桥连缺陷的方法	发明	ZL201410060130. 4	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1347.	一种高压晶体管制备工艺	发明	ZL201410060105. 6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1348.	一种晶圆可接受性测试的探针卡自动更换方法	发明	ZL201410059971. 3	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1349.	采用离子击穿检测多晶硅底部刻蚀不足缺陷的方法	发明	ZL201410059958. 8	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1350.	一种通用型针座及其使用方法	发明	ZL201410059942. 7	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1351.	制备嵌入式锗硅外延前的表面处理方法	发明	ZL201410042486. 5	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1352.	用于激光退火机的监控方法	发明	ZL201410042474. 2	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得

1353.	改善工艺窗口的光学临近修正方法	发明	ZL201410042455. X	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1354.	自动扩展缺陷图形库的方法	发明	ZL201410042444. 1	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1355.	一种制备空气间隙铜互连结构的方法	发明	ZL201310637734. 6	2013-12-02	申请日起二十年	原始取得
1356.	一种利用高深宽比工艺的器件隔离方法	发明	ZL201310632125. 1	2013-12-02	申请日起二十年	原始取得
1357.	晶圆多次测试数据的整合方法	发明	ZL201310631845. 6	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1358.	多层薄膜层间粘附性能表征及其试样制备方法	发明	ZL201310631772. 0	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1359.	浮栅晶体管阵列及其制备方法	发明	ZL201310631488. 3	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1360.	电流舵数模转换器电流源阵列的版图结构	发明	ZL201310631462. 9	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1361.	通孔或接触孔的形成方法	发明	ZL201310631359. 4	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1362.	双大马士革结构的制造方法	发明	ZL201310631357. 5	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1363.	控制多晶硅栅极关键尺寸的方法	发明	ZL201310630338. 0	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1364.	离子注入角度监控方法	发明	ZL201310630276. 3	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得

1365.	干法工艺稳定性和匹配性的判断方法	发明	ZL201310630263. 6	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1366.	CMOS 器件栅氧化层的制造方法	发明	ZL201310630240. 5	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1367.	双大马士革结构的制造方法	发明	ZL201310630206. 8	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1368.	改善 HDP PSG 工艺的方法及金属沉积前的介电质层制造方法	发明	ZL201310625737. 8	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1369.	基于规则图形过滤的版图设计光刻工艺友善性检查方法	发明	ZL201310625726. X	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1370.	CMOS 感光器件接触孔刻蚀方法及 CMOS 感光器件制造方法	发明	ZL201310625589. X	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1371.	TEM 样品的制作方法及其 TEM 样品	发明	ZL201310625537. 2	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1372.	一种晶圆可接受性测试系统及方法	发明	ZL201310625206. 9	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1373.	一种铝衬垫制备方法	发明	ZL201310625197. 3	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1374.	栅极侧墙图形化的方法	发明	ZL201310616217. 0	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
1375.	一种 WAT 测试头的布置方法	发明	ZL201310612743. X	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得

1376.	一种低介电常数薄膜的紫外线处理方法	发明	ZL201310612730. 2	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
1377.	十字型探针卡	发明	ZL201310565733. 5	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1378.	三维容错性自寻路径交叉开关矩阵设备	发明	ZL201310565679. 4	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1379.	一种浅沟槽隔离结构的形成方法	发明	ZL201310565677. 5	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1380.	一种炉管设备的组批派工系统和方法	发明	ZL201310554674. 1	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1381.	DRC 文件的坐标数据对比方法	发明	ZL201310554644. 0	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1382.	一种软启动电路及包括该软启动电路的 DC-DC 电路	发明	ZL201310554631. 3	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1383.	开关装置及具有该开关装置的多通道耦合选择器	发明	ZL201310554295. 2	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1384.	浅沟槽隔离结构制备方法	发明	ZL201310530767. 0	2013-10-30	申请日起二十年	原始取得
1385.	曝光机文件自动检查系统	发明	ZL201310506771. 3	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1386.	SECS/GEM 消息交换设备和方法	发明	ZL201310505310. 4	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得

1387.	一种形成多层复合式接触孔刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201310505137.8	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1388.	多种类硅化物掩膜层的形成方法	发明	ZL201310505099.6	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1389.	一种 CMOS 图像传感器有源像素的结构及其制造方法	发明	ZL201310495735.1	2013-10-21	申请日起二十年	原始取得
1390.	减小负偏压温度不稳定性的 CMOS 器件制作方法	发明	ZL201310492053.5	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1391.	一种金属硬掩膜层及铜互连结构的制备方法	发明	ZL201310491799.4	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1392.	一种光刻胶填充式金属互连结构及其制造方法	发明	ZL201310491613.5	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1393.	嵌入式锗硅工艺中静态随机存储器及写入冗余度改善方法	发明	ZL201310491611.6	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1394.	一种用于非晶碳沉积工艺中的清洗方法	发明	ZL201310461217.8	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
1395.	一种在芯片失效分析过程中去除层次的方法	发明	ZL201310460450.4	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得

1396.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310449849. 2	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1397.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432459. 4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1398.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432456. 0	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1399.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432448. 6	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1400.	制作栅极线条的方法	发明	ZL201310432435. 9	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1401.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432414. 7	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1402.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432385. 4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1403.	能简化极小线宽栅极线条的制作工艺的栅极线条制作方法	发明	ZL201310432087. 5	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1404.	一种可按照离子注入区域分类的电子束缺陷检测方法	发明	ZL201310432063. X	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1405.	解决氮化硅和镍硅化物界面剥落问题的工艺方法	发明	ZL201310432018. 4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1406.	提高源漏接触和氮化硅薄膜黏附力的方法	发明	ZL201310432014. 6	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得

1407.	一种金属硬掩膜层及铜互连结构的制备方法	发明	ZL201310380002. 3	2013-08-27	申请日起二十年	原始取得
1408.	应用于栅极线尾切割的双重图形成型方法	发明	ZL201310360830. 0	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1409.	栅极 LELE 双重图形成型方法	发明	ZL201310360404. 7	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1410.	基于 DARC 掩膜结构的栅极 LELE 双重图形成型方法	发明	ZL201310360385. 8	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1411.	基于 DARC 掩膜结构的双重图形成型方法	发明	ZL201310360384. 3	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1412.	双深度浅沟道隔离槽的刻蚀工艺	发明	ZL201310354785. 8	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1413.	多晶硅炉管生长厚度监测方法	发明	ZL201310354782. 4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1414.	高压 ESD 器件版图结构以及包含该版图结构的芯片	发明	ZL201310354719. 0	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1415.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354689. 3	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1416.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354686. X	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得

1417.	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201310354616. 4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1418.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354609. 4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1419.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354608. X	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1420.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354606. 0	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1421.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354604. 1	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1422.	接触孔的刻蚀方法	发明	ZL201310354603. 7	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1423.	改善有源区损伤的方法	发明	ZL201310337067. X	2013-08-02	申请日起二十年	原始取得
1424.	SRAM 失配晶体管检测方法	发明	ZL201310317737. 1	2013-07-25	申请日起二十年	原始取得
1425.	用于测试 MIM 电容的半导体结构	发明	ZL201310312455. 2	2013-07-23	申请日起二十年	原始取得
1426.	SONOS 器件中 ONO 结构的制造方法	发明	ZL201310302913. 4	2013-07-18	申请日起二十年	原始取得
1427.	高压 NPN 器件及其版图结构	发明	ZL201310286451. 1	2013-07-09	申请日起二十年	原始取得

1428.	检测通孔蚀刻不足和通孔缺失缺陷的方法	发明	ZL201310286389. 6	2013-07-09	申请日起二十年	原始取得
1429.	改善电容器件击穿电压的方法	发明	ZL201310265059. 9	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1430.	一种可按照工艺晶圆数量负载动态调整的缺陷抽检方法	发明	ZL201310264843. 8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1431.	增强光刻工艺能力的装置及利用该装置进行的光刻工艺	发明	ZL201310264730. 8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1432.	检测多晶硅栅极与接触孔对准度的方法	发明	ZL201310264726. 1	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1433.	双结构接触孔同步刻蚀工艺	发明	ZL201310264711. 5	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1434.	改善栅氧有源区缺陷的方法	发明	ZL201310264408. 5	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1435.	检测接触孔与多晶硅栅极对准度的方法	发明	ZL201310262927. 8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1436.	抗反射涂层填充式超低介电常数之铜互连制造方法	发明	ZL201310262907. 0	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1437.	版图数据的处理方法	发明	ZL201310258304. 3	2013-06-26	申请日起二十年	原始取得
1438.	栅极的形成方法	发明	ZL201310258301. X	2013-06-26	申请日起二十年	原始取得

1439.	测算接触孔与多晶硅栅极对准偏差值的方法	发明	ZL201310256841.4	2013-06-25	申请日起二十年	原始取得
1440.	测算接触孔与多晶硅栅极对准偏差值的方法	发明	ZL201310256206.6	2013-06-25	申请日起二十年	原始取得
1441.	保护浅沟槽隔离区的方法	发明	ZL201310253617.X	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1442.	改善硅片背面金属污染的方法	发明	ZL201310253594.2	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1443.	改善 GP CMOS 器件的电性参数均一性的方法	发明	ZL201310253193.7	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1444.	一种多功能半导体样品夹具	发明	ZL201310253153.2	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1445.	改善半导体器件电性参数的方法	发明	ZL201310253134.X	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1446.	光学临近效应修正方法	发明	ZL201310229404.3	2013-06-08	申请日起二十年	原始取得
1447.	改善半导体器件良率的方法	发明	ZL201310222267.0	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1448.	一种制备铜种子层的方法	发明	ZL201310221366.7	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1449.	改善 CMOS 图像传感器性能的方法	发明	ZL201310221336.6	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1450.	一种快速高效的晶背缺陷识别方法	发明	ZL201310220498.8	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得

1451.	flash 抗编程串扰的优化方法	发明	ZL201310220497.3	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1452.	一种缺陷扫描结果控制制程机台的派工方法	发明	ZL201310220485.0	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1453.	改善半导体器件负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201310220483.1	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1454.	Σ形凹槽的制作方法	发明	ZL201310217267.1	2013-06-03	申请日起二十年	原始取得
1455.	化学气相沉积室的清洁方法	发明	ZL201310213637.4	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1456.	一种提高叠对测量精度的方法	发明	ZL201310213617.7	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1457.	采用双极曝光方式的光刻装置、通光单元及光刻方法	发明	ZL201310211966.5	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1458.	具有环形透光光圈的光刻装置、通光单元及光刻方法	发明	ZL201310211954.2	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1459.	一种磷酸硅玻璃薄膜的等离子体化学气相沉积方法	发明	ZL201310196276.7	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1460.	降低冗余金属耦合电容的通孔优先双大马士革铜互连方法	发明	ZL201310196254.0	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得

1461.	光刻胶的处理方法以及半导体器件的制备方法	发明	ZL201310195621.5	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1462.	降低冗余金属耦合电容的通孔优先双大马士革铜互连方法	发明	ZL201310195572.5	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1463.	双栅氧器件的制造方法	发明	ZL201310177577.5	2013-05-14	申请日起二十年	原始取得
1464.	膜厚量测机台中颗粒的监控方法及控片	发明	ZL201310166041.3	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1465.	CMOS 带隙基准源电路	发明	ZL201310166026.9	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1466.	监控制程稳定性的测试模块和方法	发明	ZL201310165992.9	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1467.	CMOS 电荷泵电路	发明	ZL201310165971.7	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1468.	TEM 样品的制备方法	发明	ZL201310165226.2	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1469.	提高高压器件浅沟槽隔离性能的方法	发明	ZL201310165188.0	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1470.	一种在 SiGe BiCMOS 工艺中寄生的 PNP 管及其制造方法	发明	ZL201310164260.8	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得

1471.	一种双层浅沟槽隔离结构、制备方法及其横向扩散 MOS 管	发明	ZL201310157307.8	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1472.	晶体管及其沟道长度的形成方法	发明	ZL201310157253.5	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1473.	一种控制晶圆温度的等离子体刻蚀腔室及其方法	发明	ZL201310157252.0	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1474.	Σ形凹槽的制作方法	发明	ZL201310156183.1	2013-04-28	申请日起二十年	原始取得
1475.	半导体芯片的版图图层设计方法及其掩模板	发明	ZL201310153678.9	2013-04-28	申请日起二十年	原始取得
1476.	半导体器件的制造方法	发明	ZL201310122105.X	2013-04-09	申请日起二十年	原始取得
1477.	一种制备栅极氧化层的方法	发明	ZL201310120029.9	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1478.	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201310119905.6	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1479.	一种形成超浅结面的方法	发明	ZL201310119895.6	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1480.	一种栅氧化层的制备方法	发明	ZL201310085199.8	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1481.	金属沟槽的刻蚀方法	发明	ZL201310085181.8	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1482.	实现浅沟道隔离的工艺方法	发明	ZL201310085158.9	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1483.	金属硬质掩模结构的修复方法	发明	ZL201310084505.6	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1484.	一种 Σ 型硅沟槽的制造方法	发明	ZL201310082117.4	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得

1485.	TEM 样品的制备方法	发明	ZL201310082083.9	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1486.	掩膜版的自动化管理系统及方法	发明	ZL201310082060.8	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1487.	检测研磨工艺负载效应的方法	发明	ZL201310082029.4	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1488.	一种形成硅化物阻挡层的方法	发明	ZL201310081989.9	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1489.	一种 U 型沟槽的制造方法	发明	ZL201310081961.5	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1490.	一种二氧化硅金属阻挡层的淀积方法	发明	ZL201310081930.X	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1491.	一组应用于双大马士革金属互连工艺的光掩模	发明	ZL201310081912.1	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1492.	提高 PMOS 栅氧负偏压温度不稳定性方法	发明	ZL201310081898.5	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1493.	去除 BPSG 薄膜中散射状颗粒的方法	发明	ZL201310081872.0	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1494.	涂布装置及其涂布方法	发明	ZL201310062544.6	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得
1495.	实现浅沟槽隔离的工艺方法	发明	ZL201310062525.3	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得
1496.	互连电迁移的测试结构	发明	ZL201310062231.0	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得

1497.	一种氧化反应炉及利用该反应炉进行氧化反应的方法	发明	ZL201310055077.4	2013-02-20	申请日起二十年	原始取得
1498.	一种侦测硅片平坦度的装置及方法	发明	ZL201210501282.4	2012-11-30	申请日起二十年	原始取得
1499.	优化浅槽隔离刻蚀工艺的方法	发明	ZL201210501020.8	2012-11-29	申请日起二十年	原始取得
1500.	浅沟槽隔离之边角圆化的方法	发明	ZL201210496571.X	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1501.	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210496254.8	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1502.	湿法刻蚀装置及其刻蚀方法	发明	ZL201210496197.3	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1503.	一种研磨垫及利用该研磨垫进行研磨时的损耗检测方法	发明	ZL201210493978.7	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1504.	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210451889.6	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1505.	双应力薄膜的制造方法以及半导体器件	发明	ZL201210451699.4	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1506.	接触孔的制作方法	发明	ZL201210451655.1	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1507.	接触孔的制作方法	发明	ZL201210451318.2	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1508.	一种 B4-flash 器件及其制作方法	发明	ZL201210432508.X	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得

1509.	一种监控设备运行状态的系统及方法	发明	ZL201210432475.9	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1510.	一种铜互联线的制作工艺	发明	ZL201210432401.5	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1511.	一种磁阻存储器的环状存储单元的制作方法	发明	ZL201210432398.7	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1512.	一种检测半导体圆形接触孔圆度的方法	发明	ZL201210432250.3	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1513.	一种介电常数可调整的金属互连层及其制作方法	发明	ZL201210432249.0	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1514.	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210389028.X	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1515.	检测光刻机对图形模糊成像控制能力的方法	发明	ZL201210389026.0	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1516.	机台传送部件自清洗方法以及机台传送部件	发明	ZL201210388933.3	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1517.	通孔优先铜互连制作方法	发明	ZL201210388834.5	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1518.	多晶硅栅极刻蚀方法	发明	ZL201210388740.8	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1519.	一种提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210380938.1	2012-10-09	申请日起二十年	原始取得

1520.	提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210380920. 1	2012-10-09	申请日起二十年	原始取得
1521.	一种形成双深度隔离沟槽的方法	发明	ZL201210375753. 1	2012-10-08	申请日起二十年	原始取得
1522.	一种简化存储器中字线介电质膜刻蚀成型工艺的方法	发明	ZL201210375725. X	2012-10-08	申请日起二十年	原始取得
1523.	炉管挡片结构制造方法	发明	ZL201210352952. 0	2012-09-19	申请日起二十年	原始取得
1524.	一种增大 MOM 电容密度的制造工艺方法	发明	ZL201210345797. X	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1525.	一种形成磁阻存储器环状存储单元的方法	发明	ZL201210343578. 8	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1526.	一种具有多孔结构的双大马士革结构	发明	ZL201210343547. 2	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1527.	一种对 40/45 纳米工艺金属硬光罩结构的缺陷解决方案	发明	ZL201210343527. 5	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1528.	改善掺杂与非掺杂多晶硅栅极刻蚀形貌差异的方法	发明	ZL201210343505. 9	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1529.	一种对 40/45 纳米工艺金属硬光罩结构的缺陷解决方案	发明	ZL201210343463. 9	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得

1530.	一种带有空气间隙的大马士革工艺	发明	ZL201210341832.0	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1531.	一种提高 Cu CMP 效率的方法	发明	ZL201210341662.6	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1532.	一种制备顶层金属互联工艺刻蚀中间停止层的方法	发明	ZL201210341630.6	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1533.	双大马士革结构中底部抗反射涂层的刻蚀方法	发明	ZL201210335545.9	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1534.	提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210335529.X	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1535.	一种铜互联线的制作工艺	发明	ZL201210333872.0	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1536.	一种双位 NROM 存储器及提高其电子注入效率的方法和结构	发明	ZL201210333706.0	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1537.	提高通孔图形性能表现的方法	发明	ZL201210293369.7	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1538.	改善刻蚀形貌并提升可靠性的铜互连制备方法	发明	ZL201210292646.2	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1539.	半导体器件的制造方法	发明	ZL201210292632.0	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1540.	改善可靠性的铜互连层制备方法 及半导体器件	发明	ZL201210292621.2	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得

1541.	通孔优先铜互连制作方法	发明	ZL201210264541. 6	2012-07-27	申请日起二十年	原始取得
1542.	一种消除侧墙宽度负载效应的工艺	发明	ZL201210259241. 9	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1543.	一种有效判定铜扩散阻挡层阻挡能力的方法	发明	ZL201210259216. 0	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1544.	一种形成无负载效应大尺寸沟槽的方法	发明	ZL201210259010. 8	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1545.	CMOS 图像传感器及其制作方法	发明	ZL201210229018. X	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1546.	一种具有低操作电压的 NROM 结构器件	发明	ZL201210228272. 8	2012-07-04	申请日起二十年	原始取得
1547.	一种利用非对称分层势垒提高 SONNS 结构器件可靠性的方法	发明	ZL201210225804. 2	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1548.	一种浅沟槽隔离工艺研磨装置及其使用方法	发明	ZL201210225801. 9	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1549.	一种去除晶圆上 SiGe 薄膜的方法	发明	ZL201210225796. 1	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得

1550.	一种具有低操作电压的 SONOS 结构器件	发明	ZL201210225786. 8	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1551.	测算半导体器件井区注入离子横向扩散能力的方法	发明	ZL201210225784. 9	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1552.	超低介电材料的化学机械抛光方法	发明	ZL201210220362. 2	2012-06-28	申请日起二十年	原始取得
1553.	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210209049. 9	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1554.	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210209048. 4	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1555.	金属硬掩膜层制备方法以及半导体制造方法	发明	ZL201210208994. 7	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1556.	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210208991. 3	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1557.	使用应力记忆技术的半导体器件制造方法	发明	ZL201210208961. 2	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1558.	双应力氮化硅蚀刻阻挡层形成方法和半导体器件制造方法	发明	ZL201210208909. 7	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1559.	使用应力记忆技术的半导体器件制造方法	发明	ZL201210208906. 3	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得

1560.	一种形成厚度均匀二氧化硅侧墙的方法	发明	ZL201210204506.5	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1561.	一种检测接触孔和多晶硅栅极对准度的方法	发明	ZL201210204463.0	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1562.	一种具有低编程电压捕获电荷的 BE-SONOS 结构器件及形成方法	发明	ZL201210204452.2	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1563.	一种短沟道围栅结构 MOSFET 的阈值电压解析模型	发明	ZL201210204444.8	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1564.	SONOS 栅极结构及其制备方法、以及半导体器件	发明	ZL201210170390.8	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1565.	提高载流子迁移率的 PMOS 器件的制作方法及其器件结构	发明	ZL201210170354.1	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1566.	一次性可编程器件以及集成电路	发明	ZL201210169827.6	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1567.	利用应力技术提高 SONOS 结构器件编程速度的方法	发明	ZL201210169810.0	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1568.	提高载流子迁移率的 CMOS 器件的制作方法及其器件结构	发明	ZL201210169809.8	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得

1569.	一次性可编程器件以及集成电路	发明	ZL201210169500.9	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1570.	降低 N 型掺杂和非掺杂多晶硅栅极刻蚀后形貌差异的方法	发明	ZL201210163138.4	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1571.	一种具有低操作电压的 BE-SONOS 结构器件及形成方法	发明	ZL201210158901.4	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1572.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210158843.5	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1573.	一种形成半导体通孔的方法	发明	ZL201210158835.0	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1574.	一种形成双应力刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201210158828.0	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1575.	一种形成双应力刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201210158826.1	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1576.	一种用于 45 纳米及以下技术节点的金属前介质集成工艺	发明	ZL201210136032.5	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1577.	一种离子注入阻挡层的制作方法	发明	ZL201210136017.0	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1578.	一种提高金属-绝缘体-金属电容器可靠性的方法及其工艺结构	发明	ZL201210136004.3	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得

1579.	一种提高金属-绝缘体-金属电容器介电质质量的方法	发明	ZL201210135983.0	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1580.	一种用于 45 纳米及以下技术节点的金属前介质集成工艺	发明	ZL201210135982.6	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1581.	基于 SOI 的后栅型积累模式 Si-NWFET 制备方法	发明	ZL201210135272.3	2012-05-03	申请日起二十年	原始取得
1582.	SOI 上双层隔离混合晶向后栅型反型模式 SiNWFET 的制备方法	发明	ZL201210133935.8	2012-05-03	申请日起二十年	原始取得
1583.	多层金属-氧化硅-金属电容器的制作方法	发明	ZL201210116158.6	2012-04-20	申请日起二十年	原始取得
1584.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210114142.1	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1585.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210114141.7	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1586.	连接孔的形成方法	发明	ZL201210114135.1	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1587.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210113716.3	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得

1588.	多层金属-多层绝缘体-金属电容器的制作方法	发明	ZL201210109591.7	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1589.	一种成型无定形碳牺牲栅极的基体的制备方法	发明	ZL201210109584.7	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1590.	一种无定形碳牺牲栅极结构的浅结和侧墙的制备方法	发明	ZL201210109582.8	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1591.	一种防止磷硅酸盐玻璃或硼磷硅酸盐玻璃薄膜吸水的方法	发明	ZL201210100763.4	2012-04-09	申请日起二十年	原始取得
1592.	一种制备无定形碳牺牲栅极结构的浅结和侧墙的方法	发明	ZL201210098261.2	2012-04-06	申请日起二十年	原始取得
1593.	一种埋入式可编程闪存器件及其控制方法	发明	ZL201210098232.6	2012-04-06	申请日起二十年	原始取得
1594.	提高静态随机存储器写入冗余度的方法	发明	ZL201210093940.0	2012-03-31	申请日起二十年	原始取得
1595.	基于体硅的纵向堆叠式后栅型SiNWFET制备方法	发明	ZL201210093913.3	2012-03-31	申请日起二十年	原始取得

1596.	金属-多层绝缘体-金属电容器及其制造方法、集成电路	发明	ZL201210081402. X	2012-03-23	申请日起二十年	原始取得
1597.	金属-多层绝缘体-金属电容器及其制造方法、集成电路	发明	ZL201210081401. 5	2012-03-23	申请日起二十年	原始取得
1598.	一种表征多层栅极中多晶硅电阻的方法	发明	ZL201210077724. 7	2012-03-22	申请日起二十年	原始取得
1599.	一种形成双应力刻蚀阻挡层及前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064639. 7	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1600.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064629. 3	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1601.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064628. 9	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1602.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064615. 1	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1603.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064614. 7	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1604.	双层隔离纵向堆叠式半导体纳米线 MOSFET	发明	ZL201210050780. 1	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1605.	一种用于铜互连冗余金属图形的插入算法	发明	ZL201210049162. 5	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得

1606.	一种超低介电常数薄膜生长中形成渐进二氧化硅层的方法	发明	ZL201210047381. X	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1607.	一种利用应变硅技术提高 SONOS 的擦写速度的方法	发明	ZL201210047380. 5	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1608.	一种增加浅沟槽隔离压应力提高 NMOS 电子迁移率的方法	发明	ZL201210047378. 8	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1609.	一种用于栅极侧墙的二氧化硅薄膜的沉积方法	发明	ZL201210046161. 5	2012-02-27	申请日起二十年	原始取得
1610.	一种宽频带锁相环频率综合器电路	发明	ZL201210016167. 8	2012-01-18	申请日起二十年	原始取得
1611.	一种栅极图形尺寸收缩方法	发明	ZL201210014989. 2	2012-01-18	申请日起二十年	原始取得
1612.	SONOS 结构制造方法以及 SONOS 结构	发明	ZL201210009215. 0	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得
1613.	双位氮化硅只读存储器制造方法及双位氮化硅只读存储器	发明	ZL201210009093. 5	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得
1614.	改善高密度等离子体化学气相沉积的磷硅玻璃形貌的方法	发明	ZL201210009089. 9	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得

1615.	一种形成高阶电常数 K 和 T 型金属栅极的形成方法	发明	ZL201110393469. 2	2011-12-02	申请日起二十年	原始取得
1616.	用于等离子体刻蚀的先进工艺控制方法	发明	ZL201110392794. 7	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1617.	一种相位移焦距检测光罩及制造方法及检测焦距差的方法	发明	ZL201110392792. 8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1618.	一种低介电常数阻挡层工艺中的预处理的监控方法及装置	发明	ZL201110392783. 9	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1619.	一种金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110392608. X	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1620.	金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110392607. 5	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1621.	一种多层金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110391743. 2	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1622.	一种多层金属-氧化硅-金属电容的制作方法	发明	ZL201110391732. 4	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得

1623.	用于等离子体刻蚀结构的光学探测方法及计算机辅助系统	发明	ZL201110391728. 8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1624.	一种光刻机曝光方法	发明	ZL201110391163. 3	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1625.	CMOS 半导体器件及其制造方法	发明	ZL201110389208. 3	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1626.	可降低方块电阻的铜互连结构的制造方法	发明	ZL201110388945. 1	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1627.	应力记忆作用的半导体器件及其制造方法	发明	ZL201110388942. 8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1628.	PMOS 源漏区离子注入方法及相应的器件制造方法	发明	ZL201110388784. 6	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1629.	可降低方块电阻的铜互连结构的制造方法	发明	ZL201110388783. 1	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1630.	一种形成厚金属的单大马士革方法	发明	ZL201110388371. 8	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1631.	一种双镶嵌结构的形成方法	发明	ZL201110386916. 1	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1632.	一种提高金属绝缘层金属电容层多次光刻重复性的方法	发明	ZL201110386908. 7	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得

1633.	一种降低铜互连方块电阻的单大马士革方法	发明	ZL201110386892. X	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1634.	一种形成高介电常数 K 和 T 型金属栅极的形成方法	发明	ZL201110386890. 0	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1635.	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386297. 6	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1636.	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386296. 1	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1637.	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386112. 1	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1638.	扫描电子显微镜的检测方法	发明	ZL201110386090. 9	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1639.	一种降低铜互连方块电阻的全光阻双大马士革方法	发明	ZL201110385563. 3	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1640.	一种利用上掩膜实现铜互连的方法	发明	ZL201110384049. 8	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1641.	一种半导体制程中的偏移管理的良率提升系统	发明	ZL201110384048. 3	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得

1642.	一种利用上掩膜实现高性能铜互连的方法	发明	ZL201110384046.4	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1643.	一种半导体制程中的设备监控方法	发明	ZL201110384000.2	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1644.	钨生长控制设备及方法	发明	ZL201110379861.1	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1645.	提高空穴迁移率的方法以及半导体器件制造方法	发明	ZL201110379854.1	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1646.	通孔刻蚀方法、集成电路制造方法和集成电路	发明	ZL201110379853.7	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1647.	铜填充硅通孔的制作方法	发明	ZL201110379852.2	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1648.	具有空气侧墙的 CMOS 制作方法	发明	ZL201110379535.0	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1649.	光刻机投影物镜温度均衡装置及均衡方法	发明	ZL201110374963.4	2011-11-22	申请日起二十年	原始取得
1650.	提高浮体效应存储单元写入速度的方法及半导体器件	发明	ZL201110366206.2	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得
1651.	提高浮体效应存储单元写入速度的方法及半导体器件	发明	ZL201110366188.8	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得

1652.	接触孔刻蚀方法、集成电路制造方法以及集成电路	发明	ZL201110366186.9	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得
1653.	一种多层金属-氮化硅-金属电容的制造方法	发明	ZL201110361155.4	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1654.	一种金属-氮化硅-金属电容的制造方法	发明	ZL201110361154.X	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1655.	一种多层金属-氮化硅-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110361149.9	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1656.	一种导电聚合物凝胶填充硅通孔的方法	发明	ZL201110359862.X	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1657.	一种利用上掩膜实现高性能铜互连的方法	发明	ZL201110359760.8	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1658.	一种存储器单元的制备方法	发明	ZL201110349900.3	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得
1659.	用 DPN 氮氧化硅作为 SONOS 存储介质层的 ONO 结构及其制备方法	发明	ZL201110349894.1	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得
1660.	形成绝缘体上碳硅-锗硅异质结 1T--DRAM 结构的方法及形成结构	发明	ZL201110349874.4	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得

1661.	一种低应力金属硬掩膜层的制备方法	发明	ZL201110347738.1	2011-11-07	申请日起二十年	原始取得
1662.	提高浮体效应存储单元写入速度的方法	发明	ZL201110341117.2	2011-11-02	申请日起二十年	原始取得
1663.	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201110341116.8	2011-11-02	申请日起二十年	原始取得
1664.	半导体器件制作方法	发明	ZL201110335363.7	2011-10-29	申请日起二十年	原始取得
1665.	硅纳米线器件的制作方法	发明	ZL201110328162.4	2011-10-25	申请日起二十年	原始取得
1666.	保留部分无定形碳层的方法	发明	ZL201110328160.5	2011-10-25	申请日起二十年	原始取得
1667.	高速电流模式逻辑到互补金属氧化物半导体信号转换电路	发明	ZL201110322330.9	2011-10-21	申请日起二十年	原始取得
1668.	一种形成侧墙的方法及由该方法形成存储单元	发明	ZL201110322309.9	2011-10-21	申请日起二十年	原始取得
1669.	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其形成方法	发明	ZL201110314347.X	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1670.	提高写入速度的浮体动态随机存储器单元及其制作方法	发明	ZL201110314346.5	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得

1671.	提高写入速度的浮体动态随机存储器单元及其制作方法	发明	ZL201110314344. 6	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1672.	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其制备方法	发明	ZL201110314331. 9	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1673.	一种提高写入速度的浮体动态随机存储器单元的制作方法	发明	ZL201110314327. 2	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1674.	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其制备方法	发明	ZL201110314325. 3	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1675.	超低介电常数薄膜铜互连的制作方法	发明	ZL201110310575. X	2011-10-13	申请日起二十年	原始取得
1676.	一种金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110308004. 2	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1677.	一种高性能金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110308002. 3	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1678.	一种金属-氧化物-金属电容	发明	ZL201110307989. 7	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1679.	一种金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110307984. 4	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得

1680.	一种降低化学机械抛光后微粒缺陷的方法	发明	ZL201110307983. X	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1681.	一种金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110307976. X	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1682.	铜互连结构的制作方法	发明	ZL201110301126. 9	2011-09-28	申请日起二十年	原始取得
1683.	一种降低双大马士革氮化硅工艺颗粒的处理方法	发明	ZL201110299091. X	2011-09-29	申请日起二十年	原始取得
1684.	一种避免双刻蚀阻挡层引起的接触孔不通的方法	发明	ZL201110298921. 7	2011-09-29	申请日起二十年	原始取得
1685.	一种提高浅沟隔离多次曝光稳定性的方法	发明	ZL201110285100. X	2011-09-23	申请日起二十年	原始取得
1686.	超低介电常数薄膜铜互连的制作方法	发明	ZL201110274496. 8	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1687.	具有金属前介质填充结构的半导体器件及其制备方法	发明	ZL201110274490. 0	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1688.	金属铜大马士革互联结构的制造方法	发明	ZL201110274227. 1	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得

1689.	一种大马士革的集成方法	发明	ZL201110272665.4	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1690.	预防物理气相沉积溅射工艺过程中金属靶材被击穿的方法	发明	ZL201110272663.5	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1691.	一种改进的硬质掩膜与多孔低介电常数材料集成方法	发明	ZL201110266463.9	2011-09-09	申请日起二十年	原始取得
1692.	制备具有多厚度硅化物掩模层的半导体器件的方法	发明	ZL201110266445.0	2011-09-09	申请日起二十年	原始取得
1693.	一种单一厚度栅氧化层实现多级工作电压的CMOS器件的制备方法	发明	ZL201110265327.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1694.	一种提高浮体动态随机存储器单元性能的栅刻蚀方法	发明	ZL201110265311.7	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1695.	一种根据不同衬底进行光学临近修正的方法	发明	ZL201110265304.7	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1696.	一种解决高磷浓度PSG薄膜表面雾状颗粒的工艺方法	发明	ZL201110265302.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得

1697.	一种增加两次图形曝光工艺窗口的方法	发明	ZL201110265283.9	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1698.	一种用于提高半导体器件性能的硅化物掩模刻蚀方法	发明	ZL201110265270.1	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1699.	一种降低碳辅助注入工艺流程中多晶硅栅电阻的方法	发明	ZL201110265267.X	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1700.	一种利用侧向边墙技术提高 STI 凹陷区特性的方法	发明	ZL201110265265.0	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1701.	提高浮体动态随机存储单元写入速度的方法	发明	ZL201110265239.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1702.	一种金属—绝缘层—金属电容结构的制造工艺	发明	ZL201110265234.5	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1703.	一种减小半导体器件热载流子注入损伤的方法	发明	ZL201110265219.0	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1704.	绝缘体上硅硅片及浮体动态随机存储器单元的制造方法	发明	ZL201110256001.9	2011-08-31	申请日起二十年	原始取得

1705.	绝缘体上硅硅片及浮体动态随机存储器单元的制造方法	发明	ZL201110256000.4	2011-08-31	申请日起二十年	原始取得
1706.	一种新的硅化物和金属前介质集成工艺及该形成的结构	发明	ZL201110250281.2	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1707.	一种新型的双 bit 线 SONOS 单元结构及其制作方法	发明	ZL201110250278.0	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1708.	一种提高浮体动态随机存储器单元性能的栅氧预清洗方法	发明	ZL201110250276.1	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1709.	一种 STI 结构 CMP 方法以及 STI 结构制作方法	发明	ZL201110250266.8	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1710.	一种 CMP 机台内置清洗结构及方法	发明	ZL201110250265.3	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1711.	一种简化侧墙定义的两次图形曝光工艺的方法	发明	ZL201110235262.2	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1712.	一种实现两种不同绝缘层厚度电容的集成方法	发明	ZL201110235259.0	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得

1713.	一种减小半导体器件热载流子注入损伤的方法	发明	ZL201110235255. 2	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1714.	一种提高浮体动态随机存储器单元写入速度的注入方法及结构	发明	ZL201110235254. 8	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1715.	一种后栅极两晶体管 DRAM 的制造方法	发明	ZL201110235244. 4	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1716.	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区通孔刻蚀的方法	发明	ZL201110235240. 6	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1717.	一种源漏区超浅结的改进方法	发明	ZL201110235237. 4	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1718.	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区域通孔刻蚀的方法	发明	ZL201110235219. 6	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1719.	后栅极两晶体管零电容动态随机存储器的制备方法	发明	ZL201110232271. 6	2011-08-15	申请日起二十年	原始取得
1720.	增强应力记忆技术效果的方法	发明	ZL201110232262. 7	2011-08-15	申请日起二十年	原始取得
1721.	一种有助于消除倒 U 形镍硅化物的器件结构及其制备工艺	发明	ZL201110222302. X	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得

1722.	一种改善 PMOS 器件载流子迁移率的方法	发明	ZL201110222150.3	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1723.	一种改善 NMOS 器件载流子迁移率的方法	发明	ZL201110222138.2	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1724.	一种利用 P 型离子注入形成双深度隔离沟道的方法	发明	ZL201110222125.5	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1725.	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区通孔刻蚀的方法及其器件	发明	ZL201110222089.2	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1726.	一种不同多晶硅栅电极厚度的集成工艺	发明	ZL201110206448.5	2011-07-22	申请日起二十年	原始取得
1727.	一种提高光刻胶与金属/金属化合物表面之间粘附力的方法	发明	ZL201110206446.6	2011-07-22	申请日起二十年	原始取得
1728.	无金属阻挡层的铜后道互连工艺	发明	ZL201110194242.5	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1729.	用于高、低压器件的多晶硅栅电极集成工艺	发明	ZL201110194223.2	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1730.	一种铜后道互连工艺	发明	ZL201110194154.5	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得

1731.	一种优化的多晶栅极氧化硅硬质掩膜去除方法	发明	ZL201110194153.0	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1732.	MOS 电容器的结构的制作方法	发明	ZL201110194151.1	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1733.	一种提高半导体器件中 MIM 电容密度的方法及其器件	发明	ZL201110194148.X	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1734.	一种增加半导体器件中 MIM 电容密度的方法及其结构	发明	ZL201110194118.9	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1735.	抑制 GIDL 效应的后栅极工艺半导体器件及其制备方法	发明	ZL201110163853.3	2011-06-17	申请日起二十年	原始取得
1736.	一种双晶体管零电容动态 RAM 的制备方法	发明	ZL201110163852.9	2011-06-17	申请日起二十年	原始取得
1737.	一种抑制漏极感应势垒降低效应的后栅极工艺 CMOS 器件及其制备方法	发明	ZL201110160322.9	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1738.	一种抑制漏极感应势垒降低效应的 CMOS 器件及其制备方法	发明	ZL201110160321.4	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得

1739.	一种提高 MIM 器件电容均匀性的方法	发明	ZL201110160311.0	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1740.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110160309.3	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1741.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110160305.5	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1742.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容结构及制造工艺	发明	ZL201110160301.7	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1743.	设置顶部刻蚀阻挡层以增加接触孔刻蚀制程窗口的方法	发明	ZL201110160287.0	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1744.	一种双大马士革工艺中通孔填充的方法	发明	ZL201110150744.8	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1745.	改善双应力氮化硅薄膜集成的工艺及其中的结构	发明	ZL201110150725.5	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1746.	一种用于双刻蚀阻挡层技术的应变硅工艺制作方法	发明	ZL201110150724.0	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得

1747.	一种增强氮化硅薄膜张应力的方法	发明	ZL201110150722.1	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1748.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110150721.7	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1749.	消除栅极凹形缺陷的方法	发明	ZL201110150717.0	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1750.	一种提高铜互连可靠性的表面处理方法	发明	ZL201110150700.5	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1751.	一种 MIM (金属-绝缘层-金属) 电容制作方法	发明	ZL201110150697.7	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1752.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容结构及制造工艺	发明	ZL201110138154.3	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1753.	一种形成 MIM 电容器结构的方法及 MIM 电容器	发明	ZL201110138130.8	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1754.	一种针对氟基等离子体刻蚀后的氮化钛薄膜的处理方法	发明	ZL201110138127.6	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1755.	一种利用铜大马士革工艺制造双层金属-绝缘层-金属电容的方法	发明	ZL201110138065.9	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得

1756.	离子注入调整隔离氧化物应力的浅沟槽隔离结构制备方法	发明	ZL201110133619.6	2011-05-23	申请日起二十年	原始取得
1757.	用于提高半导体器件性能的在浅沟槽上形成接触孔的方法	发明	ZL201110123709.7	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1758.	一种具有自对准空洞层的 SON 互补型金属氧化物半导体制备方法	发明	ZL201110123708.2	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1759.	一种提高 MIM 电容密度的结构及其制作工艺	发明	ZL201110123645.0	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1760.	一种 CMOS 侧墙结构及其制备方法	发明	ZL201110123643.1	2011-07-27	申请日起二十年	原始取得
1761.	一种 MIM 电容的改进结构及其制造工艺	发明	ZL201110123642.7	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1762.	在浅沟槽上形成接触孔以提高半导体器件性能的方法	发明	ZL201110110384.9	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1763.	提高半导体器件中空穴迁移率的方法	发明	ZL201110110382.X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得

1764.	一种提高 PMOS 器件中空穴迁移率的多晶硅栅附加样本填充方法	发明	ZL201110110369. 4	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1765.	一种增强应力记忆效应的栅多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201110110368. X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1766.	一种制造高拉应力氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201110110367. 5	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1767.	一种用于表征低介电常数介质材料损伤的检测方法	发明	ZL201110110175. 4	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1768.	集成电路钝化层及其制造方法	发明	ZL201110110174. X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1769.	一种用于双刻蚀阻挡层技术的应变硅工艺集成方法	发明	ZL201110099265. 8	2011-04-20	申请日起二十年	原始取得
1770.	改进晶体管载流子迁移率的半导体器件及方法	发明	ZL201110078473. X	2011-03-30	申请日起二十年	原始取得
1771.	一种减小半导体器件中交叠电容的方法	发明	ZL201110078449. 6	2011-03-30	申请日起二十年	原始取得
1772.	一种干泵信号接头及 CVD 成膜设备信号接头	实用新型	ZL202421830222. 1	2024-07-30	申请日起十年	原始取得

1773.	定位装置以及蚀刻机	实用新型	ZL202421524674. 7	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1774.	线圈支架、射频匹配电路组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202421520067. 3	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1775.	具有位置偏移检测装置的离子注入机	实用新型	ZL202421520050. 8	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1776.	等离子刻蚀装置	实用新型	ZL202420910871. 6	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1777.	石英管固定结构及反应腔体	实用新型	ZL202420908366. 8	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1778.	立式炉管装置	实用新型	ZL202420907843. 9	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1779.	具有除湿装置的前开式晶圆盒	实用新型	ZL202420907810. 4	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1780.	用于气化装置的进出口管路及其的气化设备	实用新型	ZL202420590490. 4	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1781.	喷嘴支撑臂位置偏移检测装置及旋涂单元和涂胶设备	实用新型	ZL202420590463. 7	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1782.	用于掩膜版存储柜的喷气组件	实用新型	ZL202420392586. X	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1783.	固定装置及其的炉管机台	实用新型	ZL202420390531. 5	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1784.	一种干燥槽顶针	实用新型	ZL202420389435. 9	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1785.	涂料装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420385391. 2	2024-02-29	申请日起十年	原始取得

1786.	用于牵引天车的连接杆结构	实用新型	ZL202420344486. X	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1787.	隔振装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420344063. 8	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1788.	防降温保护装置	实用新型	ZL202420232425. 4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1789.	货物载入台以及测试机台	实用新型	ZL202420232052. 0	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1790.	天车维修系统	实用新型	ZL202420232021. 5	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1791.	检漏装置	实用新型	ZL202420231968. 4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1792.	燃烧式除害设备	实用新型	ZL202420231058. 6	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1793.	辅助上油装置以及测试机台	实用新型	ZL202420143421. 9	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1794.	一种烘烤排气管清洗装置	实用新型	ZL202420141150. 3	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1795.	晶圆刻蚀均匀度提升装置	实用新型	ZL202420141145. 2	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1796.	连接组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202420141126. X	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1797.	清针砂纸粘贴辅助装置	实用新型	ZL202322019571. 7	2023-07-28	申请日起十年	原始取得
1798.	一种信号线和背氮流量控制器的 防干扰结构	实用新型	ZL202321351972. 6	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1799.	安装辅助支架	实用新型	ZL202321349596. 7	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1800.	一种阳极装置及电镀设备	实用新型	ZL202321349565. 1	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1801.	一种支撑架及收纳装置	实用新型	ZL202321251352. 5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得

1802.	一种手动取片机械爪	实用新型	ZL202321251340. 2	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1803.	一种冷却水管路连接装置	实用新型	ZL202321251328. 1	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1804.	接头保护装置和液压快速接头	实用新型	ZL202321247559. 5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1805.	清洁治具及刻蚀机	实用新型	ZL202321247527. 5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1806.	研磨保护装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202321246644. X	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1807.	漏液检测报警装置及刻蚀机	实用新型	ZL202321246628. 0	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1808.	校准治具及量测系统	实用新型	ZL202321246619. 1	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1809.	工艺腔清洁装置	实用新型	ZL202320982876. 5	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1810.	一种快速热处理半导体加工机台 及半导体加工系统	实用新型	ZL202320982859. 1	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1811.	气柜部件清洗保护结构及半导体 设备	实用新型	ZL202320982844. 5	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1812.	一种对石英腔体进行降温的装置	实用新型	ZL202320982818. 2	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1813.	适用于紫外线灯照射台的吸 尘装置	实用新型	ZL202320982746. 1	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1814.	晶圆清洗装置	实用新型	ZL202320704865. 0	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1815.	清洗装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202320698685. 6	2023-03-31	申请日起十年	原始取得

1816.	一种真空吸附式取放装置	实用新型	ZL202320696516.9	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1817.	一种用于晶圆存储盒的承载装置	实用新型	ZL202320695689.9	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1818.	检测设备、工艺腔室及离子注入机	实用新型	ZL202320680210.4	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1819.	一种晶圆存储盒的防坠落装置	实用新型	ZL202320680205.3	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1820.	倾角传感器的保护结构及倾角传感器	实用新型	ZL202320351401.6	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1821.	卡盘销组件及晶圆清洗设备	实用新型	ZL202320348444.9	2023-02-28	申请日起十年	原始取得
1822.	晶圆级半自动探针台	实用新型	ZL202320347595.2	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1823.	一种输送链的承载装置	实用新型	ZL202320347565.1	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1824.	一种半导体设备及反应气体供应装置	实用新型	ZL202320347548.8	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1825.	沉积环装置、静电卡盘装置及高温铝腔	实用新型	ZL202320345982.2	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1826.	一种石英窗保温装置、等离子体反应设备及半导体加工机台	实用新型	ZL202320345925.4	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1827.	臭氧分解装置及其保护结构	实用新型	ZL202320339205.7	2023-02-24	申请日起十年	原始取得

1828.	一种防脱治具和静电吸盘	实用新型	ZL202320339162. 2	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1829.	电容防护装置	实用新型	ZL202320328598. 1	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1830.	一种真空管收集粉尘装置及真空吸附系统	实用新型	ZL202320328408. 6	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1831.	防光罩盒底盘掉落装置及光罩检测设备	实用新型	ZL202320328390. X	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1832.	光罩传送台防尘装置	实用新型	ZL202320320779. X	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1833.	起膜顶针的移动装置	实用新型	ZL202320320743. 1	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1834.	基座装置、溅射腔体及物理气相沉积设备	实用新型	ZL202320320717. 9	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1835.	光刻机温控用储液装置	实用新型	ZL202320171574. X	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1836.	一种更换上部电极的治具	实用新型	ZL202320171532. 6	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1837.	阀门切换检测装置	实用新型	ZL202320163729. 5	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1838.	芯片测试板除霜装置	实用新型	ZL202320163714. 9	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1839.	一种高度测量治具和涂胶显影机	实用新型	ZL202320152873. 9	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1840.	铜电极组装装置及电化学电镀设备	实用新型	ZL202222915186. 6	2022-10-31	申请日起十年	原始取得

1841.	晶圆传送位置检测装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222877144. 8	2022-10-31	申请日起十年	原始取得
1842.	管路装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222876868. 0	2022-10-31	申请日起十年	原始取得
1843.	一种晶圆前开式传送盒的运输装置	实用新型	ZL202222623922. 0	2022-09-30	申请日起十年	原始取得
1844.	漏气检测装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222614300. 1	2022-09-30	申请日起十年	原始取得
1845.	一种半导体设备电气柜的温度监控装置	实用新型	ZL202222601790. 1	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1846.	老化板及芯片老化测试系统	实用新型	ZL202222598976. 6	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1847.	一种光刻机的光罩传送手臂	实用新型	ZL202222598910. 7	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1848.	一种晶圆工作台用偏差矫正机构	实用新型	ZL202222596169. 0	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1849.	贯穿装置	实用新型	ZL202222304331. 7	2022-08-31	申请日起十年	原始取得
1850.	一种探针卡清洁纸辅助夹具	实用新型	ZL202222121460. 2	2022-08-12	申请日起十年	原始取得
1851.	清洗装置	实用新型	ZL202222110611. 4	2022-08-11	申请日起十年	原始取得
1852.	一种排气装置及尾气处理系统	实用新型	ZL202221984746. 7	2022-07-29	申请日起十年	原始取得
1853.	一种药液桶推车	实用新型	ZL202221982328. 4	2022-07-29	申请日起十年	原始取得
1854.	量测机台照明开关监控系统	实用新型	ZL202220927550. 8	2022-04-20	申请日起十年	原始取得

1855.	等离子刻蚀机台	实用新型	ZL202220924713. 7	2022-04-20	申请日起十年	原始取得
1856.	一种粉尘收集装置	实用新型	ZL202220923322. 3	2022-04-20	申请日起十年	原始取得
1857.	一种基座及半导体设备	实用新型	ZL202220421787. 9	2022-02-28	申请日起十年	原始取得
1858.	一种推车柜	实用新型	ZL202220348470. 7	2022-02-21	申请日起十年	原始取得
1859.	机械臂模块	实用新型	ZL202220260638. 9	2022-02-07	申请日起十年	原始取得
1860.	一种臭氧分解装置	实用新型	ZL202220252166. 2	2022-01-28	申请日起十年	原始取得
1861.	一种紫外线照射装置	实用新型	ZL202220250842. 2	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1862.	一种温控装置的加液口盖帽及温控装置的排气系统	实用新型	ZL202220238947. 6	2022-01-28	申请日起十年	原始取得
1863.	一种清洗装置	实用新型	ZL202220229831. 6	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1864.	清洗装置	实用新型	ZL202220228704. 4	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1865.	一种晶圆检测装置及半导体设备	实用新型	ZL202123436186. X	2021-12-30	申请日起十年	原始取得
1866.	一种反应装置及半导体设备	实用新型	ZL202123348685. 3	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1867.	干法刻蚀机台的设备前端模块的颗粒堆积物清理检测系统	实用新型	ZL202123348572. 3	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1868.	一种校准装置及真空传送装置	实用新型	ZL202123348110. 1	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1869.	一种排湿装置、送风管和空调机	实用新型	ZL202123348080. 4	2021-12-28	申请日起十年	原始取得

1870.	一种研磨机台的冷却装置及研磨机台	实用新型	ZL202123347985. X	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1871.	一种清洗设备	实用新型	ZL202123346972. 0	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1872.	一种清洗槽及具有其的清洗机台	实用新型	ZL202123341787. 2	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1873.	一种干式真空泵及半导体设备	实用新型	ZL202122963402. X	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1874.	一种显影设备	实用新型	ZL202122961152. 6	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1875.	一种光刻机的载片台平坦度的检测系统及光刻机	实用新型	ZL202122953910. X	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1876.	一种过热报警装置	实用新型	ZL202122953908. 2	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1877.	一种排风结构及除胶机	实用新型	ZL202122953885. 5	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1878.	一种 DRIE 机台的等离子体约束环用定位锁定结构	实用新型	ZL202122945564. 0	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1879.	一种热电偶及半导体设备	实用新型	ZL202122638508. 2	2021-10-29	申请日起十年	原始取得
1880.	一种监测特气的装置及半导体设备	实用新型	ZL202122388633. 2	2021-09-29	申请日起十年	原始取得
1881.	一种加热器水平调节装置	实用新型	ZL202122377375. 8	2021-09-29	申请日起十年	原始取得
1882.	一种改造后的 LPCVD 反应室	实用新型	ZL202122065570. 7	2021-08-30	申请日起十年	原始取得

1883.	一种 LPCVD 晶舟旋转装置	实用新型	ZL202122065555. 2	2021-08-30	申请日起十年	原始取得
1884.	一种用于 LPCVD 模块的底座及其 LPCVD 模块	实用新型	ZL202122063121. 9	2021-08-30	申请日起十年	原始取得
1885.	一种光刻胶去除机台的晶圆传送 手臂的清洁及干燥机构	实用新型	ZL202121585532. 8	2021-07-13	申请日起十年	原始取得
1886.	一种用于校正遮光板位置精度的 监控光罩	实用新型	ZL202121584306. 8	2021-07-13	申请日起十年	原始取得
1887.	一种用于管道法兰拆装的工具	实用新型	ZL202120651747. 9	2021-03-30	申请日起十年	原始取得
1888.	一种间隙测量仪、反应腔及半导 体设备	实用新型	ZL202120536419. 4	2021-03-15	申请日起十年	原始取得
1889.	晶圆清洗装置	实用新型	ZL202120412470. 4	2021-02-24	申请日起十年	原始取得
1890.	一种气体吹扫管路、反应腔及半 导体设备	实用新型	ZL202120249404. X	2021-01-28	申请日起十年	原始取得
1891.	预热激光光源冷却系统	实用新型	ZL202023245543. X	2020-12-29	申请日起十年	原始取得
1892.	掩模板清洁装置	实用新型	ZL202023242011. 0	2020-12-29	申请日起十年	原始取得
1893.	炉管设备中的晶舟运动机构	实用新型	ZL202023180549. 3	2020-12-25	申请日起十年	原始取得
1894.	半导体冷却装置及半导体机台	实用新型	ZL202023036249. 8	2020-12-16	申请日起十年	原始取得

1895.	半导体传送装置	实用新型	ZL202023020628. 8	2020-12-16	申请日起十年	原始取得
1896.	接口阀及化学气相沉积设备	实用新型	ZL202022479572. 6	2020-10-30	申请日起十年	原始取得
1897.	显影液供应系统	实用新型	ZL202020671981. 3	2020-04-27	申请日起十年	原始取得
1898.	一种排气取样装置及湿法清洗机	实用新型	ZL202020328502. 8	2020-03-16	申请日起十年	原始取得
1899.	气体管路分流装置及干法刻蚀机	实用新型	ZL201922088521. 8	2019-11-27	申请日起十年	原始取得
1900.	一种腔体结构	实用新型	ZL201922081130. 3	2019-11-27	申请日起十年	原始取得
1901.	紫外光固化装置	实用新型	ZL201921603197. 2	2019-09-24	申请日起十年	原始取得
1902.	电极保护装置	实用新型	ZL201921576498. 0	2019-09-20	申请日起十年	原始取得
1903.	一种遮光结构和涂胶显影机	实用新型	ZL201921189178. X	2019-07-25	申请日起十年	原始取得
1904.	预对准装置及晶圆处理系统	实用新型	ZL201920784669. 2	2019-05-28	申请日起十年	原始取得
1905.	一种光罩盒锁定/解锁装置及相应的 光刻机	实用新型	ZL201920613386. 1	2019-04-29	申请日起十年	原始取得
1906.	一种改善白色像素点的隔离结构	实用新型	ZL201920391846. 0	2019-03-26	申请日起十年	原始取得
1907.	一种化学药液混合装置及湿法刻 蚀装置	实用新型	ZL201920391750. 4	2019-03-26	申请日起十年	原始取得
1908.	一种改善 HCD 炉管硅片间均匀性 差异的装置	实用新型	ZL201821904812. 9	2018-11-19	申请日起十年	原始取得

1909.	一种用于监控尼康光刻机底部镜头雾化散光程度的掩膜板	实用新型	ZL201821903870. X	2018-11-19	申请日起十年	原始取得
1910.	一种用于研磨装置的新型研磨头	实用新型	ZL201821675862. 4	2018-10-16	申请日起十年	原始取得
1911.	电镀洗边结构	实用新型	ZL201820975644. 6	2018-06-25	申请日起十年	原始取得
1912.	用于刻蚀设备的新型陶瓷环	实用新型	ZL201820760179. 4	2018-05-22	申请日起十年	原始取得
1913.	化学气相沉淀机台中静电吸盘的拆装夹具	实用新型	ZL201721797367. 6	2017-12-21	申请日起十年	原始取得
1914.	一种高电流离子注入机末端测流器	实用新型	ZL201721682661. 2	2017-12-06	申请日起十年	原始取得
1915.	一种用于改善白像素的 CMOS 图像传感器	实用新型	ZL201721592960. 7	2017-11-24	申请日起十年	原始取得
1916.	一种改善 low-k 薄膜均一性的装置	实用新型	ZL201721252681. 6	2017-09-27	申请日起十年	原始取得
1917.	一种改善氮化硅薄膜膜厚均一性的炉管石英外管	实用新型	ZL201721251982. 7	2017-09-27	申请日起十年	原始取得
1918.	一种加热装置及化学气相沉积设备	实用新型	ZL201720969251. X	2017-08-04	申请日起十年	原始取得

1919.	一种超声波修整盘及化学机械研磨机	实用新型	ZL201720948244.1	2017-08-01	申请日起十年	原始取得
1920.	一种组合式溅射靶材及磁控溅射装置	实用新型	ZL201720931858.9	2017-07-28	申请日起十年	原始取得
1921.	一种侦测电镀洗边异常的装置	实用新型	ZL201621209504.5	2016-11-09	申请日起十年	原始取得
1922.	一种铜电镀机台腔体	实用新型	ZL201621151042.6	2016-10-24	申请日起十年	原始取得
1923.	套准精度量测图形结构	实用新型	ZL201620809339.0	2016-07-29	申请日起十年	原始取得
1924.	一种用于机台 RF 电感线圈的防电弧击伤装置	实用新型	ZL201620807709.7	2016-07-28	申请日起十年	原始取得
1925.	一种化学气相成膜机台	实用新型	ZL201620283550.3	2016-04-07	申请日起十年	原始取得
1926.	一种化学气相沉积工艺设备	实用新型	ZL201520861935.9	2015-10-30	申请日起十年	原始取得
1927.	一种改善晶圆边缘缺陷的装置	实用新型	ZL201520857832.5	2015-10-29	申请日起十年	原始取得
1928.	高密度等离子体机台顶端喷嘴与气体集流器的连接结构	实用新型	ZL201520856143.2	2015-10-29	申请日起十年	原始取得
1929.	一种氧化炉晶舟	实用新型	ZL201520839960.7	2015-10-27	申请日起十年	原始取得
1930.	一种探针台	实用新型	ZL201520828827.1	2015-10-23	申请日起十年	原始取得
1931.	一种恒转矩控制系统	实用新型	ZL201520794773.1	2015-10-14	申请日起十年	原始取得

1932.	一种探针卡	实用新型	ZL201520793943. 4	2015-10-14	申请日起十年	原始取得
1933.	一种机械手臂	实用新型	ZL201520739022. X	2015-09-22	申请日起十年	原始取得

表 2：标的公司拥有的分立后拟保留在其名下的主要境外已授权专利

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
1.	Stack capacitor, a flash memory device and a manufacturing method thereof	发明	美国	US17/872, 534	2022-7-25	申请日起二十年	原始取得
2.	Stack capacitor, a flash memory device and a manufacturing method thereof	发明	美国	US17/213, 885	2021-3-26	申请日起二十年	原始取得
3.	One-time programmable memory and an operation method thereof	发明	美国	US17/206, 631	2021-3-19	申请日起二十年	原始取得
4.	Method for improving HDP filling defects through STI etching process	发明	美国	US17/142, 623	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
5.	Self-aligned two-time forming method capable of preventing sidewalls from being deformed	发明	美国	US17/142, 500	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
6.	Programmable memory	发明	美国	US16/952, 262	2020-11-19	申请日起二十年	原始取得

7.	Reading reference current automatic regulation circuit of non-volatile memory	发明	美国	US16/951,018	2020-11-18	申请日起二十年	原始取得
8.	Method of sub resolution assist feature	发明	美国	US16/702,492	2019-12-3	申请日起二十年	原始取得
9.	Flash with shallow trench in channel region and method for manufacturing the same	发明	美国	US16/854,129	2020-4-21	申请日起二十年	原始取得
10.	Semiconductor structure of split gate flash memory cell and method for manufacturing the same	发明	美国	US16/861,967	2020-4-29	申请日起二十年	原始取得
11.	1.5T SONOS memory structure and manufacturing method	发明	美国	US16/826,554	2020-3-23	申请日起二十年	原始取得
12.	Method of making resistive structure of RRAM	发明	美国	US16/850,993	2020-4-16	申请日起二十年	原始取得
13.	LDO circuit device and overcurrent protection circuit thereof	发明	美国	US16/800,614	2020-2-25	申请日起二十年	受让取得

14.	Oscillator	发明	美国	US16/815,379	2020-3-11	申请日起 二十年	原始取得
15.	Erase-write cycling method of a flash device	发明	美国	US16/830,740	2020-3-26	申请日起 二十年	原始取得
16.	Power Supply Powering-On Structure	发明	美国	US16/822,757	2020-3-18	申请日起 二十年	原始取得
17.	Voltage-controlled oscillator circuit and phase-locked loop circuit	发明	美国	US16/789,550	2020-2-13	申请日起 二十年	原始取得
18.	50%-duty-cycle consecutive integer frequency divider and phase-locked loop circuit	发明	美国	US16/857,617	2020-4-24	申请日起 二十年	原始取得
19.	Classification method for automatically identifying wafer spatial pattern distribution	发明	美国	US16/690,470	2019-11-21	申请日起 二十年	原始取得
20.	Nonvolatile memory device having a memory-transistor gate-electrode provided with a charge-trapping gate-	发明	美国	US16/666,418	2019-10-29	申请日起 二十年	原始取得

	dielectric layer and two sidewall select-transistor gate-electrodes						
21.	Global shutter CMOS image sensor having photosensitive doped region with inhomogeneous potentials	发明	美国	US16/692, 832	2019-11-22	申请日起二十年	原始取得
22.	Method and apparatus for analyzing semiconductor wafer	发明	美国	US16/681, 843	2019-11-13	申请日起二十年	原始取得
23.	Etching method and a semiconductor device	发明	美国	US16/680, 512	2019-11-12	申请日起二十年	原始取得
24.	Method for detecting ultra-small defect on wafer surface	发明	美国	US16/691, 180	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得
25.	Semiconductor device and manufacturing method therefor	发明	美国	US16/384, 966	2019-4-16	申请日起二十年	原始取得
26.	Semiconductor structure and method of manufacturing the same	发明	美国	US16/681, 830	2019-11-13	申请日起二十年	原始取得

27.	Method of ion implantation and an apparatus for the same	发明	美国	US16/566,876	2019-9-11	申请日起二十年	原始取得
28.	Electrostatic protection circuit and a semiconductor structure	发明	美国	US16/566,875	2019-9-11	申请日起二十年	受让取得
29.	Methods and systems for reducing dislocation defects in high concentration epitaxy processes	发明	美国	US16/409,876	2019-5-13	申请日起二十年	原始取得
30.	Method of manufacturing a bipolar transistor with trench structure	发明	美国	US16/427,356	2019-5-31	申请日起二十年	原始取得
31.	Method for measuring interface state density	发明	美国	US13/656,701	2012-10-20	申请日起二十年	原始取得
32.	Structure for critical dimension and overlay measurement	发明	美国	US13/667,363	2012-11-2	申请日起二十年	原始取得
33.	Method of forming Cu interconnects	发明	美国	US13/667,492	2012-11-2	申请日起二十年	原始取得
34.	CML to CMOS conversion circuit	发明	美国	US13/656,700	2012-10-20	申请日起二十年	原始取得

35.	Method for producing silicon nanowire devices	发明	美国	US13/659,907	2012-10-24	申请日起二十年	原始取得
36.	Temperature balancing device of projection objective of lithography machine and method thereof	发明	美国	US13/682,069	2012-11-20	申请日起二十年	原始取得
37.	Method for depositing phosphosilicate glass	发明	美国	US13/728,743	2012-12-27	申请日起二十年	原始取得
38.	Method for monitoring alignment between contact holes and polycrystalline silicon gate	发明	美国	US13/731,294	2012-12-31	申请日起二十年	原始取得
39.	Integration flow for LDD and spacer fabrication on a sacrificial amorphous carbon gate structure	发明	美国	US13/716,990	2012-12-17	申请日起二十年	原始取得
40.	Method for etching polysilicon gate	发明	美国	US13/730,532	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
41.	Method for improving write margins of SRAM cells	发明	美国	US13/721,071	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得

42.	Method of manufacturing a tungsten plug	发明	美国	US13/706,576	2012-12-6	申请日起 二十年	原始取得
43.	Dummy wafer structure and method of forming the same	发明	美国	US13/730,576	2012-12-28	申请日起 二十年	原始取得
44.	Method of forming contact hole	发明	美国	US13/730,486	2012-12-28	申请日起 二十年	原始取得
45.	Phase shift focus monitor reticle, manufacturing method thereof and method for monitoring focus difference	发明	美国	US13/688,407	2012-11-29	申请日起 二十年	原始取得
46.	Fabrication method for improving surface planarity after tungsten chemical mechanical polishing	发明	美国	US13/730,103	2012-12-28	申请日起 二十年	原始取得
47.	Method and structure to improve the erasing speed operation of SONOS memory device having a graded silicon nitride layer	发明	美国	US13/721,078	2012-12-20	申请日起 二十年	原始取得

48.	Method of forming connection holes	发明	美国	US13/721,070	2012-12-20	申请日起 二十年	原始取得
49.	Method for reducing morphological difference between N-doped and undoped polysilicon gates after etching	发明	美国	US13/721,073	2012-12-20	申请日起 二十年	原始取得
50.	Measurement of lateral diffusion of implanted ions in doped well region of semiconductor devices	发明	美国	US13/721,082	2012-12-20	申请日起 二十年	原始取得
51.	Method of dual-depth STI formation	发明	美国	US13/728,190	2012-12-27	申请日起 二十年	原始取得
52.	Method of improving PMOS performance in a contact etch stop layer process	发明	美国	US13/730,169	2012-12-28	申请日起 二十年	原始取得
53.	Method to manufacture trench-first copper interconnection	发明	美国	US13/726,532	2012-12-24	申请日起 二十年	原始取得
54.	Algorithm of Cu interconnect dummy inserting	发明	美国	US13/731,128	2012-12-31	申请日起 二十年	原始取得

55.	Method of depositing the metal barrier layer comprising silicon dioxide	发明	美国	US14/069,570	2013-11-1	申请日起二十年	原始取得
56.	Semiconductor structure with means for testing metal-insulator-metal capacitors	发明	美国	US14/040,741	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
57.	Test module device and a test method for monitoring the stability of processes	发明	美国	US14/080,534	2013-11-14	申请日起二十年	原始取得
58.	Method of manufacturing semiconductor device	发明	美国	US14/103,496	2013-12-11	申请日起二十年	原始取得
59.	Layout pattern modification method	发明	美国	US14/105,689	2013-12-13	申请日起二十年	原始取得
60.	Optical proximity correction method based on hybrid simulation model	发明	美国	US14/086,222	2013-11-21	申请日起二十年	原始取得
61.	Method of detecting and measuring contact alignment shift relative to	发明	美国	US14/040,730	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得

	gate structures in a semiconductor device						
62.	Method of detecting transistors mismatch in a SRAM cell	发明	美国	US14/040,733	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
63.	Method of reducing contamination in CVD chamber	发明	美国	US14/040,739	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
64.	Method of manufacturing dual gate oxide devices	发明	美国	US14/040,737	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
65.	Method of detecting the circular uniformity of the semiconductor circular contact holes	发明	美国	US14/053,750	2013-10-15	申请日起二十年	原始取得
66.	Forming method of an annular storage unit of a magneto-resistive memory	发明	美国	US14/063,398	2013-10-25	申请日起二十年	原始取得
67.	Method of manufacturing the trench of U-shape	发明	美国	US14/070,060	2013-11-1	申请日起二十年	原始取得
68.	Method of forming the gate with the LELE double pattern	发明	美国	US14/085,380	2013-11-20	申请日起二十年	原始取得

69.	CMOS charge pump circuit	发明	美国	US14/091,337	2013-11-26	申请日起 二十年	原始取得
70.	Apparatus for detecting the flatness of wafer and the method thereof	发明	美国	US14/092,056	2013-11-27	申请日起 二十年	原始取得
71.	Method of inspecting misalignment of polysilicon gate	发明	美国	US14/142,584	2013-12-27	申请日起 二十年	原始取得
72.	Methods and systems for using oxidation layers to improve device surface uniformity	发明	美国	US14/590,011	2015-1-6	申请日起 二十年	原始取得
73.	Embedded SiGe epitaxy test pad	发明	美国	US15/937,881	2018-3-28	申请日起 二十年	原始取得
74.	Embedded SiGe epitaxy test pad	发明	美国	US14/691,516	2015-4-20	申请日起 二十年	原始取得
75.	Semiconductor devices with shaped cavities for embedding germanium material and manufacturing processes thereof	发明	美国	US14/691,508	2015-4-20	申请日起 二十年	原始取得

76.	Methods and Systems for Improved Uniformity of SiGe Thickness	发明	美国	US14/691,520	2015-4-20	申请日起二十年	原始取得
77.	Shaped cavity for SiGe filling material	发明	美国	US14/706,986	2015-5-8	申请日起二十年	原始取得
78.	Methods and systems for using conformal filling layers to improve device surface uniformity	发明	美国	US14/720,829	2015-5-24	申请日起二十年	原始取得
79.	Method for forming cobalt barrier layer and metal interconnection process	发明	美国	US14/753,311	2015-6-29	申请日起二十年	原始取得
80.	Floating gate flash memory device and compilation method thereof	发明	美国	US14/753,220	2015-6-29	申请日起二十年	原始取得
81.	Methods and systems for reducing dislocation defects in high concentration epitaxy processes	发明	美国	US14/879,057	2015-10-8	申请日起二十年	原始取得
82.	Method of fabricating semiconductor device and semiconductor device fabricated thereby	发明	美国	US15/235,235	2016-8-12	申请日起二十年	原始取得

83.	Method for establishing mapping relation in STI etch and controlling critical dimension of STI	发明	美国	US15/083,292	2016-3-29	申请日起二十年	原始取得
84.	Method of planarizing polysilicon gate	发明	美国	US15/235,172	2016-8-12	申请日起二十年	原始取得
85.	Method of preparing a plan-view transmission electron microscope sample used in an integrated circuit analysis	发明	美国	US15/241,284	2016-8-19	申请日起二十年	原始取得
86.	Structure for interconnect parasitic extraction	发明	美国	US15/241,108	2016-8-19	申请日起二十年	原始取得
87.	System, method and test layout for detecting leakage current	发明	美国	US15/260,361	2016-9-9	申请日起二十年	原始取得
88.	Simulation method of CMP process	发明	美国	US15/283,286	2016-9-30	申请日起二十年	原始取得
89.	Method for forming shallow trenches of the dual active regions	发明	美国	US15/283,271	2016-9-30	申请日起二十年	原始取得

90.	Photoresist bottle capable of improving poor coating coverage	发明	美国	US15/333,105	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
91.	High pressure low thermal budge high-k post annealing process	发明	美国	US16/057,829	2018-8-8	申请日起二十年	原始取得
92.	SiGe source/drain structure	发明	美国	US16/112,640	2018-8-24	申请日起二十年	原始取得
93.	Method of sub resolution assist feature	发明	美国	US15/822,230	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得
94.	Hotspot correction method	发明	美国	US15/826,705	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
95.	SiGe source/drain structure and preparation method thereof	发明	美国	US15/390,528	2016-12-25	申请日起二十年	原始取得
96.	Method for forming high aspect ratio patterning structure	发明	美国	US15/385,884	2016-12-21	申请日起二十年	原始取得
97.	Method for quickly establishing lithography process condition by a pre-compensation value	发明	美国	US15/800,043	2017-10-31	申请日起二十年	原始取得

98.	Method of etching a shallow trench	发明	美国	US15/389,414	2016-12-22	申请日起 二十年	原始取得
99.	Structure and generation method of clock distribution network	发明	美国	US15/659,577	2017-7-25	申请日起 二十年	原始取得
100.	Method and system for MOM capacitance value control	发明	美国	US15/826,726	2017-11-30	申请日起 二十年	原始取得
101.	Optimization method and system for overlay error compensation	发明	美国	US15/800,071	2017-11-1	申请日起 二十年	原始取得
102.	OPC method for a pattern corner	发明	美国	US15/800,088	2017-11-1	申请日起 二十年	原始取得
103.	OPC method for a shallow ion implanting layer	发明	美国	US15/800,081	2017-11-1	申请日起 二十年	原始取得
104.	Manufacturing method of a flash wafer	发明	美国	US15/822,226	2017-11-27	申请日起 二十年	原始取得
105.	High pressure low thermal budge high-k post annealing process	发明	美国	US15/429,194	2017-2-10	申请日起 二十年	原始取得

106.	Device and method for inrush current control	发明	美国	US15/638,383	2017-6-30	申请日起二十年	原始取得
107.	Transistor with SONOS structure having barrier wall over adjacent portions of the select transistor well and memory transistor well	发明	美国	US15/944,802	2018-4-4	申请日起二十年	原始取得
108.	Bipolar transistor with trench structure	发明	美国	US15/944,801	2018-4-4	申请日起二十年	原始取得
109.	Pixel structure and manufacturing method therefor	发明	美国	US16/203,628	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
110.	Pattern density analysis method	发明	美国	US16/203,624	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
111.	Silicon-controlled rectifier structure and manufacturing method thereof	发明	美国	US16/192,818	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
112.	Manufacturing method of a high performance metal-oxide-metal	发明	美国	US13/339,593	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得

113.	Method for reducing a minimum line width in a spacer-defined double patterning process	发明	美国	US13/339,559	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
114.	Treatment method for reducing particles in dual damascene silicon nitride process	发明	美国	US13/339,400	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
115.	Method of making optical proximity correction to original gate photomask pattern based on different substrate areas	发明	美国	US13/339,411	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
116.	Method for improving capacitance uniformity in a MIM device	发明	美国	US13/339,406	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
117.	Method for decreasing polysilicon gate resistance in a carbon co-implantation process	发明	美国	US13/339,417	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
118.	Global shutter CMOS image sensor and method for making the same	发明	美国	US18/063808	2022-12-9	申请日起二十年	原始取得

119.	Method for locating open circuit failure point of test structure	发明	美国	US17/896336	2022-8-26	申请日起 二十年	原始取得
120.	Semiconductor structure and the manufacturing method thereof	发明	美国	US17/723305	2022-4-18	申请日起 二十年	原始取得
121.	Semiconductor structure of split gate flash memory cell	发明	美国	US17/409146	2021-8-23	申请日起 二十年	原始取得
122.	Method for manufacturing shallow trench isolations	发明	美国	US17/493229	2021-10-4	申请日起 二十年	原始取得
123.	Method for detecting flare degree of lens of exposure machine	发明	美国	US17/492786	2021-10-4	申请日起 二十年	原始取得
124.	Semiconductor device and method for manufacturing the same	发明	美国	US17/389182	2021-7-29	申请日起 二十年	原始取得
125.	Semiconductor device and manufacturing method thereof	发明	美国	US17/388842	2021-7-29	申请日起 二十年	原始取得
126.	Voltage controlled oscillator structure and phase-locked loop	发明	美国	US17/327294	2021-5-21	申请日起 二十年	原始取得

127.	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/240862	2021-4-26	申请日起二十年	原始取得
128.	No-snapback silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/217644	2021-3-30	申请日起二十年	原始取得
129.	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/217517	2021-3-30	申请日起二十年	原始取得
130.	Manufacturing method for a semiconductor device	发明	美国	US17/244620	2021-4-29	申请日起二十年	原始取得
131.	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/234, 633	2021-4-19	申请日起二十年	原始取得
132.	Method for forming doped epitaxial layer of contact image sensor	发明	美国	US17/142431	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
133.	Global shutter CMOS image sensor and method for making the same	发明	美国	US16/951606	2020-11-18	申请日起二十年	原始取得
134.	Semiconductor structure and the manufacturing method thereof	发明	美国	US16/855803	2020-4-22	申请日起二十年	原始取得

135.	Preventive maintenance method for chamber of metal etching machine	发明	美国	US17/958,548	2022-10-3	申请日起二十年	原始取得
136.	Method for manufacturing deep trench isolation grid structure	发明	美国	US17/385,430	2021-7-26	申请日起二十年	原始取得
137.	SONOS memory and method for making the same	发明	美国	US17/352,451	2021-6-21	申请日起二十年	原始取得
138.	Layout structure of eFuse unit	发明	美国	US16/952,288	2020-11-19	申请日起二十年	原始取得
139.	Power-on-reset circuit	发明	美国	US18/231,851	2025-1-28	申请日起二十年	原始取得
140.	Method for Preparing Pixel Cell of CMOS Image Sensor	发明	美国	US17/890,376	2022-8-18	申请日起二十年	原始取得
141.	Method for Measuring Stitching Overlay Accuracy of Image Sensor Stitching Manufacturing	发明	美国	US17/893,425	2022-8-23	申请日起二十年	原始取得
142.	Image Stitching Method for Stitching Product	发明	美国	US17/895,279	2022-8-25	申请日起二十年	原始取得

143.	Method for Automatically Detecting Wafer Backside Brightfield Image Anomaly	发明	美国	US17/941,222	2022-9-9	申请日起二十年	原始取得
144.	Method for purge clean of low pressure furnace	发明	美国	US18/305,983	2023-4-24	申请日起二十年	原始取得
145.	Super Flash and Method for Manufacturing Same	发明	美国	US18/139,530	2023-4-26	申请日起二十年	原始取得
146.	System for Truning Off Power Consumption of Auxiliary Startup Circuit	发明	美国	US18/368,775	2023-9-15	申请日起二十年	原始取得
147.	One Time Programmable Memory Cell	发明	美国	US18/368,691	2023-9-15	申请日起二十年	原始取得
148.	Method for Manufacturing Photomask and Photomask	发明	美国	US17/893,387	2022-8-23	申请日起二十年	原始取得

表 3：标的公司拥有的主要集成电路布图设计专有权

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日
1.	HL55LPPOR06S1V1P0	BS. 165515805	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
2.	HL55LPPOR12D1V1P0	BS. 165515813	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
3.	HL55LPAD12S025D1V1	BS. 165515791	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
4.	AD12S025D1V1_DAC	BS. 165515783	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
5.	HL55LPBGR12D1V1P0 TOP_B	BS. 165515775	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
6.	HL55LPVR100D1V1P0	BS. 165515767	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
7.	HL55LPBGR12D1V1P0 TOP_A	BS. 165515759	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
8.	HL55LPPLL1500S1V1P0_A	BS. 165515732	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
9.	HL55LPPLL1500D1V1P0	BS. 165515740	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
10.	HL55LPLD0100D1V1P0	BS. 165515724	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日

附件二：标的公司报告期内关联交易情况

一. 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
华力集	采购货物	289,556,083.80	278,582,785.84
公司 B	采购货物	5,486,901.00	128,310.00
上海华虹虹日电子有限公司	采购货物	14,318,999.29	38,475,798.67
上海华虹攀芯电子科技有限公司	采购货物	1,008,159.93	1,621,553.57
攀芯电子（上海）有限公司	采购货物	541,987.00	13,562.00
华海清科股份有限公司	采购货物	10,620.46	120,786.15
华力集	接受服务	66,214,382.51	31,562,775.64
公司 B	接受服务	33,311.01	71,904.03

二. 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
-----	--------	---------	---------

华力集	销售货物	206,495,606.97	271,167,801.10
公司 B	销售货物	2,098,652.82	-
攀芯电子（上海）有限公司	销售货物	-	628,432.00
上海复旦微电子集团股份有限公司	销售货物	70,211,820.00	54,346,165.00
华力集	提供服务	16,698,951.01	22,721,820.09
公司 B	提供服务	5,267,828.48	5,678,354.79
攀芯电子（上海）有限公司	提供服务	-	71,798.00
上海复旦微电子集团股份有限公司	提供服务	5,719,318.40	8,008,543.00
公司 B	技术开发	-	471,000,000.00

三. 关联租赁情况

1. 本公司作为出租方

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度确认的租赁收入	2024 年度确认的租赁收入
华力集	房屋及建筑物	561,369.03	571,066.86
公司 B	设备	1,384,633.42	-

2. 本公司作为承租方

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力	房屋及建筑物	99,595,621.28	19,470,211.16	786,033.11

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力	房屋及建筑物	97,846,263.60	23,249,978.04	1,136,643.66

四. 关联方委托贷款

单位：元

委托人	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
华虹集团	-	137,550,000.00	-	137,550,000.00

五. 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
公司 B	融资租出设备	59,292,984.00	-

六. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
关键管理人员薪酬	16,212,816.78	36,527,033.43

七. 其他关联交易

单位：元

交易类型	关联方名称	2025 年度	2024 年度
由关联方代收代付水电物业费等	上海华虹宏力	203,724,693.70	203,582,910.27

八. 关联方应收应付款项

1. 应收账款

单位：元

关联方名称	2025年12月31日	2024年12月31日
华力集	75,067,747.91	33,886,020.36
公司B	374,771.65	1,191,472.39
上海复旦微电子集团股份有限公司	440,146.30	2,997,737.45

2. 其他应收款

单位：元

关联方名称	2025年12月31日	2024年12月31日
华力集	12,240.05	4,174.00

3. 长期应收款（含一年内到期的非流动资产）

单位：元

关联方名称	2025年12月31日	2024年12月31日
-------	-------------	-------------

公司 B	69,457,501.42	-
------	---------------	---

4. 其他非流动资产

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华虹宏力	3,498,229.31	3,876,226.67
华力集	-	51,585,101.89

5. 应付账款

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
华力集	86,965,487.00	85,795,520.74
公司 B	-	128,310.00
上海华虹宏力	46,759,356.11	62,806,966.77
上海华虹虹日电子有限公司	319,712.80	15,474,109.26
上海华虹攀芯电子科技有限公司	212,470.00	476,905.12

挚芯电子（上海）有限公司	334,915.00	13,562.00
华海清科股份有限公司	105.00	2,049.04

6. 其他应付款

单位：元

关联方名称	2025年12月31日	2024年12月31日
华力集	2,151,177.48	7,022,838.92
公司B	1,137.48	33,234.90
上海华虹宏力	5,738,944.95	4,173,815.32

7. 租赁负债（含一年内到期的非流动负债）

单位：元

关联方名称	2025年12月31日	2024年12月31日
上海华虹宏力	391,445,003.95	470,784,380.79